

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის  
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გასილ ალექსის ძე ტაბატაძე

დამხმარე გამომსხივებლების მეთოდის გამოყენება  
შებრუნებული ამოცანებისა და  
ფოტონური კრისტალების კომპიუტერული მოდელირებისთვის  
ხელმძღვანელები:  
რ. ზარიძე  
ფიზ. მათ. მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი  
დ. კაკულია  
ფიზ. მათ. მეცნიერებათა კანდიდატი,  
დოქტორი



2008

## სარჩევი

<b>შესავალი</b>	<b>3</b>
<b>თავი I დამხმარე გამომსხივებლების მეთოდი</b>	
§1.1 დამხმარე გამომსხივებლების მეთოდი და გაბნეული ველის განსაკუთრებულობები.....	7
§1.2 დგმ-ს გამოყენება ველის აღდგენისთვის და გაბნეული ველის განსაკუთრებულობების ვიზუალიზაციისათვის .....	9
§1.3 დამხმარე გამომსხივებლების მეთოდი ფოტონური კრისტალების მოდელირებისას.....	11
§1.4 ფოტოგრაფიული მეთოდი .....	13
§1.5 ჰოლოგრაფიული მეთოდი .....	16
<b>თავი II შებრუნებული ამოცანების ამოხსნა</b>	
ზოგადი მიმოხილვა.....	18
§2.1 მიწის მახასიათებლის აღდგენა .....	20
<b>შებრუნებული ამოცანების ამოხსნა ჰოლოგრაფიული მეთოდის საშუალებით</b>	
§2.2 წყაროთა ველის აღდგენა.....	27
§2.3 სხეულის ზედაპირის აღდგენა.....	30
§2.4 ჩაძირული სხეულის ზედაპირის აღდგენა .....	36
§2.5 სეგმენტზე ველის ინტერპოლაცია .....	40
§2.6 მიწის შთანთქმის უნარიანობის დამოკიდებულება სხეულის ჩაძირვის სიღრმეზე.....	41
<b>შებრუნებული ამოცანების ამოხსნა ფოტოგრაფიული მეთოდის საშუალებით</b>	
§2.7 ლინზის თვისებების გამოკვლევა .....	45
§2.8 სხეულის მდებარეობისა და ზედაპირის განსაზღვრა .....	47
§2.9 კუბის ზედაპირის აღდგენა .....	49
§2.10 საგნის გარჩევისუნარიანობის დამოკიდებულება ლინზიდან მანძილზე..	51
§2.11 ტოროიდის ზედაპირის აღდგენა .....	55
§2.12 ადამიანის ზედაპირის აღდგენა .....	56
§2.13 ჩაძირული სხეულის ზედაპირის აღდგენა .....	57
§2.14 ფოტოგრაფიული და ჰოლოგრაფიული მეთოდების შედარება	
დასკვნა .....	60
<b>თავი III ფოტონური კრისტალების კომპიუტერული მოდელირება</b>	
ზოგადი მიმოხილვა .....	62
პროგრამული პაკეტი .....	64
<b>ელექტრონული მოწყობილობები</b>	
§3.1 წრფივი ტალღამტარი .....	64
§3.2 სიმძლავრის გამყოფი .....	66
§3.3 სისშირული ფილტრი .....	68
§3.4 სიმძლავრეთა შემრევი .....	70
§3.5 ცირკულატორი .....	70
§3.6 ანტენური სტრუქტურები .....	74
§3.7 ინტეგრალური სქემა ფოტონური კრისტალის ბაზაზე .....	79
§3.8 ქარხნული დამზადების სიზუსტის მოდელირება .....	80
დასკვნა .....	81
<b>ლიტერატურა</b>	83

## შესავალი

**ნაშრომის ძირითადი მიზანი.** კომპიუტერული ტექნიკის განვითარებამ ხელი შეუწყო, მათემატიკური ფიზიკის სასაზღვრო ამოცანების ამოსახსნელად, რიცხვითი მეთოდების ინტენსიურ გამოყენებას. ეს გულისხმობს ფიზიკური ამოცანის გაიგივებას მათემატიკურ მოდელთან. რიცხივით ექსპერიმენტს თანამედროვე ელექტროდინამიკაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. გამოკვლევის სპეციფიკა იმაში მდგომარეობს, რომ ეს არ არის ცნობილი ფორმულებით რაიმე მოდელის მახასიათებლების დადგენა ერთჯერადი გამოთვლებით, არამედ რთული გამოთვლების მთელი კასკადია, რომლის პროცესშიც ხდება როგორც მოდელის დაზუსტება, ასევე გათამაშებული ფიზიკური მოვლენის შესწავლა. ამგვარად, შესაძლებელი ხდება ძვირად დირექტული რეალური ექსპერიმენტების ჩანაცვლება კომპიუტერული მოდელირებითა და გამოთვლებით. ამ მიზნით მნიშვნელოვანია, გამოყენებითი ელექტროდინამიკის ამოცანების ამოსახსნელად, ეფექტური რიცხვითი მეთოდების შემუშავება და არსებულის სრულყოფა, რადგან რიცხვითი მეთოდები ამოცანების ამოსენისას გარკვეულ, დიდ სირთულეებს აწყდება. უნივერსალური მიღგომის შექმნა ცალკე პრობლემას წარმოადგენს. გამოკვლევებისთვის შემუშავებული რიცხვითი მეთოდები და ალგორითმები უნდა ხასიათდებოდნენ საკმარისი ეფექტურობით, ხოლო მათი ქმედითუნარიანობა უნდა ჩანდეს როგორც კონკრეტული, ასევე არატრივიალური ამოცანების ამოსენისას.

ნაშრომი შედგება ორი ნაწილისაგან.

პირველ ნაწილში წარმოდგენილია შებრუნებული ამოცანის ამოსენის ორი მეთოდი და თითოეული მეთოდის საშუალებით ხდება შებრუნებული ამოცანის ამოსენა. მათი ძირითად მიზანია სამგანზომილებიან თავისუფალ სივრცეში, ან რაიმე გარემოში, მოთავსებული სხეულის ვიზუალიზაცია, მისი ფორმის, ზომის, მდებარეობისა და ელექტროდინამიკური პარამეტრების განსაზღვრა.

ნაშრომის მეორე ნაწილი შექება ფოტონური კრისტალების კომპიუტერულ მოდელირებას და მისი ძირითადი მიზანია: ორგანზომილებიან სივრცეში რთული შინაგანი სტრუქტურის მქონე ფოტონურ კრისტალებზე ელექტრომაგნიტური ტალღის დიფრაქციის ამოცანის ამოსენა; მათი ელექტროდინამიკური თვისებების გამოკვლევა დაცემული ელექტრომაგნიტური ტალღის კონკრეტული პარამეტრების დროს; რეზონანსული ველების ყოფაქცევის შესწავლა ობიექტის გეომეტრიაში შეტანილი ცვლილებების შემთხვევაში; ფოტონური კრისტალების, როგორც ერთიანი სისტემის, სისტემული მახასიათებლების შესწავლა და რიცხვითი ექსპერიმენტის შედეგების შედარება რეალურ ექსპერიმენტთან.

**თემის აქტუალობა.** თემები, რომელსაც წინამდებარე ნაშრომი ეხება, მეტად აქტუალურია. კერძოთ, შებრუნებული ამოცანის ამოსენა წლების მანძილზე კვლევის მნიშვნელოვან საგანს წარმოადგენდა. ის გამოიყენება ისეთ დარგებში, როგორიცაა არქეოლოგია – მიწაში არსებული ძვირფასი არქეოლოგიური მასალების აღმოჩენა დისტანციურად, რაც თავიდან გვაცილებს მიწის გათხრის მძიმე და ხანგრძლივ პროცესს; სამედიცინო ტომოგრაფიაში ადამიანის შინაგანი ორგანოების გამოკვლევისთვის; აგრეთვე სამხედრო სფეროში მიწაში არსებული ფეთქებადი მასალების დეტექტირებისათვის. ამ ბოლო დროს ეს თემა მეტად აქტუალური გახდა მიწაში გამავალი წყალგამტარი მილების დეფექტური ნაწილების აღმოსაჩენად. ნაშრომის ამ ნაწილზე მუშაობა ხორციელდებოდა საბერძნეთის გრანტის ფარგლებში, რომელიც სწორედ ამ პრობლემას შეეხება.

მეტად აქტუალურია ნაშრომის აგრეთვე შემდეგი ნაწილი, რომელიც შეეხება ფოტონური კრისტალების თვისებების შესწავლას მათი კომპიუტერული მოდელირების საშუალებით. ინფორმაციის ჭარბი ზრდა და მისი სწარაფი გადამუშავების მოთხოვნილება საჭიროებს ულტრაზემაღალ და ოპტიკურ დიაპაზონში მოშუშავე ელექტრონული მოწყობილობების დამზადებას. სიხშირის ზრდის პარალელურად მცირდება მოცემული მოწყობილობების ზომები, რაც მათ დამზადებას საკმაოდ ართულებს. ამ პრობლემის გადაჭრის მიზნით იყენებენ ფოტონურ კრისტალებს, რომელთა დამზადებაც შედარებით მარტივია ზემოთ აღნიშნული დიაპაზონისთვის. თუმცა მათი თვისებების უშუალო შესწავლა დიდ დროსთან და თანხებთან არის დაკავშირებული. ამიტომ მეტად აქტუალური გახდა მათი გამოკვლევა რიცხვითი ექსპერიმენტის საშუალებით, რომელიც გაცილებით სწრაფია და ეკონომიური. წინამდებარე ნაშრომში განხილულია ფოტონური კრისტალების კომპიუტერული მოდელირება დამხმარე გამომსხივებლების მეთოდის საშუალებით. ნაშრომის ამ ნაწილზე მუშაობა ხორციელდებოდა შვეიცარიის გრანტის ფარგლებში.

**ამოცანის ამოხსნის მეთოდიკა.** გასული საუკუნის ორმოციან წლებში ელიფსური ტიპის განტოლებებისთვის სასაზაღვრო ამოცანების ამოხსნა შესწავლილ იქნა იტალიელი მეცნიერების პიკონეს და ამერიოს მიერ. მათი შრომების ძირითადი ლირებულება მდგომარეობდა ასეთი კლასის ამოცანების ამოხსნის ალგორითმების შექმნის შესაძლებლობებში, რომლებშიც ამონახსნი წარმოდგენილია სრული, წრფივად დამოუკიდებელი, არაორთოგონალური ფუნქციათა სისტემით. გაშლის კოეფიციენტები განისაზღვრება სასაზღვრო პირობებიდან.

იმ შემთხვევაში, როდესაც გაშლის ფუნქციები წარმოდგენილია ჰელმოლდცის განტოლების ფუნდამენტური ამონახსნებით, არაორთოგონალური მწკრივების მეთოდს ეწოდება დამხმარე გამომსხივებლების მეთოდი.

**დამხმარე** გამომსხივებლების მეთოდი შემუშავებული იყო ელექტროდინამიკის ამოცანების ფართო კლასის ამოსახსნელად. როგორც გამოცდილება უჩვენებს, მეთოდი აკმაყოფილებს იმ მოთხოვნების უმრავლესობას, რომლებიც ზემოთ იყო ჩამოთვლილი. ეს მეთოდი ეფექტურად იყო გამოყენებული მთელი რიგი ელექტროდინამიკური ამოცანების ამოსახსნელად. გამოყენების პროცესში მეთოდმა შემდგომი განვითარებაც პოვა.

მეთოდის მათემატიკური საფუძვლები ჩაყრილია ქართველი მათემატიკოსების ვაკუპრაძის და ივეკუას მიერ [17-19]. თუმცა არსებობს რიგი შრომებისა, რომელთა ავტორების მიერ დამოუკიდებლად არის შემოთავაზებული გაბნეული ველების მსგავსი წარმოდგენები [21-25]. გარკვეულ პერიოდში მეთოდი განიხილებოდა, როგორც ფიზიკური ამოცანების ამოხსნის მათემატიკური საშუალება და ყურადღება არ ექცეოდა ფიზიკურ თავისებურობებს. დამხმარე გამომსხივებლების მეთოდს იყენებდნენ მათემატიკური ფიზიკის სასაზღვრო ამოცანებში დამხმარე პარამეტრების ოპტიმიზაციის გარეშე. ვაკუპრაძის და ივეკუას შრომებში დამტკიცებულია, რომ ნებისმიერი გამბნევი არეს შიგნით, ჩაკეტილ ზედაპირზე დამხმარე გამომსხივებლების რაოდენობის ზრდით, ამონახსნი მიისწრავის ჭეშმარიტი ამონახსნისკენ. მოგვიანებით, კონკრეტული გამოყენებითი ამოცანების ამოხსნისას გაირკვა, რომ გაბნეული ველის თვისებების გაუთვალისწინებლად წარმოიქნება სერიოზული პრობლემები. მეთოდის კრებადობა და სტაბილურობა დამოკიდებულია დამხმარე პარამეტრების სწორ არჩევაზე. აქ იგულისხმება, რომ დამხმარე ზედაპირი უნდა მოიცავდეს გაბნეული ველის ყველა განსაკუთრებულობას.

**მიღებული შედეგების მართებულობა.** მიღებული შედეგების მართებულობა მოწმდება სხეულის ზედაპირზე სასაზღვრო პირობების შესრულების შემოწმებით, შედეგების ფიზიკური არსის გაანალიზებით. აგრეთვე მცირე ელექტრული ზომების მქონე მარტივ გეომეტრიულ ფიგურებზე განსხვავებული მეთოდით, კერძო შემთხვევებში ანალიზურად მიღებულ შედეგებთან შედარებით.

**სადისერტაციო ნაშრომის მოკლე მიმოხილვა.** წინამდებარე ნაშრომში წარმოდგენილია დამხმარე გამომსხივებლების მეთოდის (დგმ) გამოყენება შებრუნებული ამოცანების კომპიუტერული მოდელირებისას; ამ მეთოდით ფოტონური კრისტალების თვისებების შესწავლა რიცხვითი ექსპერიმენტის საშუალებით.

**ნაშრომი შედეგება სამი თავისაგან:**

პირველ თავში ლაპარაკია: უშუალოდ დამხმარე გამომსხივებლების მეთოდზე ზოგადად; თუ რა სახეზე დაიყვანება ეს მეთოდი კონკრეტული ამოცანების ამოხსნისას; კერძო, შებრუნებული სამგანზომილებიანი და რთული მეტალოდიელექტრიკულ სტრუქტურაზე დიფრაქციის ამოცანების ამოხსნისას.

მეორე თავი ეხება შებრუნებული ამოცანის ამოხსნას ორი ცნობილი, ფოტოგრაფიული და ჰოლოგრაფიული მეთოდის საშუალებით. შესწავლილია კონკრეტული ამოცანა, რომელიც დაკავშირებულია მიწაში ჩაძირული სხეულის ვიზუალიზაციასთან.

მესამე თავში განხილულია ფოტონური კრისტალების გამოყენება ისეთი მოწყობილობების შესაქმნელად, როგორიცაა სიხშირული ფილტრი, სიმძლავრეთა გამყოფი, სიმძლავრეთა შემრევი, ცირკულატორი; აგრეთვე ფაზირებული ანტენის მოდელის შექმნა. წარმოდგენილია რიცხვითი ექსპერიმენტის შედეგები. ნაჩვენებია დგმ-ს ეფექტურობა და გარკვეულ შემთხვევაში მისი აუცილებლობა ასეთი ტიპის ამოცანების ამოხსნისას.

თავი I  
დამხმარე გამომსხივებლების მეთოდი

## §1.1 დამხმარე გამომსხივებლების მეთოდი და გაბნეული ველის განსაკუთრებულობები

დიფრაქციისა და გაბნევის მოვლენების გამოკვლევა, რომელიც შეეხება ორ და სამ განზომილებიან ობიექტებს, მეტად მნიშვნელოვანი თემაა მრავალ პრაქტიკულ ამოცანაში და ამ ბოლო წლებში გამოიწვია საქმაოდ დიდი ინტერესი. ეფექტური რიცხვით მეთოდების შემუშავება წარმოადგენს დიდ პრაქტიკულ ინტერესს.

თანამედროვე ტექნოლოგიების ტექნიკური და ფიზიკური პარამეტრების მიმართ მოთხოვნილებების გაზრდის გამო, ეხლანდელი კომპიუტერული რესურსი, რადგან მექსიერებისა და ცენტრალური პროცესორის შესაძლებლობები დროში შეზღუდულია, შემოსაზღვრავს ისეთი კარგად ცნობილი მეთოდების გამოყენებას, როგორებიცაა: მომენტების მეთოდი, სასრული ელემენტების მეთოდი, სასრული სხვაობები დროით არეში და სხვა.

არსებობს მეთოდები, რომლებიც ეფუძნებიან სხვადასხვა მეთოდების კომბინაციას, რომლებიც ცნობილია როგორც პიბრიდული მეთოდები. ჩვენი ნაშრომი ეხება დამხმარე გამომსხივებლების მეთოდის (დგმ) საშუალებით ორი და სამი განზომილებიანი ამოცანების ამოხსნისას კომპიუტერული რესურსების მინიმიზაციას.

ჩვენ მიერ ქვემოთ მოცემული განხილვა შეიძლება გადატანილ იქნას შებრუნებული ამოცანის ამოხსნისას. დგმ შეიქმნა ელექტროდინამიკის ამოცანების ფართო კლასის გადასაჭრელად და გაუმჯობესდა მრავალი პრაქტიკული ამოცანის ამოსახსნელად. დამხმარე გამომსხივებლების მეთოდის მათემატიკური დასაბუთება მოცემული იყო კუპრაძის მიერ [7]. მეთოდი [7] ტრადიციულად გამოიყენებოდა დგმის საშუალებით მათემატიკური ფიზიკის სასაზღვრო ამოცანების ამოხსნისათვის მისი დამხმარე პარამეტრების ოპტიმიზაციის გარეშე.

[4,5]-ში ნაჩვენები იყო, რომ მოცემულ ალგორითმში მხედველობაში მიიღებოდა გაბნეული ველის განსაკუთრებულობების (გვგ) ყველა ძირითადი ფიზიკური თვისებები. ჩვენ მიერ დადგენილია გაბნეული ველის სტაბილურობა და გვგ. §1.2 წარმოდგენილია დგმ-ზე დაფუძნებული ახალი ალგორითმი, გვგ ლოკალიზაცია და ველის ვიზუალიზაცია – დაფუძნებული გაბნეული ველის ანალიზურ გაგრძელებაზე.

და ბოლოს ორ განზომილებიან ამოცანებში გამოყენებულია ფუნქცია  $H_{\theta}^{(1)}(kr)$ , რომელიც აღწერს განშლად ტალღებს. ხოლო სამ განზომილებიან ამოცანაში ჩვენ მიერ გამოყენებული იქნა ელემენტარული დიპოლის ფუნქცია პირდაპირი ამოცანის ამოსახსნელად; შებრუნებული ამოცანის გადასაწყვეტად კი გამოყენებული იქნა იგივე ფუნქცია, ოღონდ მასში ტალღური ვექტორის მიმართულება შეცვლილი იქნა საწინააღმდეგოთი. ცნობილია, რომ გვგ განაწილებულია როგორც „მნათი წერტილები კაუსტიკური ზედაპირის მახლობლად.“ გვგ-ს ამ განლაგების გამოყენებით, ჩვენ მიერ მიღწეულ იქნა, დიდ ობიექტებზე გაბნევის ამოცანების ეფექტური ამოხსნა გაბნეული ველის ნაწილობრივი წარმოდგენების საშუალებით.

განვიხილოთ ორ განზომილებიანი გაბნევის ამოცანა, რომელიც ნაჩვენებია ნახ. I.1-ზე, სადაც შემომსაზღვრელი ზედაპირი S არის იდეალური გამტარი და ზედაპირის შიგა არე აღნიშნულია D-თი (იგივე განხილვა მცირე შესწორებებით შეიძლება გადატანილ იქნას დიელექტრიკზე დიფრაქციის ამოცანის ამოხსნისას, როგორც ორი ისე სამი განზომილებიანი შემთხვევისთვის) და მოითხოვება

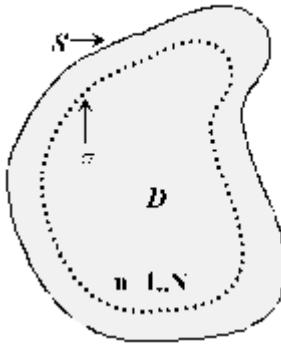
განისაზღვროს ელექტრული  $\vec{E}$  და მაგნიტური  $\vec{H}$  ველები D-ს გარეთ, რომლებიც აკმაყოფილებენ ტალღურ განტოლებას სასაზღვრო S ზედაპირზე, როდესაც გვაქვს დაცემული ტალღა.  $U^i$  ველის დროზე დამოკიდებულება მივიჩნიოთ  $e^{-i\omega t}$  -სახის. გაძნევის ამოცანა დაიყვანება ჰელმიოლცის განტოლების ამონასსნის პოვნაზე:

$$\Delta U^s(x, y, z) + k^2 U^s(x, y, z) = 0 \quad (1)$$

აქ მოითხოვება სასაზღვრო პირობების შესრულება

$$W \left\{ U^s(x, y, z) + U^i(x, y, z) \right\} = 0, M(x, y, z) \in S \quad (2)$$

სადაც  $U^s(x, y, z)$  არის გაბნეული ველი (გვ),  $U^i(x, y, z)$  არის დაცემული ველი W არის სასაზღვრო პირობის ოპერატორი:



ნახ. 1.1 დგმ თრ განზომილებიანი, იდეალურად გამტარი ობიექტის გეომეტრია. დამხმარე წყაროები განთავსებულია თანაბრად  $\sigma$  დამხმარე ზედაპირის გასწვრივ D გამზნევის არაფიზიკური არეს შიგნით. ზედაპირი S არის იდეალურად გამტარი საზღვარი D არესი.

[7]-ს თანახმად, დამხმარე  $\sigma$  ზედაპირი თავსდება D არეს შიგნით; წყაროთა წყება განთავსებული წერტილებში  $\{x_n, y_n, z_n\}_{n=1}^\infty \in \sigma$  არის თანაბრად განაწილებული, როგორც ნახ. 1.1 -ზეა ნაჩვენები.

დავუშვათ  $\{U(|\vec{r}_n - \vec{r}|)\}_{n=1}^\infty$  -არის ჰელმიოლცის განტოლების ამოხსნა დაკავშირებული ელემენტარულ ელექტრომაგნიტური ველის წყაროებთან, რომლითაც გაბნეული ველი (გვ) უნდა იქნას წარმოდგენილი. შესაბამისი ფუნქციები არიან:

$$U(|\vec{r}_n - \vec{r}|) = H_0^{(1)}(k|\vec{r}_n - \vec{r}|) \quad (3) \quad - 2 \text{ განზომილებიანი შემთხვევისთვის;}$$

$$U(|\vec{r}_n - \vec{r}|) = \frac{e^{ik|\vec{r}_n - \vec{r}|}}{|\vec{r}_n - \vec{r}|} \quad (4) - 3 \text{ განზომილებიანი სკალარული შემთხვევისთვის. ხოლო}$$

ვექტორული შემთხვევისთვის გამოიყენება ელემენტარული ელექტრული დიპოლი, რომელზეც ქვემოთ ვიდაპარაკებთ.

დამტკიცებულია რომ [7] :

1. ფუნქციათა ერთობლიობა  $\{U(|\vec{r}_n - \vec{r}|)\}_{n=1}^{\infty}\}$  – ელემენტარული დამხმარე გამომსხვებლები (დგ), რომლებიც აღწერენ ველის ხასიათს (ელექტრული, მაგნიტური ან ველის პოტენციალი) – არიან სრული და წრფივად დამოუკიდებელი S ზედაპირზე  $L_2$ -სივრცეში.
2. არიან ისეთი კოეფიციენტები  $j_n$ , რომ ზემოთაღნიშნული სისტემის პირველი N ფუნქციის გამოყენებით, ნებისმიერი სახის ფუნქცია ზედაპირზე S შეიძლება წარმოდგენილი იქნას ფუნდამენტური ამონასხვების წრფივი კომბინაციით შესაბამისი ამ კოეფიციენტების საშუალებით. იდეალურად გამტარი გამბნევისთვის:

$$W \left\{ \sum_{n=1}^N j_n U(|\vec{r}_n - \vec{r}|) \right\}_S = -W \left\{ U^i(x, y, z) \right\}_S \quad (5)$$

შემდეგ, მიახლოებითი ამონენა სასაზღვრო ამოცანისა D-ს გარეთ არის:

$$\tilde{U}^s(x, y, z) = \sum_{n=1}^N j_n U(|\vec{r}_n - \vec{r}|) \quad (6)$$

რომელიც უახლოვდება ზუსტ ამონასხვას  $U^s(x, y, z)$ , როდესაც  $N \rightarrow \infty$ .

ეს არის არსი კუპრაძის მიერ შემოთავაზებული დგმ-ისა [7].

გამოკვლევებში [4-6] ნაჩვენებია, რომ დამხმარე კონტურის კორექტული შერჩევა და დამხმარე გამომსხვებლების განთავსება, შემოთავაზებული მეთოდის ავალიზაციის მიღწევისთვის მნიშვნელოვანი ფაქტორებია.

ანდა აღინიშნოს, რომ თუ გვგის მდებარეობა კარგად არ შეირჩა, გამოთვლითი პროცესი შეიძლება არ იყოს კრებადი.

აუცილებელი რაოდენობა წევრებისა, რომელიც (5) განტოლებაში უნდა მივიღოთ მხედველობაში, მკაცრად არის დამოუკიდებული დამხმარე კონტურის ფორმაზე და დამხმარე ზედაპირის მდებარეობაზე.

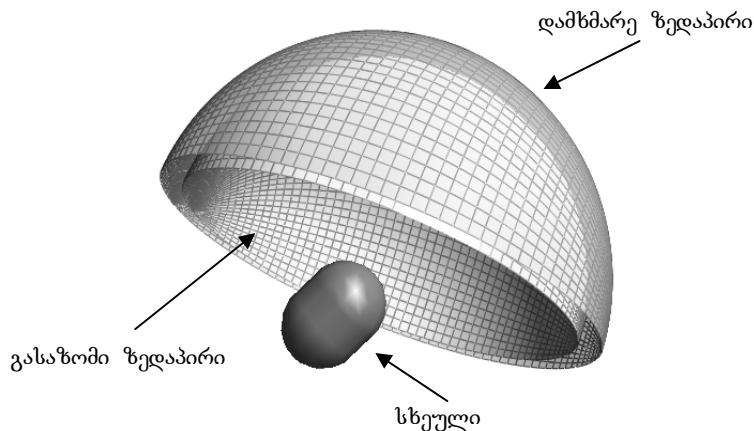
როდესაც დამხმარე კონტურს ვამოძრავებთ შორს ფიზიკური S ზედაპირიდან, წევრების მოთხოვნადი რაოდენობა (5) განტოლებაში, მაღალი სიზუსტის მისაღწევად, მკვეთრად კლებულობს და CPU (ცენტრალური პროცესორი) ამონენის დროც კლებულობს [4-6]. ეს შეიძლება აიხსნას იმ ფაქტით, რომ დამხმარე ზედაპირის წანაცვლება გამბნევი სხეულის შიგნით, ხდის გაბნეული ველის ფუნქციას უფრო გლუვს სხეულის ზედაპირზე და ხდება დაცემული ველის კომპენსაცია კოლორაციის წერტილებში. ე.ი. სასაზღვრო პირობების შესრულება კოლორკაციის წერტილებს შორის უმჯობესდება. თუმცა წყაროთა ძალიან ღრმად მოთავსებამ სხეულის შიგნით, შეიძლება განშლადი ამონასხვი მოგვცეს. ეს ხდება თუ გვგ აღმოჩნდება დამხმარე კონტურის გარეთ: დამხმარე წყაროებით წარმოქმნილი ველი ველარ აღწერს ამ განსაკუთრებულობებს, რადგან გაბნეული ველი ანალიზურია ყველგან დამხმარე კონტურის გარეთ.

## §1.2 დგმ-ს გამოყენება ველის აღდგენისა და გაბნეული ველის განსაკუთრებულობების ვიზუალიზაციისათვის

ცნობილია, რომ გამბნევი სხეულიდან არეკლილი გამრბენი ველი რეგულარულია და ცალსახად განისაზღვრება შესაბამისი წყაროთა განსაკუთრებულობებით, რომლებიც მოთავსებულია გამბნევის შიგნით [1].

შესაბამისად, ველის სიდიდეები რეგულარულ, გაბნეულ ველის არეში და დამატებით ფიზიკური ზედაპირის განსაკუთრებულობების რეგიონის სიახლოვეში, შეიძლება განისაზღვროს მოცემულ არეში მოსახერხებელი ანალიზური ტალღური ფუნქციების საშუალებით.

არსებობს გაბნეული ველის აღდგენისა და ანალიზური გაგრძელების მრავალი მეთოდი. ამ მეთოდთა მათემატიკური დასაბუთება მოცემულია [18,19]-ში. არის აგრეთვე სხვა მეთოდები ველის ვიზუალიზაციის მიმართულებით [20]. ჩვენ მიერ წარმოდგენილი იქნება პოლოგრაფიული მეთოდი, ანუ ველის აღდგენა მეზობელ არეში გარკვეულ ზედაპირზე გაბნეული ველის ამპლიტუდების და ფაზების ცნობილი მონაცემების საშუალებით. განვიხილოთ სამგანზომილებიანი შემთხვევა.



**ნახ.1.2 შებრუნებული ამოცანა  
სამგანზომილებიან შემთხვევაში**

შემოთავაზებული მეთოდი დაფუძნებულია ველის ანალიზურ გაგრძელებაზე, რომელიც ასევე დგმ-ს საშუალებით ითვლება. ჩვენ მიერ ნაშრომში წარმოდგენილია ახალი იდეა ისეთი ფუნქციების გამოყენების შესახებ, რომელიც აღწერს წყაროსევენ მიმართულ კრებად ველს. ასეთი ფუნქციებია ელემენტარული ელექტრული დიპოლის ფუნქცია, რომლის გამოსახულებაშიც ხდება შეცვლა  $k \Rightarrow -k$ , რის შედეგადაც მიიღება კრებადი ტალღა. ამ ფუნქციას აღნიშნავენ  $G(-kr)$ -ით და უწოდებენ გრინის ფუნქციას. განვიხილოთ სხეული (სურ. 1.2) დასხივებული წერტილოვანი წყაროს მიერ.

შემდეგ დაგვშვათ, რომ  $S$  რაიმე ზედაპირზე (გასაზომი ზედაპირი) – ობიექტიდან გარკვეულ მანძილზე, ცნობილია კომპლექსური გაბნეული ველი  $U^s(\vec{r})$  (ამპლიტუდები და ფაზები). ჩვენი მიზანია აღვადგინოთ გვ-ს ანალიზური გაგრძელება ობიექტის მახლობლად, მანამ სანამ ის მიაღწევს განსაკუთრებულ წერტილებს (გაბნეული ველის წყაროებს ან მეორად წყაროებს). როგორც ნახ. 12-ზეა ნაჩვენები, გასაზომი ზედაპირის მახლობლად მდებარე დამსმარე ზედაპირზე მოთავსებულია დამსმარე წყაროები იგივე სისშირის და ნებისმიერი კოეფიციენტებით. ამ დამსმარე გამომსხივებლების შერჩევა მეტად მნიშვნელოვანი საკითხია. მას შემდეგ, რაც დამსმარე გამომსხივებლებს გამოვიყენებოთ კრებადი წყაროების აღსაწერად, გაბნეული ველის ტალღური ვექტორი უნდა იყოს

მიმართული აგრეთვე წყაროებისკენ. ამრიგად, ეს დამხმარე წყაროები არ უნდა ემორჩილებოდნენ გამოსხივების პირობას. პირიქით უნდა იქცეოდნენ როგორც მშთანთქმელები, რომელიც ახდენენ იმ  $U(\vec{r})$  ველის გენერირებას რომელიც მათგან ვრცელდება. მას აქვს შემდეგი სახე:

$$U(\vec{r}) = \sum_{n=1}^N a_n G(-kr_n) \quad (7)$$

მაშასადამე, ეს დამხმარე გამომსხივებლები ცნობილია როგორც დამხმარე მშთანთქმელები (დმ); დროზე დამოკიდებულება მოცემულია  $e^{-iat}$  სახით. შემდეგ ცნობილი გაბნეული ველი გამოისახება დმ-ს ველის მიერ იმ პირობით, რომ გასაზომ ზედაპირზე წერტილთა რაოდენობა  $M \geq N$ . შესაბამისი წრფივ განტოლებათა სისტემა იწერება შემდეგნაირად:

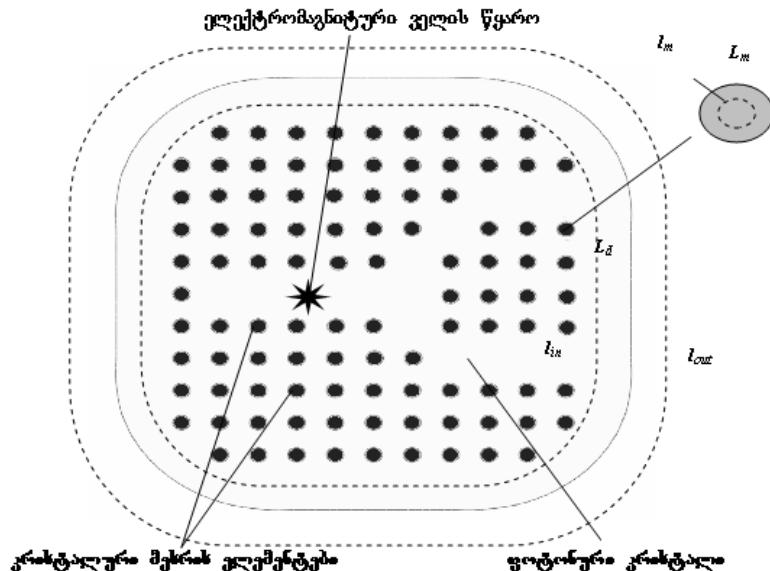
$$\sum_{n=1}^N a_n G(kr_{nm}) = U^s(r_m) \quad (8)$$

ამ სისტემის ამონახსნი განსაზღვრავს დმ-თა ამპლიტუდებს და ფაზებს. გაბნეული ველის ანალიზური გაგრძელების ერთადერთობის გამო, დმ-ები ადადგენენ ველს მთავარ განსაკუთრებულობების წერტილებამდე, ანუ დასასხივებელი სხეულის აკრძალულ არემდე.

### §1.3 დამხმარე გამომსხივებლების მეთოდი ფოტონური კრისტალების მოდელირებისას.

დამხმარე გამომსხივებლების მეთოდი ორ განზომილებიანი რთული შიდა სტრუქტურის მქონე მეტალო-დიელექტრიკული სხეულებისათვის, ანუ ჩვენს შემთხვევაში ფოტონური კრისტალებისათვის, დადის შემდეგ სახეზე:

ფოტონური კრისტალის მოდელად აღვაძული გვაქვს ნებისმიერი ფორმის დიელექტრიკული სხეული, რომელშიც დეფექტების სახით შეტანილია ცილინდრული გამტარები. (ნახ. 1.3) განვიხილოთ ორ განზომილებიანი შემთხვევა, როცა სისტემა  $Z$  ლერძის გასწვრივ ერთგვაროვანია.



ნახ. 1.3  
ფოტონური კრისტალის ფიზიკური მოდელი

კრისტალში ვათავსებოთ ელექტრომაგნიტური გელის წყაროებს, რომელთა განლაგება და რაოდენობა შესაძლებელია წინასწარ ნებისმიერად შეირჩეს. დაცემული გელის მნიშვნელობა  $\tilde{r}$  წერტილში გამოისახება შემდეგი სახით:

$$E^{inc}(\vec{r}) = k \sum_{n=1}^N C_n H_0^{(1)}(k\sqrt{\epsilon\mu}(\vec{r}_n - \vec{r})) \quad (1)$$

სადაც  $k$ -არის ტალღური რიცხვი,  $N$  - კრისტალური მესრის ელემენტების რაოდენობა,  $C_n$  -  $\vec{r}_n$  წერტილში მოთავსებული  $n$ -ურ ელემენტში დენის კომპლექსური ამპლიტუდა,  $\epsilon$  და  $\mu$  - ფოტონური კრისტალის დიელექტრიკული და მაგნიტური შეღწევადობა,  $E^{inc}$  - დაცემული გელი ხოლო  $H_0^{(1)}$  - პანკელის პირველი რიგის ფუნქცია.

ელექტროდინამიკის ამოცანის ამოსახსნელად გამოყენებული იქნა დამხმარე გამომსხივებლების მეთოდი (დგმ), რომლის საშუალებითაც, წინასწარ არჩეული სიზუსტით, აღიწერება მოცემულ ელემენტებში მიმდინარე ტალღური პროცესები.

კრისტალის მიერ გაძნეული გელი წარმოიდგინება უცნობი ამპლიტუდების მქონე დამხმარე გამომსხივებლების საშუალებით, რომლებიც განლაგებული არიან შესაბამისად  $l_{in}, l_{out}, l_m$  დამხმარე კონტურებზე. ფოტონური კრისტალისათვის  $l_{in}$  კონტური მოთავსებულია დიელექტრიკული ზედაპირის შიგნით, და მასზე მოთავსებული გამომსხივებლები აღწერენ ველს კრისტალის გარეთ ოავისუფალ გარემოში.  $l_{out}$  კონტური მოთავსებულია დიელექტრიკული ზედაპირის გარეთ, და აღწერს ველს კრისტალის შიგნით  $l_m$  კონტურზე მოთავსებულ დამხმარე გამომსხივებლებთან ერთად, სადაც  $l_m$  წარმოადგენს ცილინდრული გამტარების - მეტალური მავთულებისათვის დამხმარე კონტურს. ვექტორ-პოტენციალის ფუნქციას  $r_n$  წერტილში მოთავსებული დამხმარე გამომსხივებლისთვის აქვს შემდეგი სახე:

$$\vec{P}(|\vec{r} - \vec{r}_n|) = \vec{i}_z H_0^{(1)}(k\sqrt{\epsilon\mu} |\vec{r} - \vec{r}_n|) \quad (2)$$

ელექტრული ველის მნიშვნელობა კრისტალის გარეთ გამოითვლება შემდეგი ფორმულით:

$$E^{out}(\vec{r}) = k \sum_{n=1}^{N_{in}} a_n^{in} H_0^{(1)}(k(\vec{r}_n - \vec{r})) \quad (3)$$

სადაც  $N_{in}$ -არის დამხმარე გამომსხივებლების რიცხვი  $l_{in}$  კონტურზე,  $a_n^{in}$  მათი ამპლიტუდები.

ელექტრული ველისათვის კრისტალის შიგნით გვაქვს:

$$E^{in}(\vec{r}) = k\epsilon\mu \sum_{n=1}^{N_{out}} a_n^{out} H_0^{(1)}(k\sqrt{\epsilon\mu}(\vec{r}_n - \vec{r})) + \sum_{i=1}^{N_m} b_i^{in} H_0^1(k(\vec{r}_i - \vec{r})) \quad (4)$$

სადაც  $N_{out}$  და  $N_m$ - არის დამხმარე გამომსხივებლების რიცხვი შესაბამისად  $l_{out}$  და  $l_m$  კონტურებზე, ხოლო  $a_n^{out}$  და  $b_i^{in}$  მათი ამპლიტუდები. მაგნიტური ველი როგორც კრისტალის შიგნით, ასევე მის გარეთ, შეიძლება განისაზღვროს მაქსველის განტოლების დახმარებით:

$$rot \vec{E} = -ik\mu \vec{H} \quad (5)$$

უცნობი ამპლიტუდები განისაზღვრება სასაზღვრო პირობებიდან. დიელექტრიკის ზედაპირზე მოითხოვება ელექტრული და მაგნიტური ველის ტანგენციალური მდგენელის უწყვეტობის პირობა, ხოლო მეტალის ზედაპირზე ელექტრული ველის ტანგენციალური მდგენელის ნულთან ტოლობა.

დიელექტრიკის და მეტალის ზედაპირის წერტილებისთვის ამ პირობის დაწერით ვღებულობთ წრფივ ალგებრულ განტოლებათა სისტემას უცნობი  $a_n^{in}$ ,  $a_n^{out}$ ,  $b_i^{in}$  კოეფიციენტებისათვის:

$$\begin{cases} E_\tau^{out}(\vec{r}_i) - E_\tau^{in}(\vec{r}_i) = E_\tau^{inc}(\vec{r}_i) \\ H_\tau^{out}(\vec{r}_i) - H_\tau^{in}(\vec{r}_i) = H_\tau^{inc}(\vec{r}_i), \\ E_\tau^{in}(\vec{r}_j) = E_{inc} \end{cases} \quad (6)$$

მოცემული სისტემის ამოხსნა გვაძლევს დამხმარე გამომსხივებლების ამპლიტუდებს, რომელთა ჩასმით (3) და (4)-ში ვითვლით ველს სივრცის ნებისმიერ წერტილში.

#### §1.4 ფოტოგრაფიული მეთოდი

ფოტოგრაფიული მეთოდი ეყრდნობა დამხმარე გამომსხივებლების მეთოდს და ერთერთი მძლავრი მეთოდია შებრუნებული ამოცანების ამოსახსნელად. მეთოდის არსი მდგომარეობს შემდეგში. სხეულს ეცემა ელექტრომაგნიტური ველი და ხდება ამ ველის არეკვლა მოცემული სხეულიდან. არეკვლილ ველს გზომავთ რადაც არეში. ჰიუგენსის პრინციპის თანახმად ჩვენ შეგვიძლია მოვახდინოთ ველის ანალიზური გაგრძელება თუ თითოეულ წერტილში, რომელშიც ველს გზომავთ, მოვათავსებთ კომბინირებულ დიპოლს იმ ამპლიტუდით და ფაზით, რომელიც გაზომილ ველის მნიშვნელობებს ჰქონდა. მაშინ ჩვენ შევძლებთ ვიპოვოთ ველის შემდგომი სვლა. ამ შემთხვევაში ჩვენ აღვადგენთ ველს ხარისხობრივად და არა რაოდენობრივად. კომბინირებულ დიპოლს აქვს შემდეგი მათემატიკური სახე:

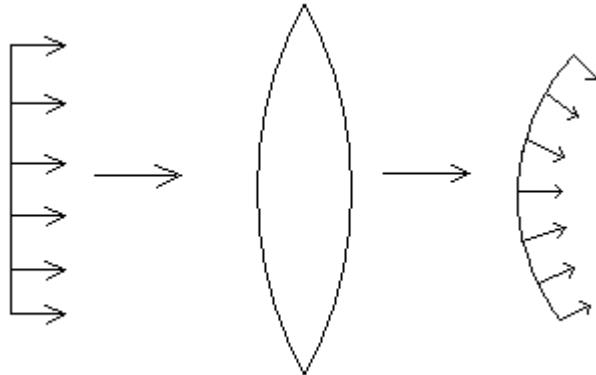
$$E_{el} = \frac{e^{ikr}}{4\pi\epsilon_0 r^3} \{(1-ikr) \cdot (3(\vec{n} \cdot (\vec{n} \cdot \vec{p}) - \vec{p}) - k^2 r^2 [\vec{n}[\vec{n} \cdot \vec{p}]])\}$$

$$E_{mag} = \frac{ikW_0 e^{ikr}}{4\pi\mu_0} \cdot \left( \frac{1}{r^2} - \frac{ik}{r} \right) \cdot [\vec{p} \cdot \vec{n}] \quad E_{komb} = E_{el} + 120\pi \cdot E_{mag}$$

$$k = k_0 \sqrt{\epsilon\mu} \quad \vec{n} = \frac{\vec{r}}{r}$$

ამასთან

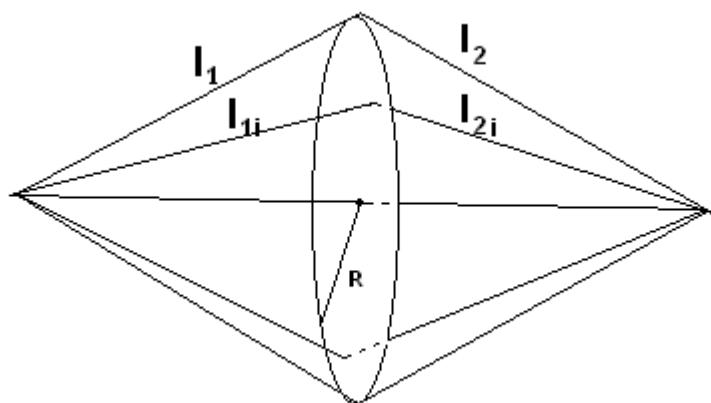
ერთად, ჩვენ გვინდა ეს ველი დავაფოკუსიროთ რაიმე სიბრტყეში მკაფიო გამოსახულების მისაღებათ. ამისათვის ჩვენ უნდა მოვათავსოთ ლინზა იმ ადგილას, სადაც ველს ვზომავთ. ლინზა, როგორც ვიცით იწვევს ტალღური ფრონტის შეცვლას; კერძოთ, ტალღური ფრონტის თითოეული ნაწილი ლინზაში გასვლის შემდეგ იძენს გარდაველ ფაზურ დაგვიანებას, რაც აისახება ტალღური ფრონტის ფორმის შეცვლაში. თუ ლინზას ბრტყელი ტალღა ეცემა, მაშინ მასში გასვლის შემდეგ ტალღურ ფრონტს ექნება ნახ. 1.4-ზე ნაჩვენები ფორმა. ამიტომ ის ფოკუსირდება.



ნახ. 1.4

ტალღის ფრონტის ცვლილება ლინზაში  
გასვლის შემდეგ, რის შედეგადაც ხდება  
ველის ფოკუსირება

ლინზის დასამოდელირებლად ვიყენებოთ ტაუტოქრონიზმის პირობას, რაც გამოიხატება შემდეგში:



ნახ. 1.5 სიბრტყის წრიულ კერთაზე სადაც ხდება  
ველის მნიშვნელობების გაზომვა მოითხოვება სხივთა  
ტაუტოქრონულობის პირობა

უოველი სხივი, რომელიც წყაროდან გამოდის, ერთ და იგივე დროს ანდომებს ფოკუსირების წერტილამდე მისვლას (ნახ. 1.5). როგორც ნახაზე ჩანს, სხვადასხვა სხივის მიერ განვლილი მანძილები არ არის ერთი და იგივე; მაგრამ ლინზა თითოეულ სხივს აყოვნებს სხვადასხვა დროით, რაც უზრუნველყოფს სხივების ტაუტოქრონულობას. მოდელირების დროს ჩვენ ვზომავთ ველის ამპლიტუდებს და ფაზებს ლინზის ზედაპირზე და შემდეგ ველის ამ მნიშვნელობებს ვამრავლებთ  $e^{i\varphi}$  - ზე, სადაც  $\varphi$  - არის ფაზური დაგვიანება, რომელსაც ლინზა იწვევს. ფაზურ დაგვიანებებს განვსაზღვრავთ შემდეგნაირად:  $\varphi = k \cdot d$ ,  $d = (l_1 + l_2) - (l_{1i} + l_{2i})$  (ნახ. 1.6) კ-არის ტალღური რიცხვი თავისუფალ გარემოში. კომბინირებული დიპოლების საშუალებით მიიღება ველის ხარისხობრივი ხასიათი. რომ მივიღოთ აღდგენილი ველის ზუსტი რაოდენობრივი აღწერა, უნდა ავიღოთ კირხვოფის ინტეგრალი, რომლის საშუალებით ელექტრული და მაგნიტური ველის დაძაბულობებს აქვს შემდეგი სახე:

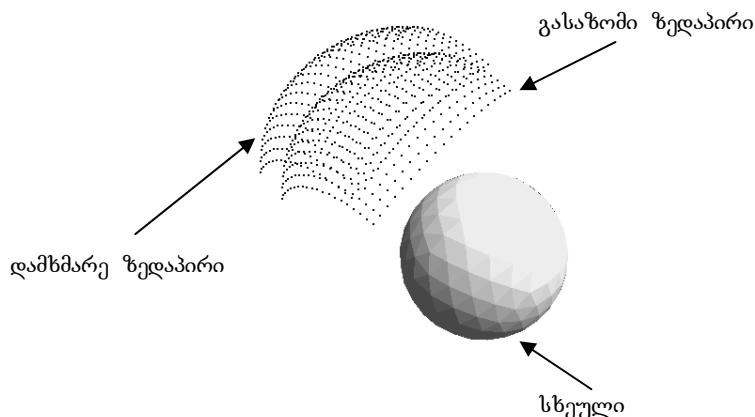
$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \frac{1}{4\pi} \int ds \frac{\exp(i(kr - \omega t))}{r} \left[ ik \vec{j}_e \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} - \left( ik - \frac{1}{r} \right) (\vec{j}_m \times \vec{r}_0 + q_e \vec{r}_0) \right]$$

$$\vec{H}(\vec{r}, t) = -\frac{1}{4\pi} \int ds \frac{\exp(i(kr - \omega t))}{r} \left[ ik \vec{j}_m \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} - \left( ik - \frac{1}{r} \right) (\vec{j}_e \times \vec{r}_0 + q_m \vec{r}_0) \right]$$

სადაც  $\vec{r}$ -არის გასაზომი ზედაპირის წერტილიდან იმ წერტილამდე მანძილი, სადაც ველი გვაინტერესებს,  $r = |\vec{r}|$ ,  $\vec{r}_0 = \frac{\vec{r}}{r}$ ,  $\vec{j}_e = \vec{n} \times \vec{H}$  სადაც  $\vec{n}$  არის გასაზომი ზედაპირის ნორმალი.  $\vec{j}_m = \vec{n} \times \vec{E}$ ,  $q_e = \vec{n} \cdot \vec{E}$ ,  $q_m = \vec{n} \cdot \vec{H}$

### §1.5 ჰოლოგრაფიული მეთოდი

შებრუნებული ამოცანების ამოსახსნელად ერთერთი ყველაზე ეფექტური მეთოდი არის ჰოლოგრაფიული მეთოდი. მისი არსი მდგომარეობს შემდეგში: გარკვეულ ზედაპირზე (ჩვენ კონკრეტულ შემთხვევაში ვიღებთ სფერულ სეგმენტს) განლაგებულია ელექტრომაგნიტური ველის სენსორები, რომლებიც ზომავენ ელექტრული ველის დაძაბულობის ამპლიტუდის და ფაზის მნიშვნელობებს. ეს არის ველი, რომელსაც ასეივებს ელექტრომაგნიტური ველის წყარო, ან რომელიც აირეკლება სხეულიდან მასზე დაცემული ველის შედეგად.



**ნახ. 1.7**  
დასასწივებელი სხეული გასაზომი ზედაპირი და  
დამხმარე ზედაპირი

ამის შემდეგ ნახ. 1.7-ზე ნაჩვენებ დამხმარე ზედაპირზე ვათავსებთ კრებად დამხმარე წყაროებს. კრებადი წყაროს მისაღებად ჩვეულებრივი ველის წყაროს განტოლებაში ტალღურ ვექტორს უნდა შევუცვალოთ მიმართულება  $k \Rightarrow -k$  დამხმარე წყაროებად ვიყენებთ ელემენტარულ ელექტრულ დიპოლს რომლის ელექტრული და მაგნიტური ველის დაძაბულობა გამოისახება შემდეგი ფორმულებით:

$$\vec{E}_n(\vec{R}_n) = \frac{1}{4\pi\varepsilon} e^{-i\omega t} \left\{ \frac{1}{R_n^3} \left( 3\vec{R}_n^\theta (\vec{R}_n^\theta, \vec{p}) - \vec{p} \right) - \frac{ik}{R^2} \left( 3\vec{R}_n^\theta (\vec{R}_n^\theta, \vec{p}) - \vec{p} \right) - \frac{k^2}{R} [\vec{R}_n^\theta [\vec{R}_n^\theta, \vec{p}]] \right\}$$

$$\vec{H}_n(\vec{R}_n) = -\frac{i\omega}{4\pi} e^{-i\omega t} \left( \frac{1}{R_n^2} - \frac{ik}{R_n} \right) [\vec{p}, \vec{R}_n^\theta]$$

იმ წერტილებში სადაც გაგზომეთ ველი, ვითხოვთ სასაზღვრო პირობების შესრულებას – ელექტრული ველის უწყვეტობის პირობას, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდნენ დამხმარე ზედაპირზე განლაგებული დამხმარე წყაროები. შედეგად მიიღება განტოლებათა სისტემა რომლის ამოსსნაც საშუალებას იძლევა განვსაზღვროთ დამხმარე წყაროთა კომპლექსური ამპლიტუდები. მათი განსაზღვრის შემდეგ უკვე შესაძლებელია ველის ანალიზური გაგრძელება, ანუ ველის აღდგენა ჩვენთვის სასურველ არეში. მოცემული მეთოდი საშუალებას გვაძლევს ველი აღვადგინოთ იმ არეში, სადაც ველი სასრულია და არ გვაქვს განსაკუთრებულება.

თავი II  
შებრუნებული ამოცანების ამოხსნა

## ზოგადი მიმოხილვა

ადამიანის ძირითადი ინსტრუმენტი სივრცეში ორიენტირებისათვის თავიდანვე იყო თვალი, რომლითაც ის აკვირდებოდა სამყაროს, განასხვავებდა საგნებს ერთმანეთისგან, ადგენდა საგნამდე მანძილს, მის ზომას, ფორმას. ელექტრომაგნიტური ტალღების დიაპაზონი საკმაოდ ფართოა. ადამიანის თვალი მგრძნობიარეა ამ დიაპაზონის მხოლოდ საკმაოდ ვიწრო უბნის, კერძოდ ხილული სინათლის მიმართ. მზის თუ სინათლის სხვა წყაროს მიერ გამოსხივებული სინათლე ირეცლება სხვადასხვა სხეულიდან, ხვდება ადამიანის თვალში და პროექცირდება თვალის ბადურაზე არსებულ ნერვულ დაბოლოებებზე. ამ უკანასკნელში აღძრული ნერვული იმპულსები მიეწოდება ტვინს. ტვინი ახდენს ამ ინფორმაციის დამუშავებას და გარემომცველ სამყაროს ხდის ხილულს. ოდითგანვე ადამიანი ახდენდა სხვადასხვა მოვლენის აღწერას და შემდეგი თაობისთვის გადაცემას წერილობითი სახით, მაგრამ საუკეთესო საშუალებას ამ მიზნის განხორციელებისთვის, მაინც თვალით მიღებული ინფორმაციის შენახვა წარმოადგენდა. ამ მიზნით მეცნიერებმა შექმნეს ფოტო აპარატი. რომელიც საშუალებას იძლევა ამა თუ იმ მოვლენის დაფიქსირებისა. იგივე ფოტო აპარატი კარგი საშუალებაა დააკვირდეს სხვადასხვა მანძილზე მდებარე საგნებს, მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ საგნებს სხვა საგნები არ ეფარება. ცნობილია, რომ ყველა საგანი არ უშლის ხელს სხვა საგნის დანახვას, მაგალითად წყალი, მინა, რადგან ისინი ხილულ დიაპაზონში გამჭვირვალეა. მეცნიერულმა გამოკვლევებმა ცხადყო, რომ ყველა ნივთიერებას შეესაბამება ელექტრომაგნიტური ტალღების სპექტრის დიაპაზონი, რომელშიც ის მეტნაკლებად გამჭვირვალეა და ამრიგად თუ შევქმნით თვალის ანალოგს მოცემული სიხშირული დიაპაზონისათვის, შევძლებთ დავინახოთ საგნები რომლებიც იმყოფებიან სხვა გარემოში, ან რომლებიც არ არიან უშუალო ხედვის არეში.

ქვემოთ განხილული იქნება ამ ამოცანის გადაჭრის ერთერთი საშუალება. ტვინის როლს შესარულებს კომპიუტერი, რომელიც გარკვეულ სეგმენტზე დალაგებულ სენსორებში გაზომილ ველის მნიშვნელობებით მიღებულ ინფორმაციას დაამუშავებს და მოახდენს ველის ვიზუალიზაციას სასურველ არეში, რაც შესაძლებელს გახდის იმ საგნის ან სინათლის წყაროს დანახვისა, რომლიდან მოსული ველის მნიშვნელობებიც ჩვენ სეგმენტზე გავზომეთ.

ასეთი ტიპის ამოცანებს შებრუნებული ამოცანები ეწოდება.

შებრუნებული ამოცანები დღესდღეობით მეტად აქტუალურია. მათ გამოყენების ფართო არე აქვთ. მაგალითად ის გამოიყენება სამედიცინო ტომოგრაფიაში ადამიანის შინაგანი ორგანოების გამოსაკვლევად, მიწაში არსებული ძვირფასი მასალების აღმოსაჩენად არქეოლოგიური გათხრების თავიდან ასაცილებლად, ან ფეოქებადი საგნების მდებარეობის დასადგენად (დიელექტრიკული თუ მეტალური ნაღმები). დღესდღეობით ის განსაკუთრებულ აქტიურ გამოყენებას პოულობს მიწაში არსებული წყალსადენი დეფექტური მილების დეტექტირებისთვის: როგორც ცნობილია, დროთა განმავლობაში მილი ზიანდება, რაც შეიძლება გამოწვეული იყოს კოროზით ან თუ ის პლასტმასისგანად დამზადებული - ლპობით; ან შესაძლოა მილს პქონდეს ქარხნული დეფექტი, რაც დიდი ხნის შემდეგ იჩენს თავს. წყალი, რომელიც ჟონავს გამსკდარი მილიდან, იკავებს გარკვეულ მოცულობას მიწაში. თუ წყალი არ აღწევს მიწის ზედაპირს, მაგალითად ის შეიძლება მიწაში იკეთებს არსს და გაედინება. მისი დეტექტირება ზემოდან თვალით შეუძლებელია და ამიტომ

ხდება დიდი მასის სასმელი წყლის დაკარგვა. წყლის დროებით შეწყვეტის შემთხვევაში, გაუონილი წყალი შეიძლება უკან მიღმივე შებრუნდეს და დააბინძუროს სასმელი წყალი. ამიტომ სასურველია შეიქმნას ისეთი მოწყობილობა, რომელიც საშუალებას მოგვცემს ზემოდან, მიწასთან უშუალოდ შეხების გარეშე, დადგინდეს სად არის მიღი დაზიანებული. ეს ამოცანა შეიძლება ამოიხსნას მიწის ზემოდან ელექტრომაგნიტური ტალღის დასხივების და შემდგომ მიწიდან და მისი სიღრმეებიდან არეკვლილი ველით მიღებული ინფორმაციის დამუშავების შედეგად, რადგან არეკვლილი ველი შეიცავს ინფორმაციას მიწის სტრუქტურის შესახებ.

მიწა არსებობს სხვადასხვა სახის. ეს შეიძლება იყოს ნიადაგი, ქვიშა, თიხა და ა.შ. ამიტომ სხვადასხვა ადგილას მისი პარამეტრები (დიელექტრიკული შეღწევადობა, მაგნიტური შეღწევადობა, გამტარებლობა) განსხვავებულია. მიწის პარამეტრები დამოკიდებულია აგრეთვე ტემპერატურაზე და მასში წყლის შემცველობაზე. ექსპერიმენტი გვიჩვენებს, რომ როგორიც არ უნდა იყოს მიწა, აუცილებლად არსებობს სიხშირული დიაპაზონი, რომელშიც ის მეტ-ნაკლებად გამჭვირვალეა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ის შედარებით ნაკლებად შთანთქავს მასში შესულ ელექტრომაგნიტურ ტალღებს მოცემულ დიაპაზონში. ეს იძლევა საშუალებას აღმოვაჩინოთ მასში მოთავსებული სხეულები საკმაოდ დიდ სიღრმეზე.

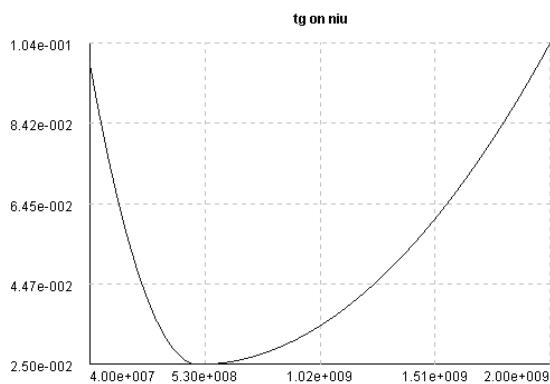
შებრუნებული ამოცანის ამოხსნა ნიშნავს, შორ ზონაში გაზომილი ველის საშუალებით, ამ ველის წყაროს პოვნას. ველის წყარო შეიძლება იყოს როგორც აქტიური, ისე პასიური. სხეული, რომლიდანაც რაიმე წყაროს მიერ გამოსხივებული ელექტრომაგნიტური ტალღა ირეკლება, წარმოადგენს ველის პასიურ წყაროს. თავად ელექტრომაგნიტური ველის წყარო კი წარმოადგენს აქტიურ წყაროს. აქტიური წყარო შეიძლება იყოს იმპულსის გენერატორი, რომელიც ასხივებს პერიოდულ იმპულსებს. იმპულსის პერიოდი ისე უნდა იყოს შერჩეული, რომ არეკვლილი იმპულსის დეტექტირება უნდა მოხდეს მანამ, სანამ მეორე იმპულსი მოასწრებს მოსვლას. იმპულსის სპექტრი მდიდარი უნდა იყოს ისეთი სიხშირეებით, რომლისთვისაც გარემო მეტ-ნაკლებად გამჭვირვალეა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ენერგიის დიდი ნაწილი შთანთქმება და არეკვლილი ველის გაზომვას ვერ შევძლებო მისი სიმცირის გამო.

## §2.1 მიწის მახასიათებლის აღდგენა

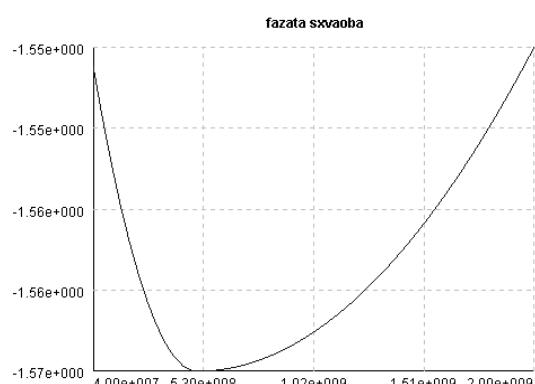
როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, იმისათვის რომ ამონებნას ძირითადი ამოცანა, ანუ მოხდეს მიწაში ჩაძირული სხეულების ვიზუალიზაცია და მათი ფორმების გარჩევა ე.მ. იმპულსების ზონდირებით და სათანადო არეკვლილი ველის ანალიზით, საჭიროა მოხდეს მიწის ელექტროდინამიკური თვისებების შესწავლა, რათა შეირჩეს ისეთი დაცემული იმპულსი, რომლის ფურიე სპექტრიც შეიცავს სიხშირეებს, რომლისთვისაც მიწა მეტ-ნაკლებათ გამჭვირვალეა. ეს გასაგებია, რადგან ჩვენი ამოცანაა რაც შეიძლება უფრო დიდი სიდრომიდან ამოვიდოთ ინფორმაცია. როგორც უკვე ზემოთ აღნიშნეთ, მიწის ელ. დინამიკური პარამეტრები მკვეთრად იცვლება ადგილიდან ადგილამდე, დამოკიდებულია ტემპერატურაზე, მის შემადგენლობაზე (ქვიშიანი, თიხიანი, თუ სხვა სახის), წყლის პროცენტულ შემცველობაზე და ა. შ. ამიტომ, წინასწარ მისი შთანთქმისა და დიელექტრიკული შეღწევადობის დამოკიდებულება სიხშირეზე ზოგადად უცნობია. მიწის სინჯის აღება და მისი ლაბორატორიული გამოკვლევა კი დიდ დროს და დამატებით სამუშაოებს საჭიროებს.

ამ შუალედური ამოცანის ამოსახსნელად, ჩვენს მიერ შემუშავებული იქნა მეთოდი, რომელიც იძლევა საშუალებას განისაზღვროს ან შეფასდეს მიწის ელ-დინამიკური მახასიათებლები სინჯის აღების გარეშე. კერძოთ, თუ მიწას დავასხივებთ სასინჯ, (წინასწარ ცნობილი ამპლიტუდური და ფაზური ფურიე სპექტრის მქონე) რაიმე იმპულსით და შემდგომ, მისგან არეკვლილ იმპულსს აგრეთვე დავშლით ფურიე სპექტრად, დაცემული და არეკვლილი იმპულსების ფაზური და ამპლიტუდური სპექტრალური კომპონენტების შედარებით, კერძოთ, მათი სხვაობებით, შესაძლებელია შევაფასოთ დედამიწის ელ-დინამიკური თვისებები. რიცხვითმა ექსპერიმენტებმა გვაჩვენა, რომ დაცემული და არეკვლილი იმპულსების ფურიეს სპექტრალური კომპონენტების ფაზათა სხვაობის სიხშირეზე დამოკიდებულება, ზუსტად იმეორებს მიწის შთანთქმითი სიხშირული მახასიათებლის დამოკიდებულებას. ეს ფაქტი საშუალებას იძლევა განგსაზღვროთ მიწის შთანთქმითი მახასიათებლის სიხშირული დამოკიდებულებების გრაფიკი და დავადგინოთ, რომელ დიაპაზონში არის მიწა უფრო, ან მეტ-ნაკლებათ გამჭვირვალე, ანუ მისი შთანთქმის დამოკიდებულებას რა სიხშირეზე გააჩნია მინიმუმი.

მაგალითის სახით, ნახ. 2.1-ზე მოცემულია გარკვეული მიწის მილევა-დანაკარგების კუთხის ტანგენსის სიხშირეზე დამოკიდებულება, ხოლო ნახ. 2.2-ზე დაცემულ და არეკვლილ იმპულსთა სპექტრალური კომპონენტების ფაზათა სხვაობის დამოკიდებულება სიხშირეზე.



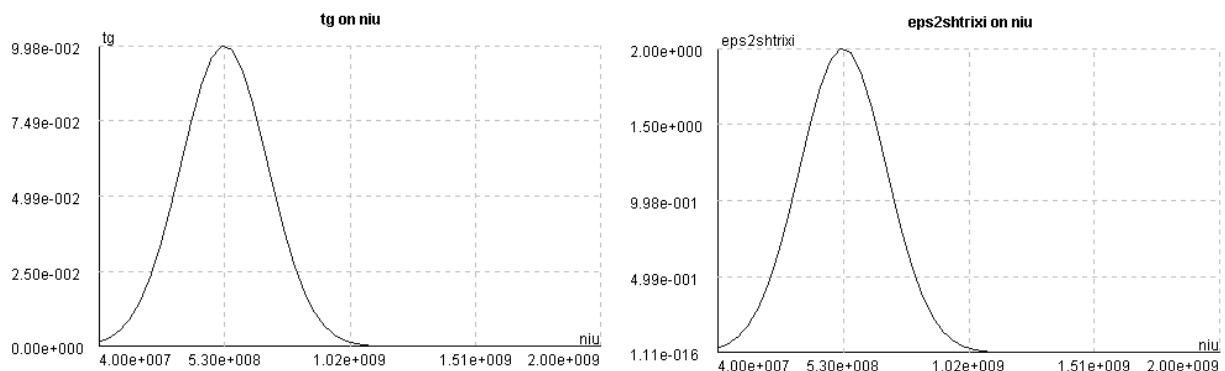
ნახ. 2.1 სკელი ნიადაგის მილევის  
ტანგენსის სიხშირეზე დამოკიდებულება



ნახ. 2.2 აღდგენილი  
მახასიათებლის სახე

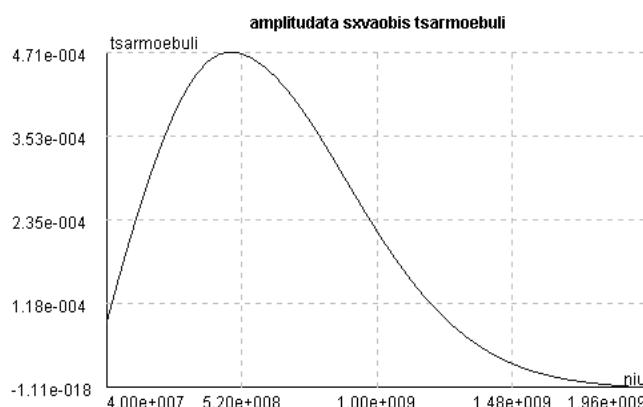
როგორც სურათიდან ჩანს თანხვედრა საკმაოდ კარგია და ეს ფაქტი იძლევა იმედს, რომ დისტანციურად, ელ-მაგნიტური ტალღის იმპულსის ზონდირებით, შესაძლებელია სწრაფად დადგინდეს ნიადაგის “გამჭვირვალობის” სიხშირული არე.

განვიხილოთ შემთხვევა როდესაც  $\varepsilon'$  მუდმივია, ხოლო  $\varepsilon''$  და მიღევის კუთხის ტანგენტის დამოკიდებულია სიხშირეზე ისე, როგორც ეს ნახ. 2.3-ზეა ნაჩვენები (კომპლექსური დიელექტრიკული შეღწევადობა  $\varepsilon = \varepsilon' + i\varepsilon''$ ; ხოლო მიღევის კუთხის ტანგენტის  $tg\delta = \frac{\varepsilon''}{\varepsilon'}$ )



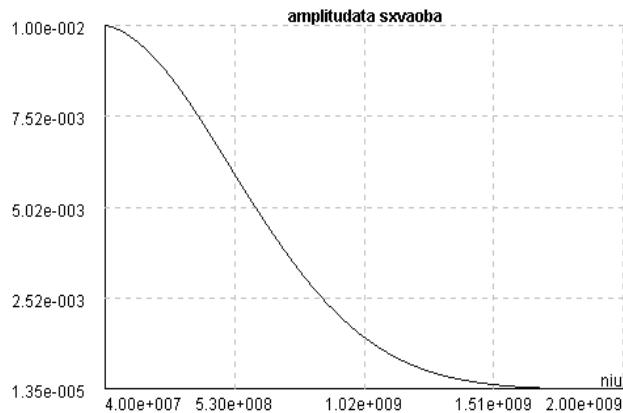
ნახ. 2.3 მიღევის ტანგენტის სიხშირული მახასიათებელი (მარცხნივ) და  $\varepsilon''$  – ის აღდგენილი სიხშირული მახასიათებელი (მარჯვნივ)

დაცემული და არეკვლილი იმპულსების სპექტრალური კომპონენტების ფაზათა სხვაობის სიხშირეზე დამოკიდებულება იმეორებს  $\varepsilon''$ -ის მახასიათებლის ფორმას. მახასიათებლის შესახებ ინფორმაციას იძლევა არა მარტო ფაზათა სხვაობა, არამედ ამპლიტუდათა სხვაობის წარმოებულიც. მისი სიხშირეზე დამოკიდებულება წარმოდგენილია ნახ. 2.4-ზე.



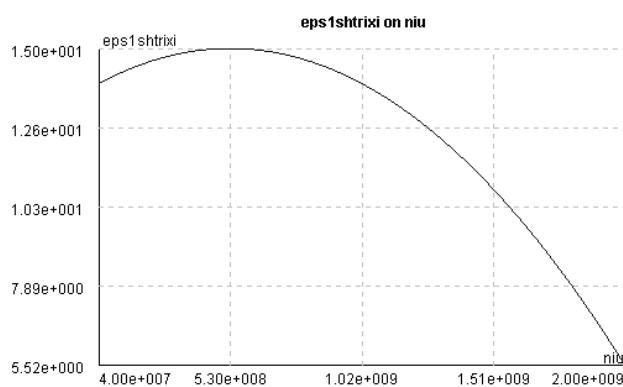
ნახ. 2.4 ამპლიტუდათა სხვაობის წარმოებულის სპექტრის სიხშირეზე დამოკიდებულება

ყურადღება უნდა მიექცეს იმ ფაქტს, რომ აქ ლაპარაკია ამპლიტუდათა სხვაობის წარმოებულზე და არა ამპლიტუდათა სხვაობაზე. ამ უკანასკნელის სიხშირული მახასიათებელი წარმოდგენილია ნახ. 2.5-ზე და ნათლად ჩანს, რომ ის მახასიათებლის შესახებ ინფორმაციას არ იძლევა:



ნახ. 2.5  
ამპლიტუდათა სხვაობის სპექტრის სიხშირული მახასიათებელი

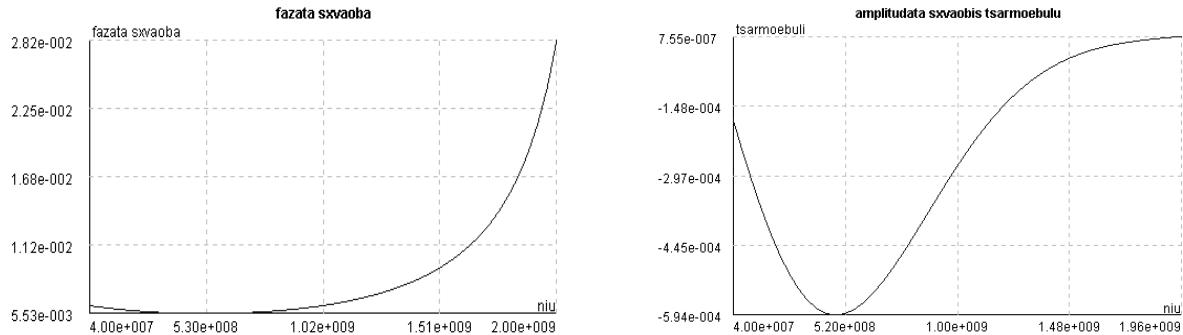
ახლა განვიხილოთ შემთხვევა როდესაც პირიქით  $\varepsilon''$  მუდმივია, ხოლო  $\varepsilon'$  დამოკიდებულია სიხშირეზე, ისე როგორც ეს ნახ. 2.6-ზეა ნაჩვენები.



ნახ. 2.6  
 $\varepsilon'$  – ის სიხშირული მახასიათებელი

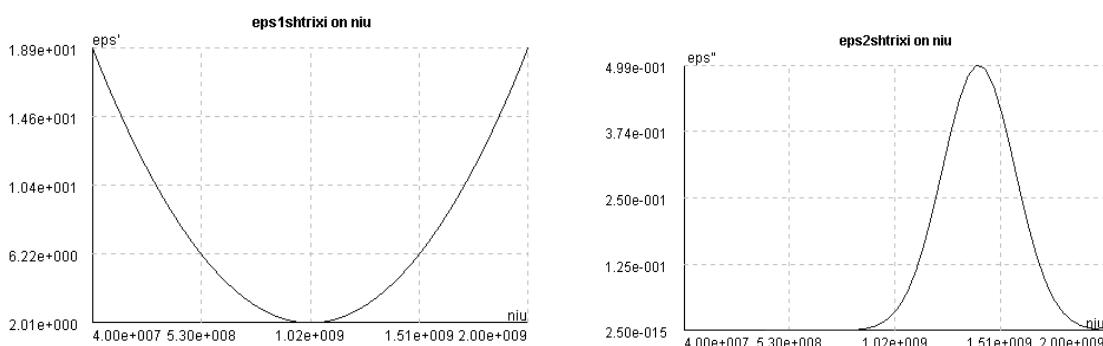
ამ შემთხვევაში დაცემული და არეკვლილი იმპულსის სპექტრალური კომპონენტების ფაზათა სხვაობა და ამპლიტუდათა სხვაობის წარმოებული

იძლევა საშუალებას ვიპოვოთ მახასიათებლის ექსტრემუმი. ნახ. 2.7-ზე წარმოდგენილია მათი სიხშირული მახასიათებლები.



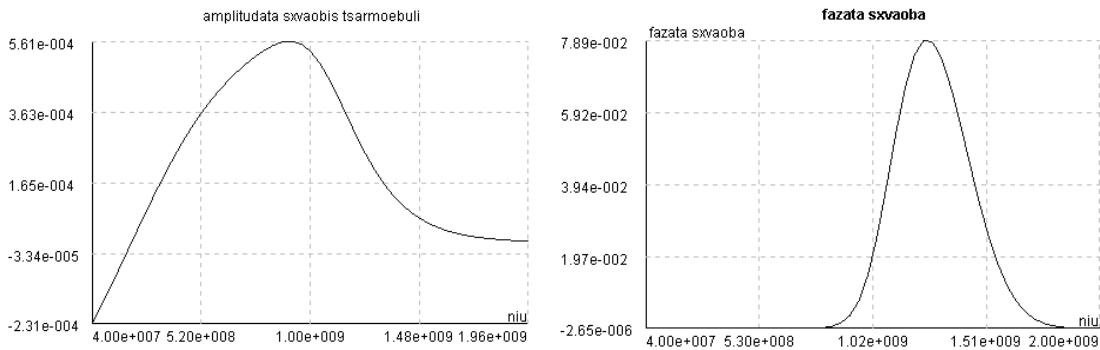
ნახ. 2.7 დაცემული და არეკვლილი იმპულსის სპექტრალურ კომპონენტების ფაზათა სხვაობისა (მარცხნივ) და ამპლიტუდათა სხვაობის (მარჯვნივ) წარმოებულის სიხშირული მახასიათებელი

განვიხილოთ საბოლოო ყველაზე ზოგადი შემთხვევა, როდესაც  $\varepsilon'$  და  $\varepsilon''$  ორივე დამოკიდებულია სიხშირეზე. ეს დამოკიდებულებები მოცემულია ნახ. 2.8-ზე.



ნახ. 2.8  $\varepsilon'$  -ის (მარცხნივ) და  $\varepsilon''$  -ის (მარჯვნივ) სიხშირული მახასიათებლები

ამ შემთხვევაში დაცემული და არეკვლილი იმპულსის სპექტრალური კომპონენტების ამპლიტუდათა სხვაობის წარმოებული აღადგენს და პოულობს  $\varepsilon'$ -ის ექსტრემუმს, ხოლო ფაზათა სხვაობა კარგი სიზუსტით აღადგენს  $\varepsilon''$ -ის სიხშირულ მახასიათებელს (ნახ. 2.9).



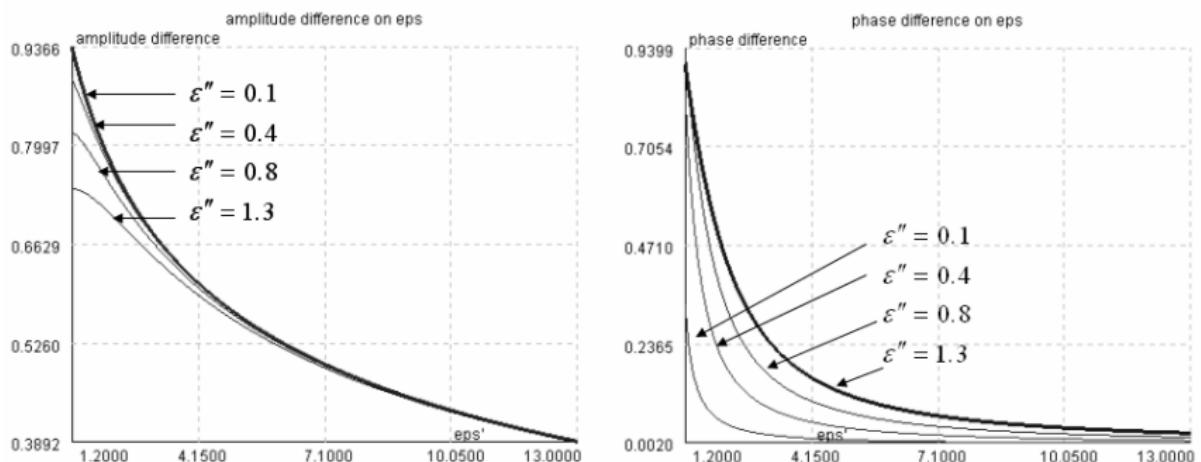
ნახ. 2.9 ამპლიტუდათა სხვაობის წარმოებული აღადგენს  $\varepsilon'$ -ის ექსტრემუმს (მარცხნივ), ხოლო ფაზათა სხვაობა კარგი სიზუსტით აღადგენს  $\varepsilon''$ -ის სისშირულ მახასიათებელს (მარჯვნივ)

ამ მახასიათებლების მიღებისთვის ჩვენ გამოვიყენეთ ზუსტი ამონახსნის ფორმულა იმ შემთხვევისათვის, როდესაც ორი გარემოს გამყოფ ზედაპირს ეცემა ბრტყელი ელ-მაგ ტალღა. ანალიზური ფორმით არსებობს ეს ამონახსნი (1) და არეკვლის კოეფიციენტის კომპლექსურ გამოსახულებას აქვს შემდეგი სახე: (სიმარტივისათვის, დაცემული ტალღის ამლიტუდა მიღებულია ერთის ტოლად):

$$r_{\perp} \equiv \frac{R_{\perp}}{E_{\perp}} = \frac{n_1 \cos \varphi - n_2 \cos \psi}{n_1 \cos \varphi + n_2 \cos \psi} \quad (1)$$

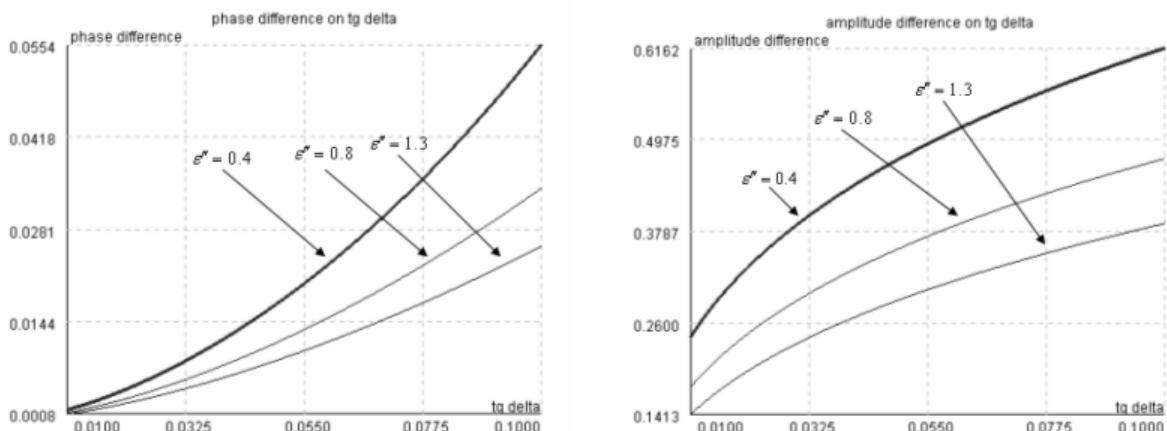
სადაც  $n_1$  - პირველი, ხოლო  $n_2$  - მეორე გარემოს გარდატეხის მაჩვენებელია; ხოლო  $\varphi$  და  $\psi$  შესაბამისად დაცემის და გარდატეხის კუთხე.

მიწიდან არეკვლილი ველი საშუალებას იძლევა განისაზღვროს არა მარტო მიწის მახასიათებლის ფორმა, არამედ რიცხობრივი მნიშვნელობებიც. განვიხილოთ  $\varepsilon'$ -ის მნიშვნელობების აღდგენა, როდესაც ცნობილია  $\varepsilon''$ . ამჯერად მიწას ეცემა მონოქრომატული ტალღა. პირველ რიგში ვაგებთ დაცემული და არეკვლილი ველის ფაზათა და ამპლიტუდათა სხვაობის დამოკიდებულებას  $\varepsilon' - \varepsilon''$  და მიღევის ტანგენსზე სხვადასხვა  $\varepsilon''$ -ის შემთხვევაში (ნახ. 2.10, 2.11). ექსპერიმენტის დროს, როდესაც მოხდება არეკვლილი ველის ფაზის და ამპლიტუდის გაზომვა, მიღებული გრაფიკების საშუალებით მოხდება  $\varepsilon'$ -ის და  $tg \delta$  - მნიშვნელობების განსაზღვრა.



**ნახ. 2.10**  
ფაზათა და ამპლიტუდათა სხვაობის  
დამოკიდებულება დიელექტრიკულ  
შეღწევადობაზე

ნახ. 1.10, და 1.11-ზე წარმოდგენილია საწყისი გრაფიკები, რომელთა საშუალებითაც ხდება დიელექტრიკული შეღწევადობისა და მიღების ტანგენსის მნიშვნელობების აღდგენა, ფაზათა და ამპლიტუდათა სხვაობის გაზომილი მნიშვნელობების საფუძველზე.



**ნახ. 2.11**  
ფაზათა და ამპლიტუდათა სხვაობის  
დამოკიდებულება მიღების კუთხის  
ტანგენსზე

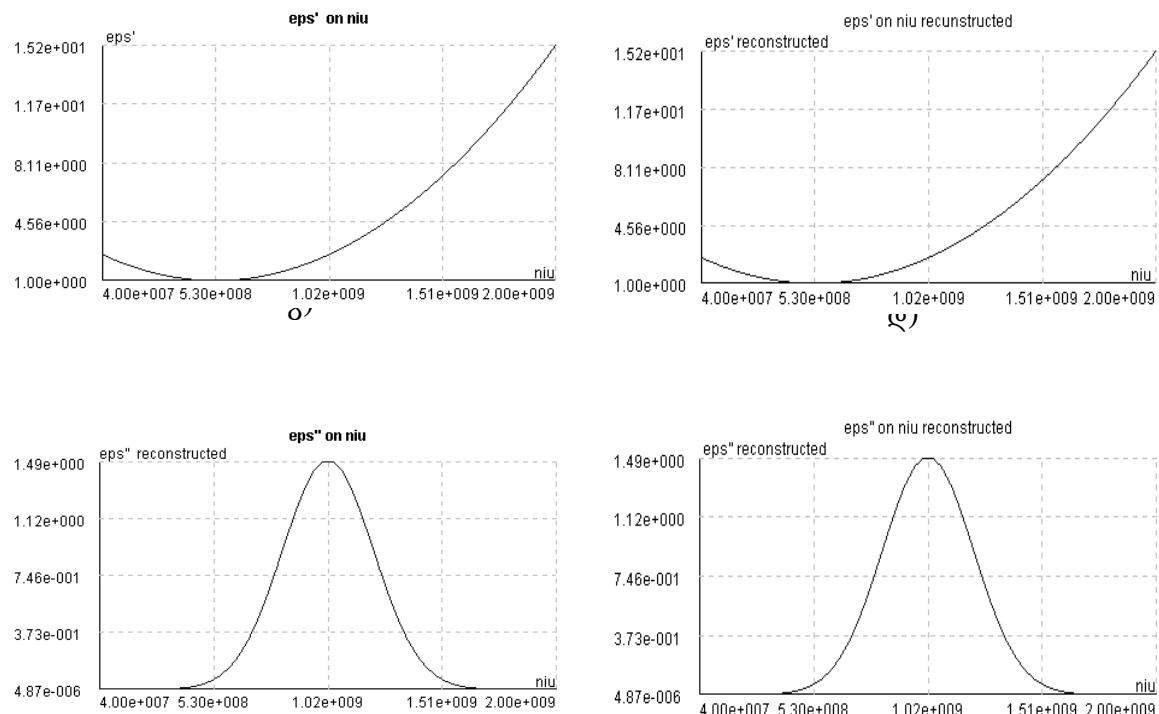
(1) ფორმულა საშუალებას იძლევა განისაზღვროს დიელექტრიკული შეღწევადობა ანალიზურად. ამ ფორმულის მარტივი გარდაქმნის შედეგად, თუ გავითვალისწინებთ, რომ  $n_1 = \sqrt{\epsilon_1}$  და  $n_2 = \sqrt{\epsilon_2}$ , და რადგანაც პირველი გარემო რომლიდანაც სხივი 2 გარემოს გამყოფ ზედაპირს ეცემა ჰაერია, ამიტომ  $\epsilon'_1 = 1$ ,

$$\varepsilon_1'' = 0 \quad \text{და:}$$

$$\varepsilon_2 = \left( \frac{\cos \varphi}{\cos \psi} \right)^2 \cdot \left( \frac{1 - r_{\perp}}{1 + r_{\perp}} \right)^2 \quad (2)$$

თავიდან უნდა შეირჩეს იმპულსი საკმაოდ ფართო სიხშირული დიაპაზონით, მას ვშლით ფურიე სპექტრად და თითოეული სპექტრალური კომპონენტისთვის ვიყენებთ ფორმულას  $r_{\perp} = \frac{E_r}{E_{inc}}$ .

მიწას წინასწარ ვანიჭებთ სასურველ სიხშირულ მახასიათებელს, სადაც  $\varepsilon'$  და  $\varepsilon''$  დამოკიდებულია სიხშირეზე, და მას შემდეგ, რაც განვსაზღვრავთ არეკვლის კოეფიციენტს, ვიყენებთ (2) გამოსახულებას თითოეული სპექტრალური კომპონენტისთვის.



ნახ. 2.12

დიელექტრიკული შეღწევადნის სიხშირული მახასიათებლის აღდგენა:

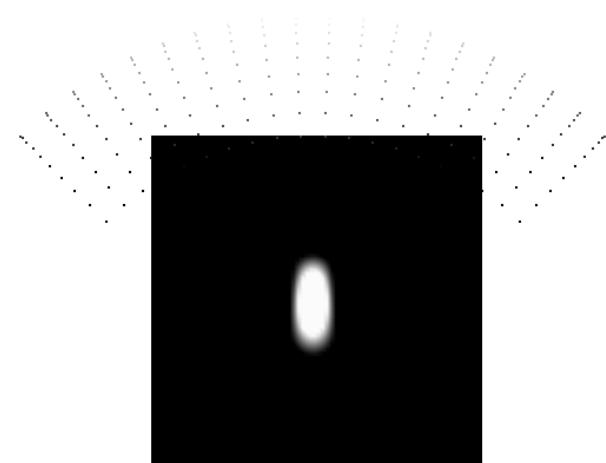
- ა)  $\varepsilon'$ -ის სიხშირული მახასიათებელი ბ) აღდგენილი  $\varepsilon'$ -ის სიხშირული მახასიათებელი
- გ)  $\varepsilon''$ -ის სიხშირული მახასიათებელი დ) აღდგენილი  $\varepsilon''$ -ის სიხშირული მახასიათებელი

დიელექტრიკული შეღწევადობის აღდგენილი მახასიათებელი რიცხვითი მნიშვნელობების მესამე ნიშნამდე სიზუსტით ემთხვევა საწყის მახასიათებელს. ნახ. 2.12-ზე წარმოდგენილია ამ მეთოდით დიელექტრიკული შეღწევადობის სიხშირული მახასიათებლის აღდგენის შემთხვევები.  $\varepsilon'$ -ის სიხშირულ მახასიათებელს აქვს პარაბოლის ფორმა, ხოლო  $\varepsilon''$ -ს გაუსის. ეს მეთოდი მუშაობს მაშინ, როცა მიწა ერთგვაროვანია და ბრტყელი, რაც საშუალებას იძლევა გამოვიყენოთ (2) ფორმულა.

### შებრუნებული ამოცანების ამოხსნა პოლოგრაფიული მეთოდის საშუალებით §2.2 წყაროთა ველის აღდგენა

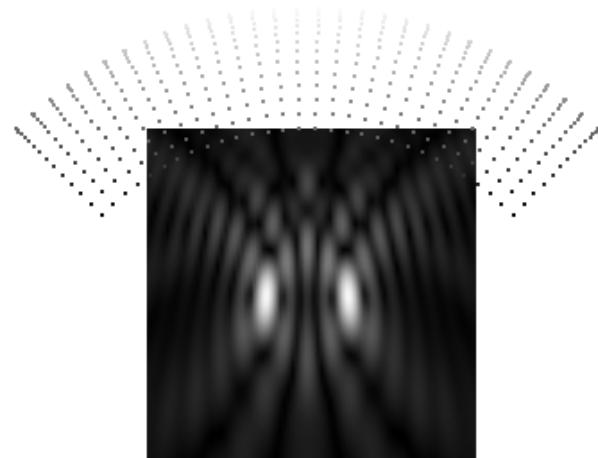
ზემოთ ჩვენ განვიხილეთ პოლოგრაფიული მეთოდის არსი. კერძოთ, თუ რა სახეს იღებს დამხმარე გამომსხივებლების მეთოდი შებრუნებული ამოცანების ამოხსნისას. განვიხილოთ კონკრეტული შემთხვევა, როდესაც გვაქვს ერთი წყარო და მოვახდინოთ მისი ველის აღდგენა.

ნახ. 2.13-ზე წარმოდგენილია ელემენტარული დიპოლის ველის აღდგენილი სურათი. ნახ. 2.13-ზე წარმოდგენილია აგრეთვე სეგმენტი, რომელზეც ხდება ველის მნიშვნელობების გაზომვა. აღდგენილი ველის ხარისხი დამოკიდებულია სეგმენტის ზომაზე, მის მდებარეობაზე, ორიგინტაციაზე და წყაროს სიხშირეზე.



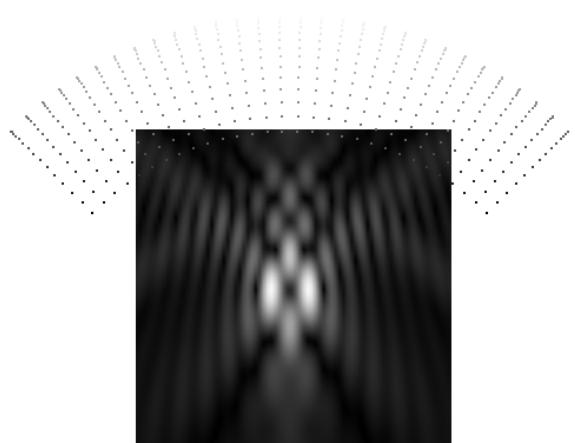
ნახ. 2.13  
ერთი წყაროს ფოკუსირება  
აღდგენილი E ველის პროექცია

განვიხილოთ ორი წყაროს ველის აღდგენის შემთხვევა. რადგან თითოეული წყაროს აღდგენილი ველი არ არის წერტილი, ამიტომ ამ წყაროთა ველი გადაიფარება და გადაფარვას აღგილი ექნება მანამ, სანამ წყაროები ერთმანეთისგან გარკვეულ მანძილზე არ იქნებიან დაშორებული. ორი წყაროს ველის გარჩევადობა გაუმჯობესდება აგრეთვე სიხშირის გაზრდით.

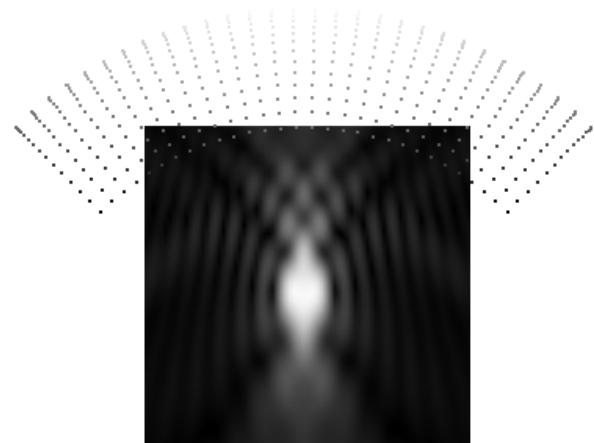


ნახ. 2.14 ორი წყაროს  
გელის აღდგენა

ნახ. 2.14-ზე წარმოდგენილია ორი ელემენტარული დიპოლის გელის აღდგენილი სურათი. წყაროები განცალკევებულია და ამიტომ შეიძლება თითოეული მათგანის გარჩევა. ამ შემთხვევაში წყაროები ერთმანეთისგან ერთი მეტრით არიან დაშორებული. ახლა განვიხილოთ შემთხვევა, როდესაც წყაროები ერთმანეთთან ახლოს არიან მოთავსებული. ნახ. 2.15-ზე წარმოდგენილია ორი წყაროს გელის აღდგენა წყაროთა შორის სხვადასხვა მანძილის შემთხვევაში



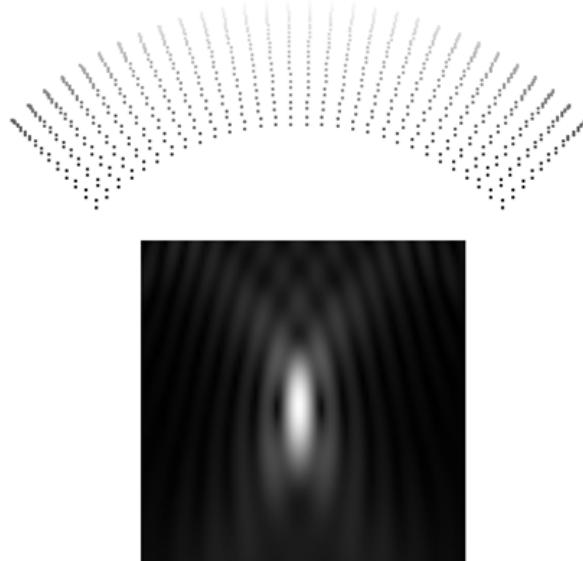
ა)



ბ)

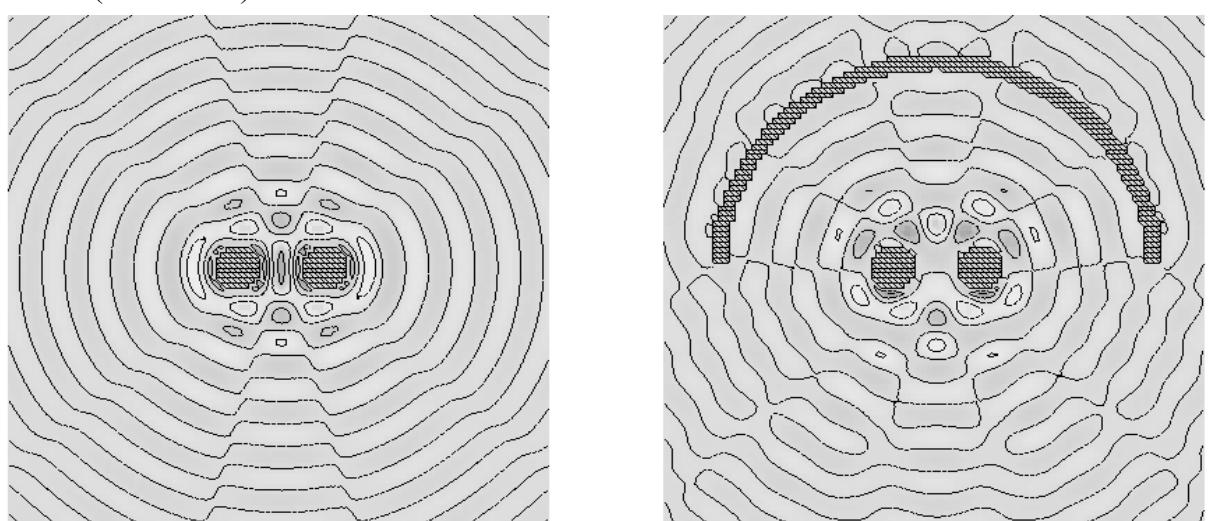
ნახ. 2.15 2 წყაროს გელის აღდგენა  
ა) წყაროთა შორის მანძილი 0.4 მეტრია  
ბ) წყაროთა შორის მანძილი 0.3 მეტრი.

- ა) შემთხვევაში წყაროთა შორის მანძილი 0.4 მეტრია, ხოლო ბ) შემთხვევაში 0.3 მეტრი. როგორც ნახაზებზე ჩანს, წყაროთა დაახლოებით მათი გარჩევადობა უარესდება და ბ) შემთხვევაში ის ერთ წყაროდ აღიქმება. დავუბრუნდეთ ისევ ერთი წყაროს შემთხვევას და ვნახოთ როგორაა დამოკიდებული წყაროს ველის აღდგენა სეგმენტის მდებარეობაზე.



ნახ. 2.16  
ერთი წყაროს ველის აღდგენა, როდესაც  
წყარო სეგმენტიდან მოშორებულია

ჩვენს მიერ განხილულ წინა შემთხვევებში, სეგმენტის ცენტრი წყაროდან დაცილებული იყო 1.5 მეტრით და წყარო მდებარეობდა სეგმენტის მიერ შემოსაზღვრულ სექტორის შიგნით. თუ სეგმენტს გადავაადგილებთ ზევით ისე, რომ სეგმენტის ცენტრი დაემთხვევა წყაროს მდებარეობას, მივიღებთ შემდეგ სურათს ( ნახ. 2.16)



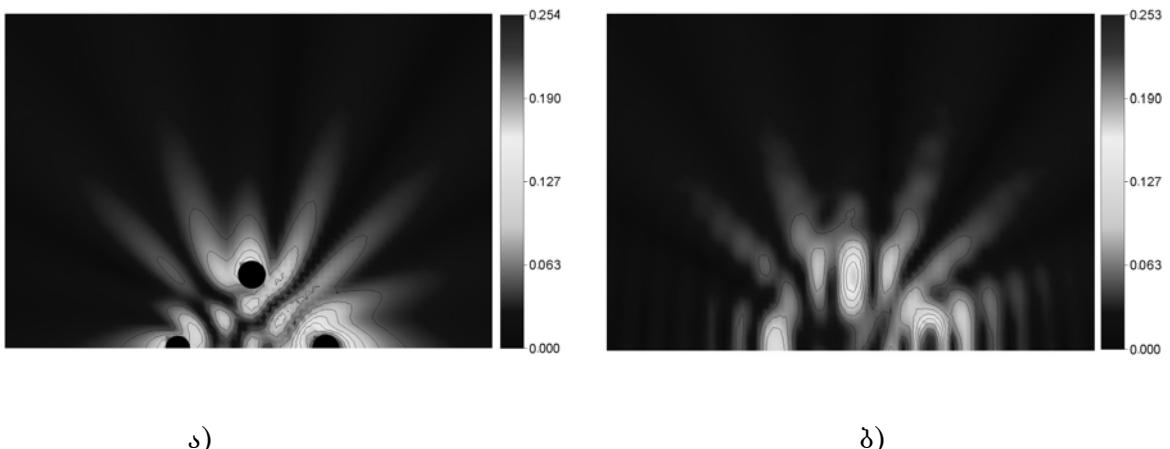
ნახ. 2.17  
2 წყაროს ველი დინამიურ რეჟიმში  
ა) რეალური ველი ბ) აღდგენილი

როგორც ნახაზზე ჩანს, წყაროს ველი უფრო მეტადაა გადღაბნილი მე-2.13 სურათზე წარმოდგენილ შემთხვევასთან შედარებით, ანუ აღდგენის ხარისხი გაუარესებულია. აქედან გამომდინარეობს, რომ აღდგენილი სურათი უფრო ახლოსაა რეალურთან, თუ წყარო სეგმენტის შემოსაზღვრული სექტორის შიგნით მდებარეობს.

აქამდე ვაკვირდებოდით ველის ამპლიტუდის მნიშვნელობების განაწილებას. ახლა შევადაროთ ველის მნიშვნელობები ფაზების გათვალისწინებით. ნახ. 2.17-ზე წარმოდგენილია ორი წყაროს ველი დინამიურ რეჟიმში: а) სურათზე შემთხვევა შეესაბამება რეალური ველის სურათს; ხოლო ბ) აღდგენილს. სეგმენტის შიგნით ველის მნიშვნელობები ერთმანეთს მეოთხე ნიშნის სიზუსტით ემთხვევა. თუ ველის გავრცელების სურათს დავაკვირდებით, დავრწმუნდებით რომ სეგმენტის შიგნით არა მარტო ველის მნიშვნელობები, არამედ გავრცელების მიმართულებაც ემთხვევა. სურათზე (პროგრამულად) განულებულია (ნულადაა აღებული) ველის მნიშვნელობები უშუალოდ წყაროს მდებარეობის ადგილას, რადგან რეალური ველის შემთხვევაში იქ განსაკუთრებულობები გვაქვს. ჩვენ აქამდე განვიხილავდით განმხოლოებულ წყაროთა ველის აღდგენის შემთხვევებს. ეხლა განვიხილოთ კიდევ ერთი შემთხვევა, კერძოთ სამი წყაროს ველის აღდგენა და შემდეგ გადავიდეთ უშუალოდ სხეულის ზედაპირის აღდგენაზე. ნახ. 2.18 გვიჩვენებს სამი წყაროს ველის აღდგენას ა) შეესაბამება რეალური ველის სურათს, სადაც უშუალოდ წყაროს მდებარეობის ადგილას ამოჭრილია (განულებულია) ველის მნიშვნელობები; ბ) კი შეესაბამისად არის აღდგენილი ველის სურათი. სურათებიდან ჩანს, რომ დამთხვევა საქმაოდ კარგია.

### §2.3 სხეულის ზედაპირის აღდგენა

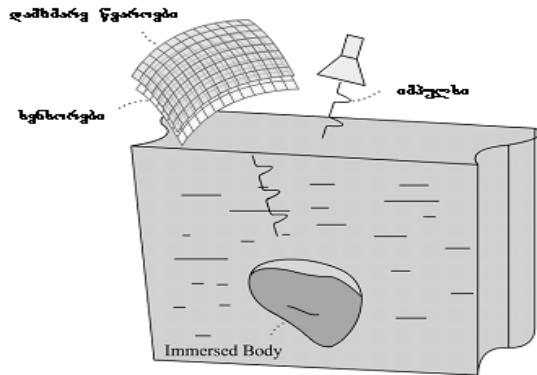
განვიხილოთ სხეულის ზედაპირის აღდგენის შემთხვევები. წინა შემთხვევებისგან ეს იმით განსხვავდება, რომ აქ სხეული პასიური გამომსხვებელია ანუ მასზე ეცემა იმპულსი, რომელსაც ასხივებს რუპორული ანტენა. სეგმენტზე ვზომავთ სხეულიდან არეავლილ ველს (ნახ. 2.19).



ნახ. 2.18

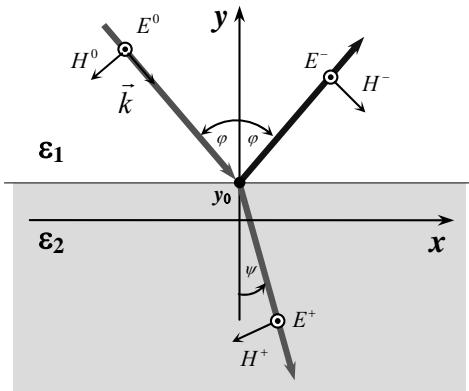
სამი წყაროს ველის აღდგენა

ა)რეალური ველი წყაროთა ახლო მიდამოში ველი განულებულია ბ)აღდგენილი



ნახ. 2.19  
ამოცანის დასტანი

ნახ. 2.19-ზე წარმოდგენილია მოდელი იმისა, თუ როგორ ვახდენთ ჩაძირული სხეულის ვიზუალიზაციას. დაცემული იმპულსი უნდა შეიცავდეს ისეთ სიხშირეებს, რომლისთვისაც მიწა მეტ-ნაკლებად გამჭვირვალეა. ასეთი იმპულსის შერჩევის შემთხვევა ზემოთ უკვე განხილული იყო. იმპულსი, რომელსაც ასხივებს რუპორული ანტენა, ნაწილობრივ ირეკვლება დედამიწის ზედაპირიდან, ნაწილი აღწევს მიწის სიღრმეში და ირეკვლება მიწაში არსებული არა- ერთგვაროვნებიდან. შემდეგ არეკვლილ ველს ვზომავთ გასაზომ ზედაპირზე მოთავსებულ სენსორებში. გაზომილ იმპულსებს ვშლით ფურიე სპექტრად და თოთოეულ სპექტრალური კომპონენტისთვის ვახდენთ ველის მნიშვნელობების აღდგენას სასურველ არეში;



$$E^0 = E_0 \exp(-ik(x \sin \varphi - (y - y_0) \cos \varphi))$$

$$E^- = E_0 \rho_\perp \exp(-ik(x \sin \varphi + (y - y_0) \cos \varphi))$$

$$E^+ = E_0 \tau_\perp \exp(-ik(x \sin \psi + (y - y_0) \cos \psi))$$

ნახ. 2.20

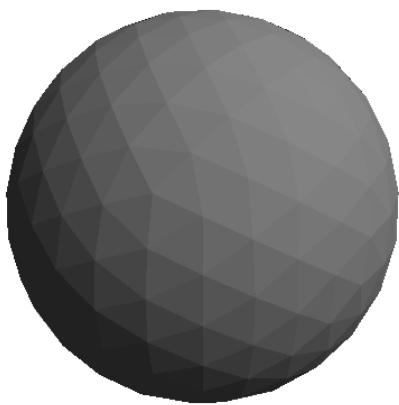
2 გარემოს გამყოფ ზედაპირი  
დაცემული არეკვლილი და გარდატებილი სხივები

$$P(y) = \int_{k_1}^{k_2} |E^0 + E^-|^2 dk = E_0^2 (k_2 - k_1) \left( 1 + \rho_\perp^2 + 2\rho_\perp \frac{\sin \alpha}{\alpha} \cos \beta \right) \quad \text{და} \quad \beta = (y - y_0)(k_2 + k_1) \cos \varphi$$

$$\min[P(y)] = E_0^2 (k_2 - k_1) (1 + \rho_\perp)^2 = P(y_0) \quad \rho_\perp < 0 \quad (\varepsilon_2 > \varepsilon_1) \quad \alpha = (y - y_0)(k_2 - k_1) \cos \varphi$$

$$\max[P(y)] = E_0^2 (k_2 - k_1) (1 + \rho_\perp)^2 = P(y_0) \quad \rho_\perp > 0 \quad (\varepsilon_2 < \varepsilon_1)$$

შემდეგ აღდგენილ ველს ვამატებთ დაცემულ ველს და მის აბსოლუტურ მნიშვნელობებს ვკრიბავთ თითოეული სპექტრალური კომპონენტებისთვის. მათემატიკურად შეგვიძლია დავამტკიცოთ, რომ სრულ ველს მინიმუმი აქვს სხეულის ზედაპირზე. ამის მათემატიკური დასაბუთებას აქვს შემდეგი სახე.

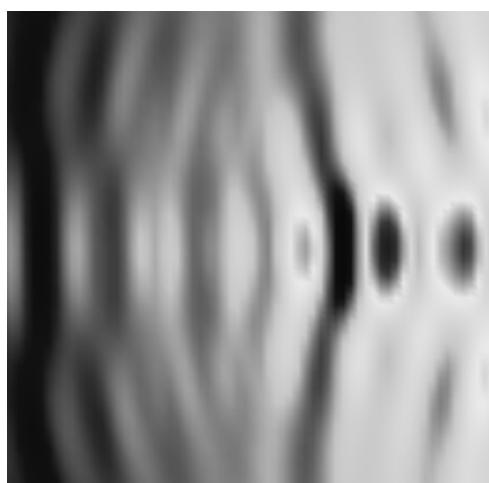


ნახ. 2.21  
სფეროს გეომეტრია  
 $R = 1\text{d}; \varepsilon = 3.0; \mu = 1.0$

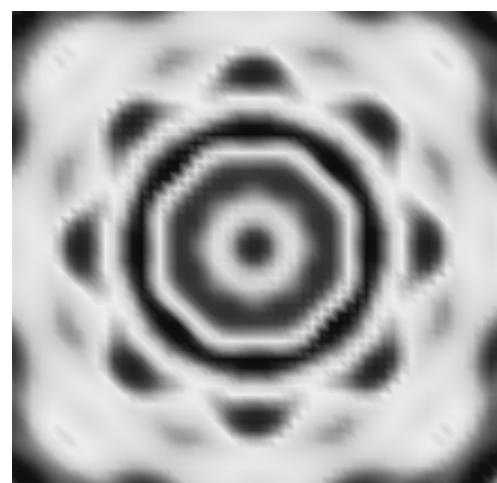


ნახ. 2.22  
სფერული სენსორული სეგმენტი

განვიხილოთ სფეროს ზედაპირის აღდგენის შემთხვევა. ნახ. 2.21-ზე მოცემულია სფეროს გეომეტრია. როგორც ნახაზზე ჩანს, სფერო სამკუთხედებად არის დაყოფილი. ასეთი სახით მოცემული გეომეტრიის დამუშავება გაცილებით მარტივია. მოცემულ სფეროზე ეცემა იმპულსი და შემდეგ ხდება სფეროდან არეალის გელის რეგისტრირება (ნახ. 2.22) სეგმენტზე. ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია აღვადგინოთ სფეროს ზედაპირის გარკვეული ნაწილი. ნახ. 2.23-ზე წარმოდგენილია სწორედ ამ ნაწილის აღდგენის სურათი. სურათზე არსებული გელის მინიმუმი შეესაბამება სფეროს ზედაპირს.



ნახ. 2.23  
სფეროს ზედაპირის ნაწილობრივი აღდგენა

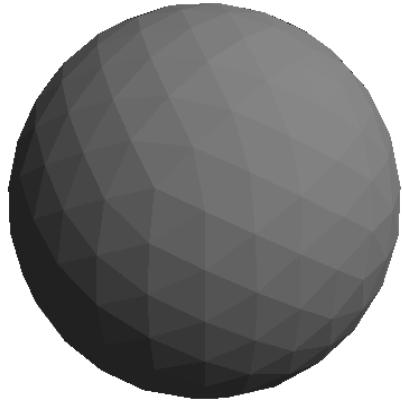


ნახ. 2.24  
სფეროს ზედაპირის სრული აღდგენა

თუ სფეროს დავასხივებთ რამოდენიმე ქსრიდან და შემდეგ თითოეული შემთხვევისთვის აღვადგენოთ მის ზედაპირს, ამ აღდგენილ ველთა სუპერპოზიცია მოგვცემს ნახ. 2.24-ზე გამოსახულ სურათს. ეს სურათი წარმოადგენს 8 სხვადასხვა ქსრიდან აღდგენილი სფეროს ზედაპირის ზედდებას ისე, რომ

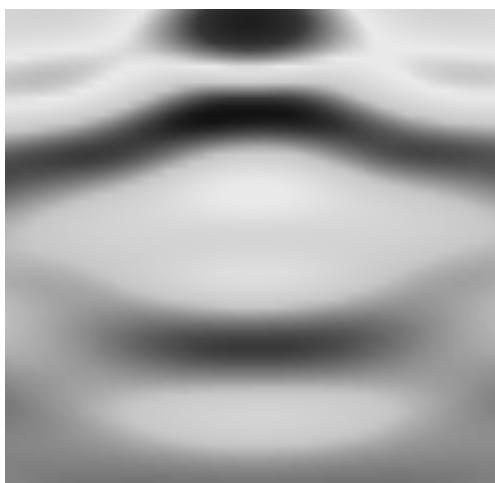
საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით ხდებოდა წყაროს და სეგმენტის შემობრუნება 45 გრადუსით.

განვიხილოთ მეორე სფეროს ზედაპირის აღდგენის შემთხვევა. ეს სფერო წინა შემთხვევისაგან იმით განსხვავდება, რომ მისი დიელექტრიკული შეღწევადობა უფრო ნაკლებია (ნახ. 2.25).

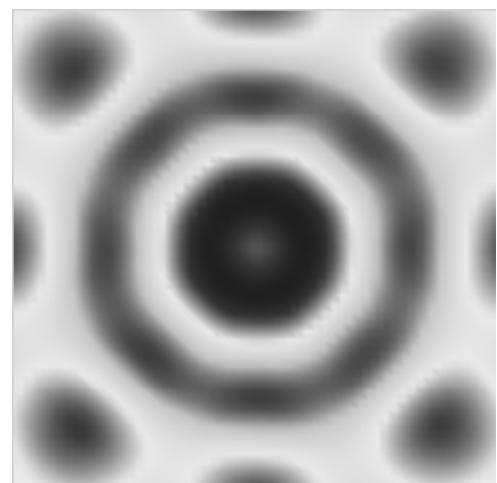


**ნახ. 2.25**  
სფეროს გეომეტრია  
 $R = 1\text{d}$ ,  $\varepsilon=6.0$ ,  $\mu = 1.0$

თუ მოცემული სფეროსთვის გავიმეორებთ იგივე პროცედურას, ანუ აღვადგენთ მისი ზედაპირის ნაწილს სხვადასხვა მხრიდან და შემდეგ მოვახდენთ მათ სუპერპოზიციას, მივიღებთ შემდეგ სურათებს (ნახ. 2.26).



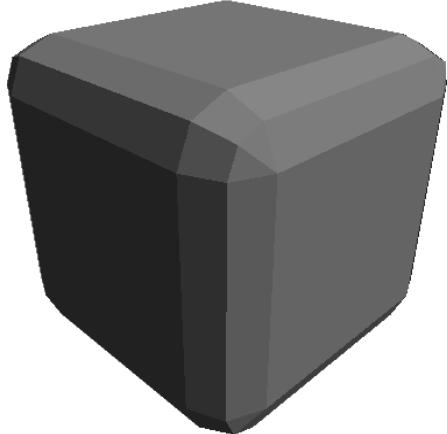
ა)



ბ)

**ნახ. 2.26**  
ა) სფეროს ზედაპირის ნაწილობრივი აღდგენა  
ბ) სფეროს ზდაპირის სრული აღდგენა

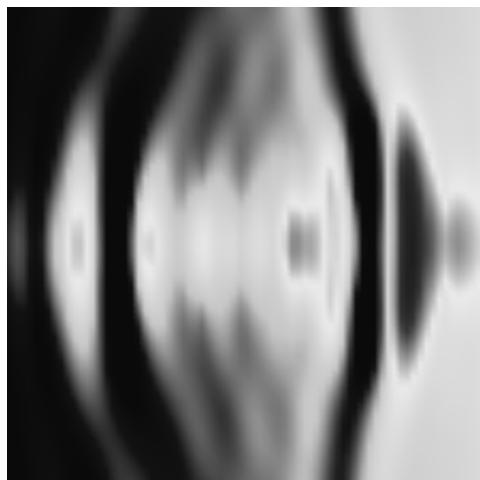
ახლა განვიხილოთ უფრო რთული სხეულის ზედაპირის აღდგენა. კერძოთ კუბი, რომლის წიბოები მომრგვალებულია. (ნახ. 2.27)



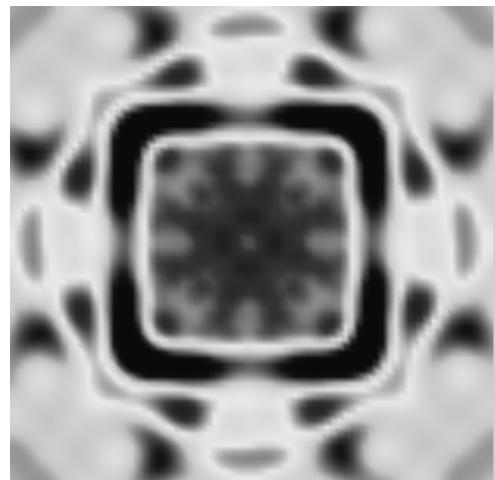
ნახ. 2.27

მომრგვალებულ წიბოებიანი კუბის გეომეტრია  
განზომილება:  $4\delta \times 4\delta \times 4\delta$ ;  $\epsilon=6.0$ ;  $\mu=1.0$

ჩვეულებისამებრ ვათავსებოთ წყაროს შორ მანძილზე. ამით უზრუნველვყოფთ იმას, რომ სხეულზე დაცემული ტალღა ბრტყელია. მისგან არეკვლილ ველს კი ვზომავთ სეგმენტზე (ნახ. 2.22). ერთჯერადი აღდგენის შედეგად მიიღება შემდეგი სურათი (ნახ. 2.28). აქ ჩანს კუბის სიბრტყით კვეთის მხოლოდ ნაწილის აღდგენა, რომელიც სურათზე მოცემულია შავი ზოლის სახით.



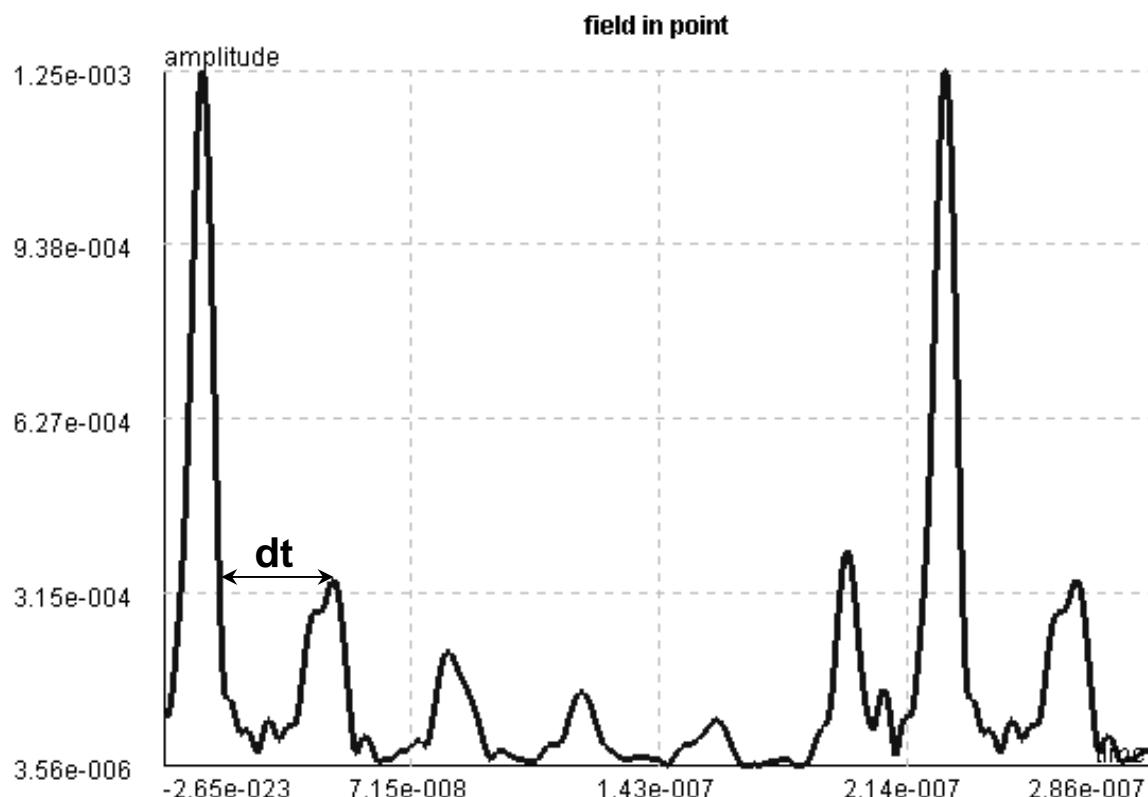
ნახ. 2.28  
კუბის ზღაპრის ნაწილობრივი  
აღდგენა



ნახ. 2.29  
კუბის ზღაპრის სრული აღდგენა

ნახ. 2.29 - კი გვიჩვენებს ამ კვეთის სრულ აღდგენას. აღდგენა შეიძლება მოვახდინოთ კუბის სხვა სიბრტყით კვეთისთვისაც და ამით უზრულველვყოთ მისი ზედაპირის სრული აღდგენა.

დაგუბრუნდეთ ისევ სფეროს აღდგენის შემთხვევას. ამჯერად გავზომოთ სფეროდან არეკვლილი კელი ერთ რომელიმე სფეროდან მოშორებულ წერტილში. მივიღებთ პერიოდულ იმპულსს, რომელიც გამოსახულია ნახ. 2.30-ზე. მოცემულ სურათზე ჩანს სფეროდან იმპულსის მრავალჯერადი არეკვლის შედეგი. კერძოთ, პირველადი იმპულსი ირეკვლება სფეროს წინა ზედაპირიდან, შემდეგ იმპულსი შედის შიგნით და ირეკვლება მისი უკანა ზედაპირიდან – მიიღება მეორადი არეკვლა; ნაშილი მეორადი არეკვლილი იმპულსისა ირეკვლება ისევ

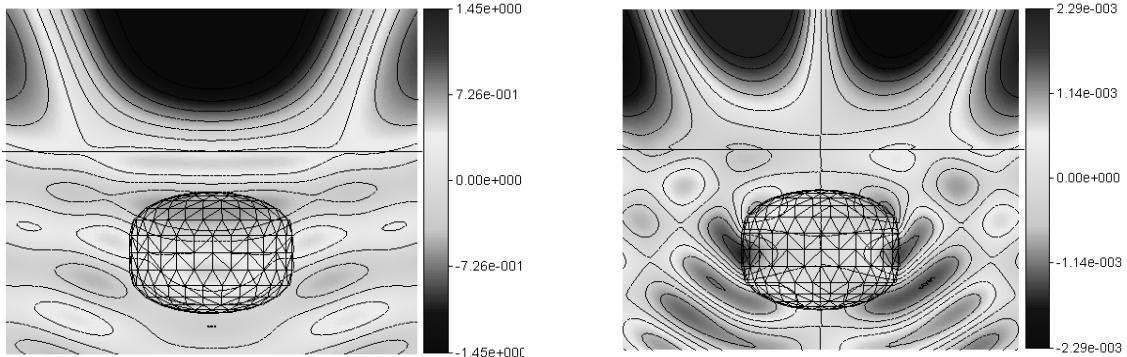


ნახ. 2.30  
სფეროდან არეკვლილი იმპულსის დროზე დამკიდებულება გაზომილი სფეროდან გარკვეულ მანძილზე წირტყილში. ნახაზზე ჩანს სფეროს ზედაპირიდან მრავალჯერადი არეკვლის შედეგი

წინა ზედაპირიდან და ასე შემდეგ, სანამ არ მიიღევა. ნახ. 2.30 მაგალითად ჩანს 5 ჯერადი არეკვლა. დროის ინტერვალი  $dt$  ყოველ ორ მომდევნო არეკვლას შორის გვიჩვენებს თუ რა დროს აყოვნებს ტალღა სფეროს დიამეტრის გასწვრივ მოძრაობას წინ და უკან. თუ ვიცით სფეროს ზომები, მაშინ შევძლებთ დავადგინოთ მისი დიელექტრიკული შედწევადობა, რადგან სფეროს შიგნით იმპულსის გავრცელების სიჩქარე  $v = \frac{c}{\sqrt{\epsilon}}$  არამაგნიტურ გარემო

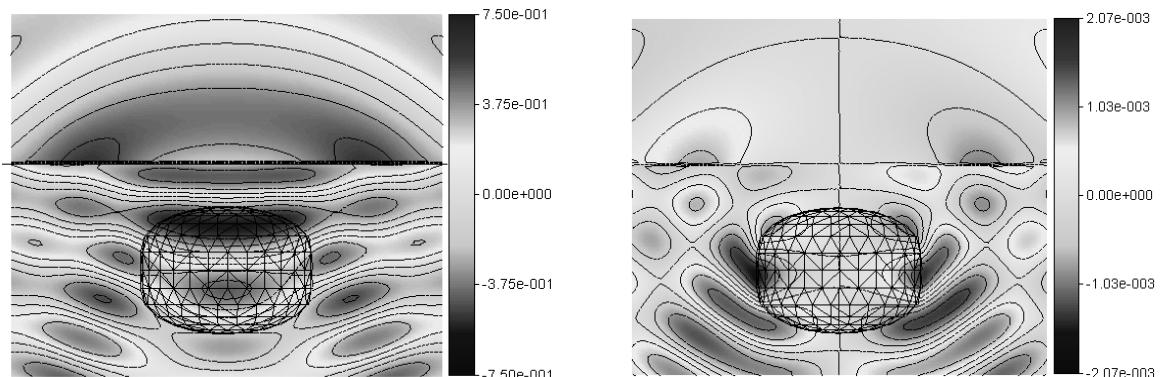
#### §2.4 ჩაძირული სხეულის ზედაპირის აღდგენა

სანამ უშეალოდ ზედაპირის აღდგენის ამოცანაზე გადავიდოდეთ, გავარკვიოთ შესაძლებელია თუ არა ჩაძირული სხეულიდან არეკვლილი ველის გაზომვა და რა რიგისაა იგი.



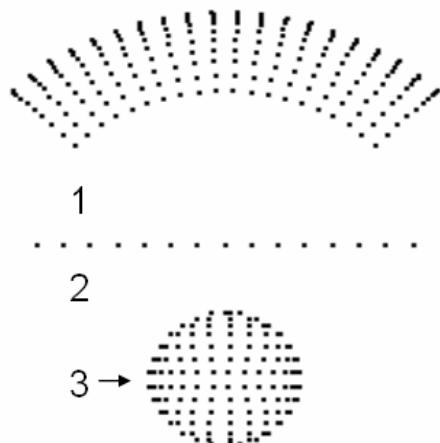
ნახ. 2.31  
 $E_y$  და  $H_z$  ველების განაწილება მიწაში ჩაძირული სხეულის ახლო არეში

ნახ. 2.31-ზე გამოსახულია ჩაძირულ სხეულზე ელექტრომაგნიტური ტალღის დიფრაქციის შედეგად მიღებული ელექტრული და მაგნიტური დაძაბულობის განაწილებათა სურათები. მიწის ზემოთ მოცემულია სრული ველი, ანუ დაცემული და არეკვლილი ველების ჯამი. თუ ჩვენ მოცემული ველის გავრცელებას დავაკვირდებით დინამიურ რეჟიმში, დაცემული ველი საკმაოდ დიდია არეკვლილთან შედარებით; ამიტომ ფაქტიურად მარტო დაცემული ველი ჩანს. მაგრამ თუ მიწის ზემოთ გამოვსახვთ მხოლოდ არეკვლილ ველს, დავინახავთ რომ არეკვლილი ველი არცოუ ისე მცირეა და შეიძლება მისი გაზომვა. ეს შემთხვევა წარმოდგენილია ნახ. 2.32-ზე.



ნახ.2.32  
 $E_y$  და  $H_z$  ველების განაწილება მიწაში ჩაძირული სხეულის ახლო არეში

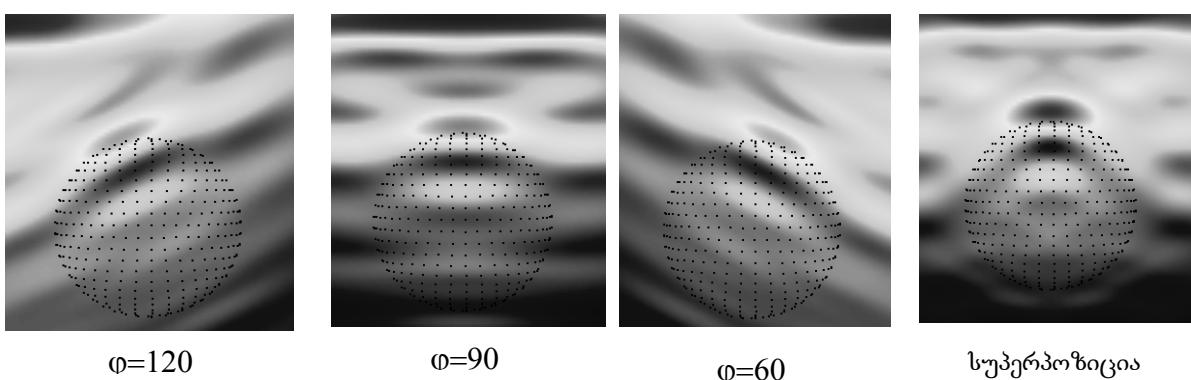
მიწაში ჩაძირული სხეულის მთელი ზედაპირის აღდგენა შეუძლებელია, რადგან ზემოდან ჩანს მხოლოდ წინა ნაწილი. იმის მიხედვით თუ მიწის მიმართ რა კუთხით ვაკვირდებით, დავინახავთ მისი ზედაპირის მხოლოდ ნაწილს. თუ შემდეგ მოვახდენთ სხვადასხვა კუთხიდან გადაღებული სურათების ზედდებას, მივიღებთ ჩაძირული სხეულის ზედაპირის დიდი ნაწილის აღდგენას. ჩვენ განვიხილეთ სხვადასხვა პარამეტრების მქონე მიწაში ჩაძირული სფეროს ზედაპირის აღდგენის მაგალითი. ერთ-ერთი შემთხვევა წარმოდგენილია ქვემოთ.



ნახ. 2.33

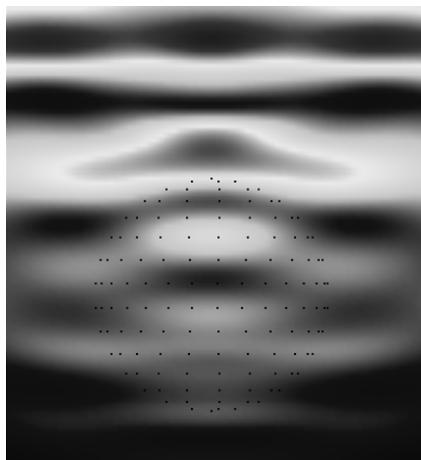
მიწაში ჩაძირული სხეულის და სენსორული სეგმენტის გეომეტრია  
 $\varepsilon_1=1.0$  (ჰაერის),  $\varepsilon_2=1.3$  (მიწის),  $\varepsilon_3=4.0$  (ჩაძირული სხეულის)

ნახ. 2.33-ზე ნაჩვენებია ჩაძირული სფეროს და სენსორული სეგმენტის გეომეტრია, აგრეთვე მიწისა და სფეროს პარამეტრები. მოცემული პარამეტრების მქონე მიწისა და ჩაძირული სფეროსთვის განვიხილეთ სეგმენტის და ელექტრომაგნიტური იმპულსის წყაროს სხვადასხვა მდებარეობა, თითოეული შემთხვევისთვის აღვადგინეთ სხეულის მდებარეობა და შემდეგ მოვახდინეთ მათი ზედდება (ნახ.2.34).

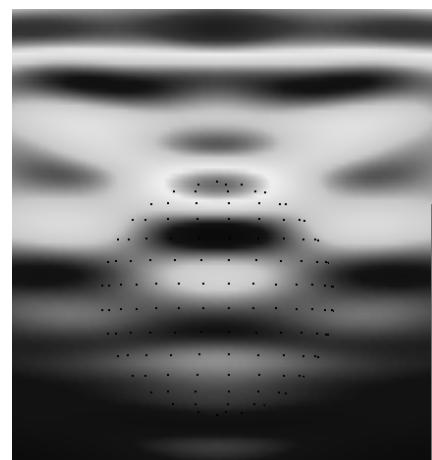


ნახ. 2.34 ჩაძირული სხეულის ზედაპირის აღდგენა სხვადასხვა კუთხით ყურებისას და მათი სუპერპოზიციის შედეგი

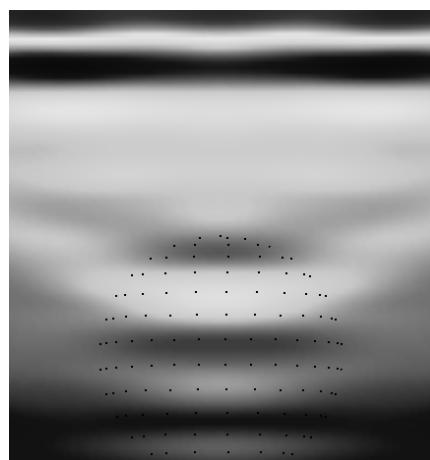
განვიხილოთ როგორ არის დამოკიდებული ჩაძირული სფეროს ზედაპირის აღდგენის ხარისხი მიწის დიელექტრიკულ შეღწევადობაზე. ეს დამოკიდებულება გამოწვეულია იმით, რომ ჩვენ სხეულის ზედაპირის აღდგენისას ვიყენებთ იმ მოვლენას, რომ სრული ველი სხეულის ზედაპირზე გვაძლევს მინიმუმს. ამისთვის სეგმენტზე გაზომილი ველის მნიშვნელობების საშუალებით აღდგენილ ველს უნდა დავადოთ დაცემული ველი, რაც ვაკუუმში მოთავსებული სხეულისთვის ცნობილია. მაგრამ მიწაში მოთავსებული სხეულისთვის ზოგადად უცნობია. ამიტომ ჩაძირული სხეულის შემთხვევაშიც აღდგენილ ველს ვამატებთ დაცემულ ველს ვაკუუმში. ამიტომ მიწის დიელექტრიკული შეღწევადობის ზრდასთან ერთად ცდომილება მოიმატებს. ამ შემთხვევას გამოსახავს ნახ. 2.35-ზე გამოსახული სურათები.



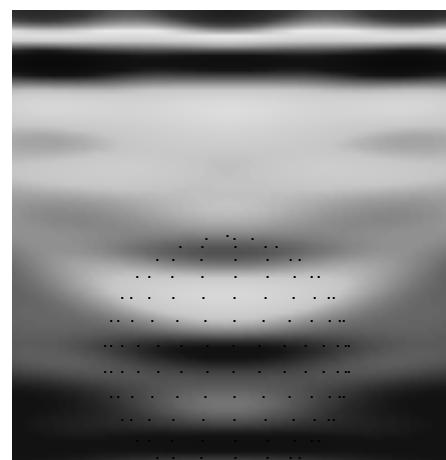
ა)  $\varepsilon_1=1$ ,  $\varepsilon_2=1.1$ ,  $\varepsilon_3=4$



ბ)  $\varepsilon_1=1$ ,  $\varepsilon_2=1.5$ ,  $\varepsilon_3=4$



გ)  $\varepsilon_1=1$ ,  $\varepsilon_2=2$ ,  $\varepsilon_3=5$

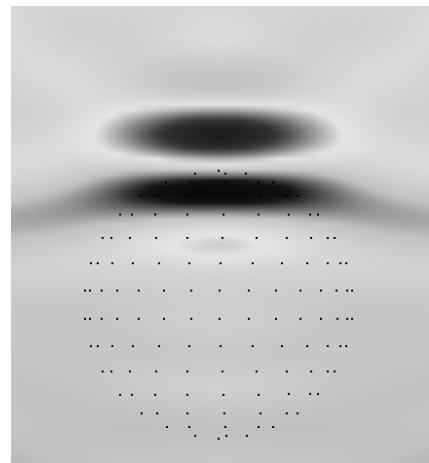


დ)  $\varepsilon_1=1$ ,  $\varepsilon_2=2$ ,  $\varepsilon_3=6$

ნახ. 2.35 ჩაძირული სფეროს ზედაპირის აღდგენა  $\varepsilon_1$ - პარამეტრის დიელექ. შეღწ. ,  $\varepsilon_2$ - მიწის  $\varepsilon_3$ - ჩაძირული სხეულის.

სურათებზე ზედა მინიმუმი შეესაბამება მიწის ზედაპირს, ქვედა კი სფეროს ზემოთა ნაწილს. დიელექტრიკული შეღწევადობის ზრდასთან ერთად აღდგენის სიზუსტე მცირდება, მაგრამ მიწის დიელექტრიკული შეღწევადობა, განსაკუთრებით თუ ის მშრალია, არ არის დიდი და ეს ამოცანა ამ მეთოდის საშუალებით მესამე მიშნის კარგი სიზუსტით იხსნება.

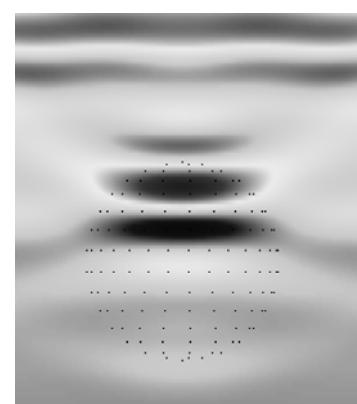
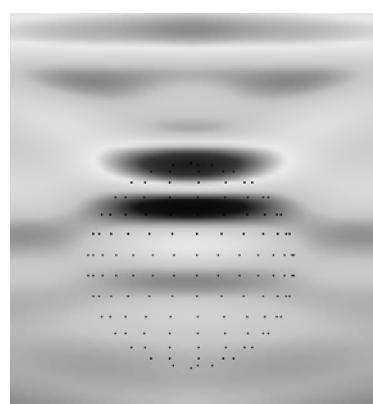
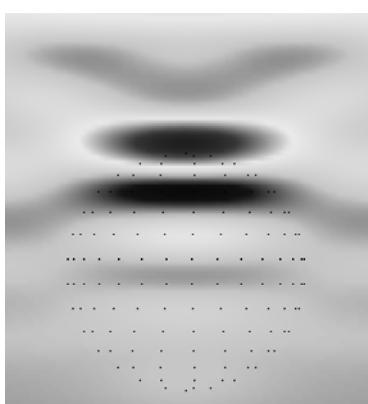
აქამდე განვიხილავდით ჩაძირულ დიელექტრიკულ სფეროს. მოცემული მეთოდი საშუალებას ვაძლევს აღვადგინოთ ჩაძირული მეტალური სფეროს ზედაპირიც; თანაც აღდგენის ხარისხი გაცილებით უკეთესია, რადგან არეკვლილი ველი გაცილებით მეტია.



ნახ. 2.36

**თავისუფალ სივრცეში მოთავსებული  
მეტალური სფეროს ზედაპირის აღდგენა**

ნახ. 2.36 წარმოადგენს მეტალურ სფეროს ზედაპირის აღდგენას ვაკუუმში. ვიზუალური დაკვირვების თვალსაზრისით საკმაოდ კარგი მინიმუმი მიიღება სფეროს ზედაპირზე. თუ მოცემულ სფეროს მოვათავსებთ დიელექტრიკში, ანუ ჩვენ შემოხვევაში ჩავძირავთ მიწაში, დავინახავთ რომ დიელექტრიკული შეღწევადობის ზრდასთან ერთად ველის მინიმუმი, რომელიც სფეროს მდებარეობას გვიჩვენებს, ქვევით ინაცვლებს (ნახ. 2.37). თუმცა ეს წანაცვლება სფეროს ფარგლებს არ ცილდება.



ა)  $\varepsilon_1 = 1$ ,  $\varepsilon_2 = 1.3$

ბ)  $\varepsilon_1 = 1$ ,  $\varepsilon_2 = 1.5$

გ)  $\varepsilon_1 = 1$ ,  $\varepsilon_2 = 2$

ნახ. 2.37

**ჩაძირული მეტალის ზედაპირის  
აღდგენა**

## §2.5 სეგმენტზე ველის ინტერპოლაცია

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ჩაძირული სხეულის ვიზუალიზაციისათვის საჭიროა სფერულ სეგმენტები, რომელიც მოთავსებულია მიწის ზემოთ, გაიზომოს ველის მნიშვნელობები და შემდეგ მოხდეს ველის აღდგენა გაზომილი ველის მნიშვნელობების საფუძველზე. აღდგენის წინასწარ არჩეული მაღალი სიზუსტის სიზუსტის მისაღებად საჭიროა ველი გაიზომოს საკმაოდ ბევრ წერტილში. ჩვენს ამოცანაში ეს რიცხვი უდრის 121-ს; მაგრამ რეალურად ამის განხორციელება მეტად მოუხერხებელია, რადგან თითოეულ წერტილში ველის გაზომვისთვის გვჭირდება თითო ხელსაწყო - სულ დაგვჭირდება 121. ასეთი გამზომი ხელსაწყოები საკმაოდ ძვირია, და ეს პრობლემაც რომ არ არსებობდეს, 121 ხელსაწყოს ტრანსპორტირება იმისათვის, რომ გამოკვლეულ იქნას მიწის სხვადასხვა უბანი, მეტად მოუხერხებელია. მეტად მნიშვნელოვნი და აუცილებელია, რომ მოხდეს ამ რაოდენობის მინიმიზაცია. ამ პრობლემის გადასაჭრელად მივმართავთ ველის ინტერპოლაციის მეთოდს, ანუ ხდება ველის მნიშვნელობების გაზომვა სეგმენტზე მცირე რაოდენობის წერტილებში, და შემდეგ იმ დაშვებით, რომ ველი იმ სეგმენტის



აღდგენილი ველი ინტერპოლაციის გარეშე  
წერტილების რაოდენობა: 11x11

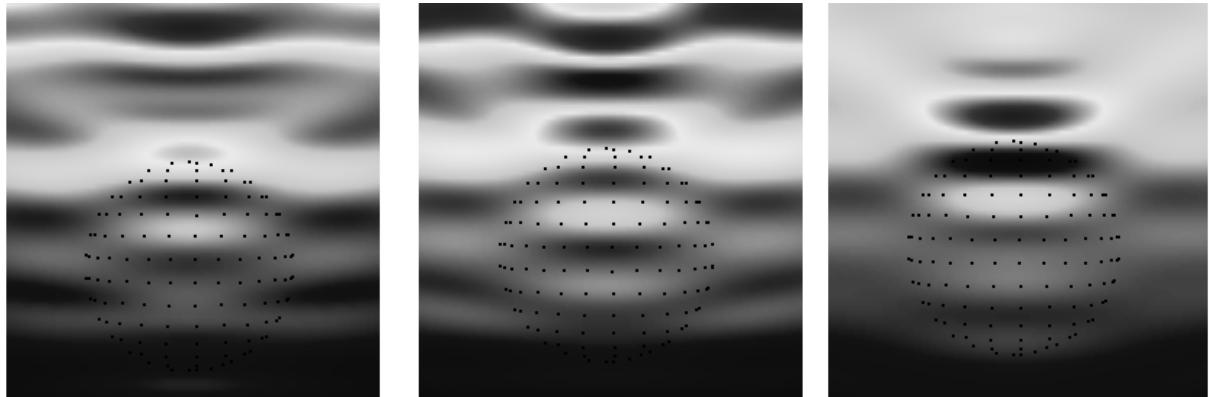


აღდგენილი ველი ინტერპოლაციით  
წერტილების რაოდენობა: 6x6

ნახ. 2.38  
სეგმენტზე ველის ინტერპოლაცია

გასწვრივ რომელზეც გაზომვა ხდება, მცირედ იცვლება, ვახდენთ მის ინტერპოლაციას – იგივე აპროქსიმაციას. ნახ. 2.38-ზე წარმოდგენილია 121 სენტიმეტრის საშუალებით ველის აღდგენა და შემთხვევა, როცა გვაქვს მხოლოდ 36 წყარო; ოღონდ შემდეგ მოვახდინეთ ველის ინტერპოლაცია. როგორც სურათებიდან ჩანს დამთხვევა საკმაოდ კარგია. ჩვენ არ შევჩერდით წერტილების აღნიშნულ რაოდენობაზე და შევამცირეთ: კერძოდ, გავიხილეთ 25, 9 წერტილის შემთხვევები; და ბოლოს ვაჩვენეთ, 4 წერტილისთვისაც კიდევ სრულიად

დამაკმაყოფილებლად შეიძლებოდა გელის აღდგენა. ეს შემთხვევები წარმოდგენილია ნახ. 2.39-ზე.



წერტილების რაოდენობა 5X5

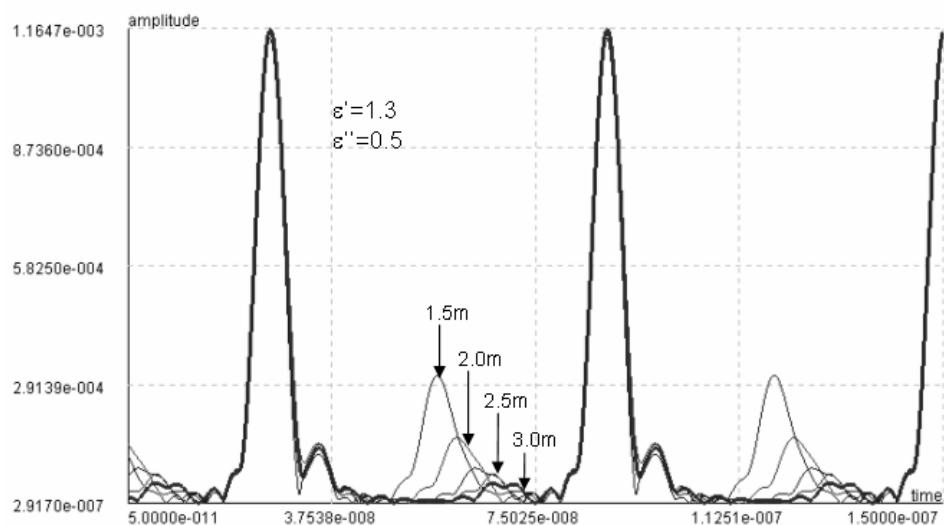
წერტილების რაოდენობა 3X3

წერტილების რაოდენობა 2X2

ნახ. 2.39  
ველის აღდგენა ინტერპოლაციით

## §2.6 მიწის შთანთქმის უნარიანობის დამოკიდებულება სხეულის ჩაძირვის სიღრმეზე

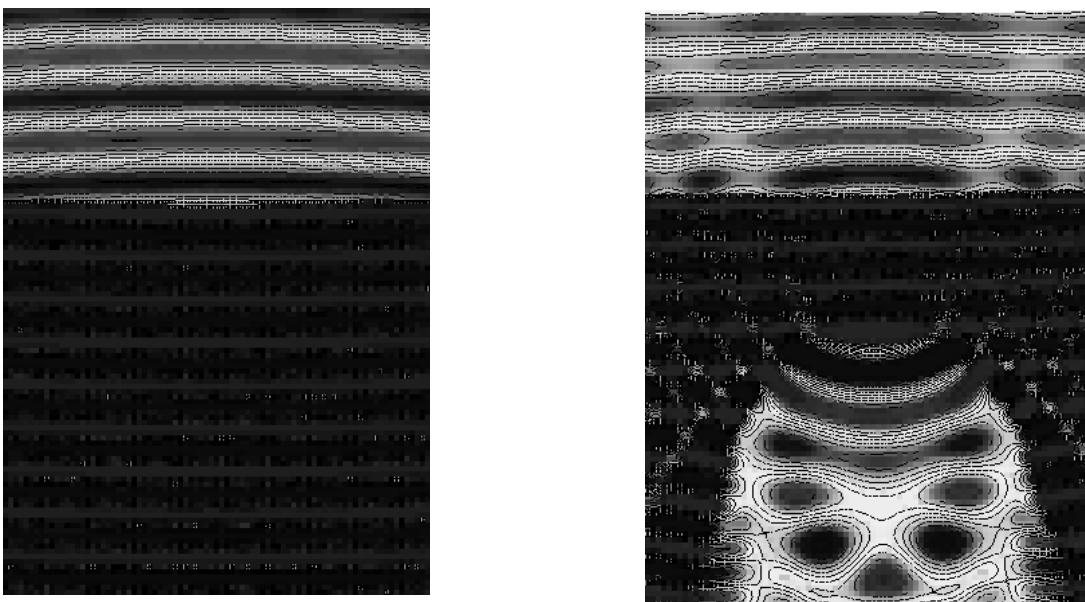
როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, მიწას ვასხივებთ იმპულსით, რომლის სპექტრიც მდებარეობს იმ უბანში, რომლისთვისაც მიწა მეტ-ნაკლებად გამჭვირვალეა. ამ დიაპაზონშიც კი მიწას გარკვეული შთანთქმა მაინც გააჩნია. ამიტომ რაც უფრო დრმად არის სხეული, მით მეტი მანძილის გავლა უხდება იმპულსს და მით მეტად მიიღევა.



ნახ. 2.40  
არეკვლილი იმპულსის დამოკიდებულება  
სხეულის მიწაში ჩაძირვის სიღრმეზე

ნახ. 2.40-ზე წარმოდგნილია მიწის ზემოთ მოთავსებულ სენსორში გაზომილი მიწიდან არეკვლილი იმპულსის დროზე დამოკიდებულების გრაფიკთა ოჯახი, მიწაში სხეულის სხვადასხვა სიღრმეზე ჩაძირვის შემთხვევისათვის. სურათზე პირველი პიკი შეესაბამება მიწიდან არეკვლილ იმპულსს, ხოლო მეორე კი სხეულიდან არეკვლილს. როგორც სურათზე ჩანს, მეორე პიკის სიმაღლე მცირდება ჩაძირვის სიღრმის მატებასთან ერთად და 3 მეტრის შემდეგ, ფაქტიურად ხმაურის დონეზეა. გრაფიკები აგებულია  $\varepsilon = 0.5$ -ის შემთხვევისთვის. ეს არცოუ ისე მცირე შთანთქმაა, რაც იძლევა შესაძლებლობას, რომ რეალურ შემთხვევაში უფრო დრმად არსებულ ობიექტებსაც დავაკვირდებით.

როდესაც ელექტრომაგნიტური ტალღა ეცემა მიწას, ნაწილი ენერგიისა აირეკლება მისგან, ნაწილი კი აღწევს მიწის შიგნით და ირეკლება მიწაში არსებული არაერთგვაროვნებებიდან. ჩაძირული სხეულის ზედაპირის ადგენისათვის, ცხადია რომ არეკვლილ იმპულსში, მიწის წიაღის არაერთგვაროვნებებიდან არეკვლილი წვლილი არ უნდა იყოს ძალიან მცირე მიწის ზედაპირიდან არეკლვილთან შედარებით, რათა მოხერხდეს მისი გაზომვა.

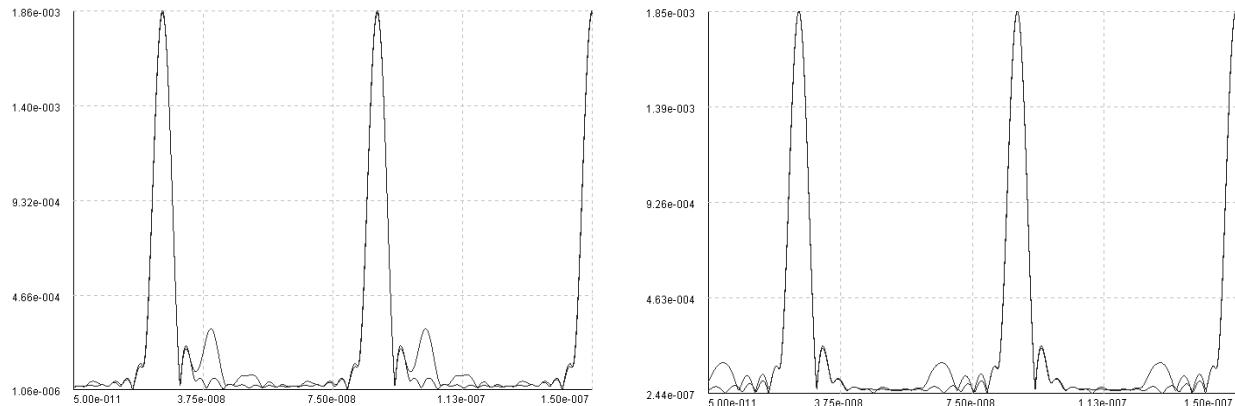


ნახ. 2.41  
არეკვლილი ველის სურათი ერგვაროვანი მიწიდან (მარცხნივ) და მიწაში მოთავსებული სფერული სიღრუდან

ნახ. 2.41-ზე წარმოდგენილია მარცხნივ ერთგვაროვანი მიწიდან არეკვლილი ველის სურათი; ხოლო მარჯვნივ იგივე სურათი, როდესაც მიწაში გვაქვს სფერული სიღრუე. სურათზე ნათლად ჩანს, რომ სფერული სიღრუის შემთხვევაში მიწიდან არეკვლილ ველი განსხვავდება შემთხვევისგან, როცა მიწა არაერთგვაროვანია (ნახაზზე არეკვლილი ველი მოცემულია სურათის ზემო ნაწილში, მიწის გამყოფი ზედაპირის ზემოთ).

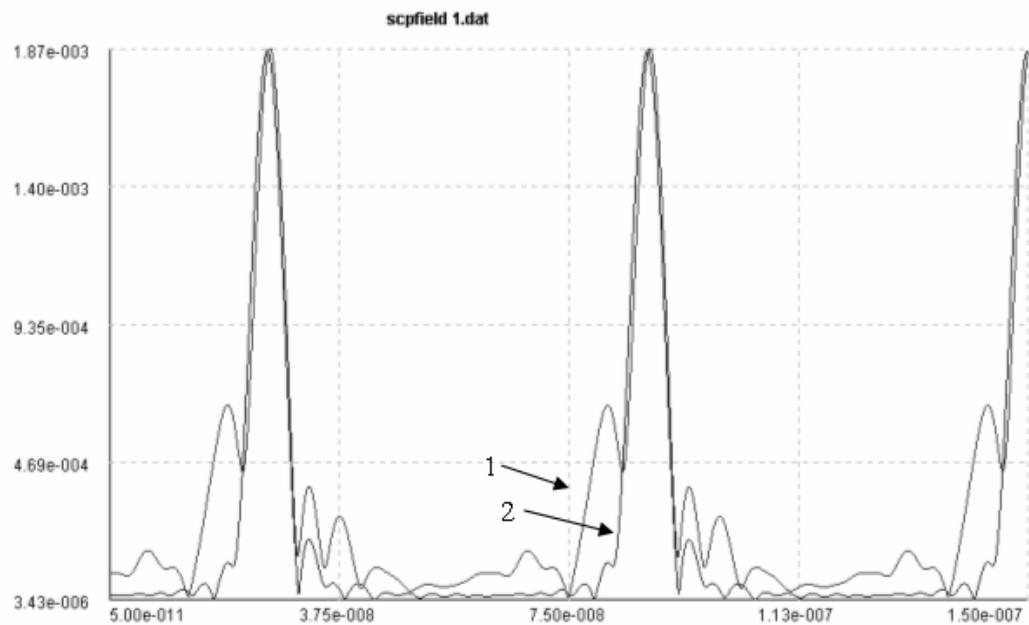
იგივე შედეგი ნათლად ჩანს იმპულსის არეკვლის დროს: თუ მიწის ზემოთ რომელიმე წერტილში გავზომავთ არეკვლილ ველს, ზემოთ აღიშნული ორი შემთხვევისთვის განსხვავება აშკარა შეიქმნება. ეს კარგად ჩანს ნახ. 2. 42-ზე: მარცხნივ წარმოდგენილია 2 გრაფიკი – პირველი შეესაბამება ერთგვაროვანი მიწიდან იმპულსის არეკვლას; მეორე კი იმპულსის არეკვლას, როდესაც მიწაში მოთავსებულია სფერული სიღრუე – ამ შემთხვევისთვის გრაფიკზე ჩნდება

მეორე პიკი, რომელიც შეესაბამება სფერული სიღრუეიდან არეკვლას, მიწიდან არეკვლის შესაბამისი პირველი პიკი კი ამ ორივე შემთხვევაში ერთმანეთს ემთხვევა. თუ სფერულ სიღრუეს მოვათავსებთ უფრო დრმად, მაშინ გრაფიკზე მეორე პიკი წაინაცვლებს მარჯვნივ (ნახ. 2.42 მარჯვნივ).



**ნახ. 2.42**  
მიწიდან არეკვლილი იმპულსის დროზე  
დამოკიდებულება

თუ სფერულ სიღრუეს შევცვლით სფერული დიელექტრიკით, მაშინ არეკვლილი ველი ასევე შეიცვლება. ეს მოსალოდნელიცაა, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერ განვასხვავებდით რა ობიექტია მიწის შიგნით, ანუ აქედან გამომდინარე – სხვადასხვა ფორმის, ზომის, მდებარეობისა და დიელექტრიკული შეღწევადობის მქონე ჩაძირულ ობიექტს განსაზღვრული არეკვლილი იმპულსი შეესაბამება; მაშასადამე თუ შევადგენთ გარკვეულ ბიძლიოთებას სხვადასხვა შემთხვევისთვის, რეალურ ექსპერიმენტზე ერთ წერტილში გაზომილი არეკვლილი იმპულსის საშუალებით განვსაზღვრავთ რა არაერთგვაროვნებაა მიწაში. ნახ. 2.43-ზე წარმოდგენილია ზემოთ აღნიშნული ორი შემთხვევისთვის არეკვლილი იმპულსების შედარება.

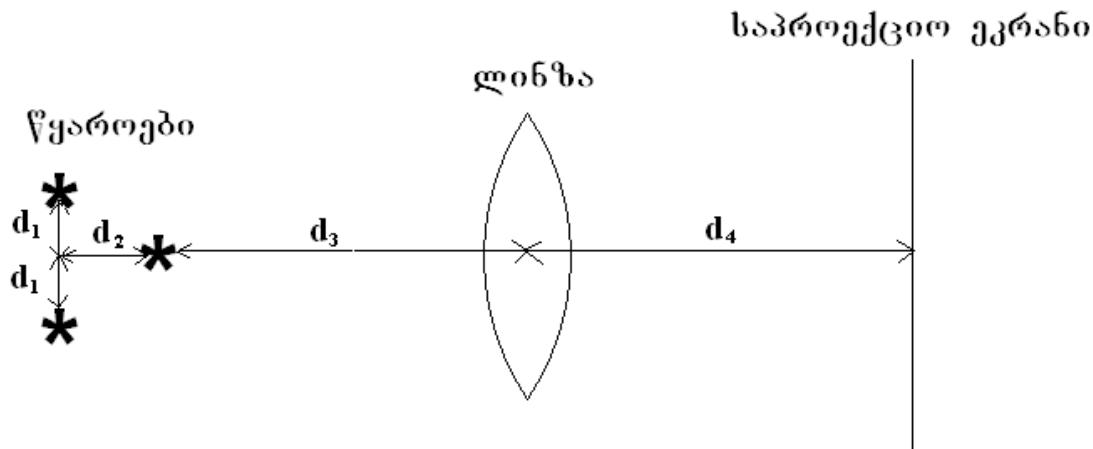


**ნახ. 2.43**  
მიწიდან არეალილი იმპულსების შედარება  
1. მიწაში არსებული სფერული სიღრუიდან  
2.მიწაში არსებული დიელექტრიკიდან

### თავი III შებრუნებული ამოცანების ამოხსნა ფოტოგრაფიული მეთოდის საშუალებით

#### §2.7 ლინზის თვისებების გამოკვლევა

ზემოთ ჩვენ განვიხილეთ ფოტოგრაფიული მეთოდი, როგორც დამხმარე გამომსხივებლის მეთოდის კერძო შემთხვევა. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, გვაქვს ლინზა, რომლის საშუალებითაც ხდება მიწიდან ან სხეულიდან არეკვლილი ვალის ფოტუსირება. გამოვიკვლიოთ მისი თვისებები.



ნახ. 2.44 რამოდენიმე  
წყაროს ფოტუსირება

ვთქვათ გვაქვს სამი წყარო, რომლებიც განლაგებული არიან ნახ. 2.44-ზე ნაჩვენები სახით.

გამოვიკვლიოთ როგორ არის დამოკიდებული გამოსახულება წყაროთა მდებარეობაზე და ურთიერთგანლაგებაზე. ჯერ განვიხილოთ შემთხვევა, როდესაც წყაროები განლაგებულია ლინზის სიახლოვეში. ეს შემთხვევა გამოსახულია ნახ. 2.45-ზე. საკმარისია წყაროები ლინზას დავაშოროთ, რომ გამოსახულებაში წყაროთა შორის მანძილი შემცირდება. ეს კარგად ჩანს ნახ. 2.46-ზე.



ნახ. 2.45  
რამოდენიმე წყაროს ფოტუსირება  
 $d_1=1, d_2 = 0.5, d_3 = 4, d_4 = 5$

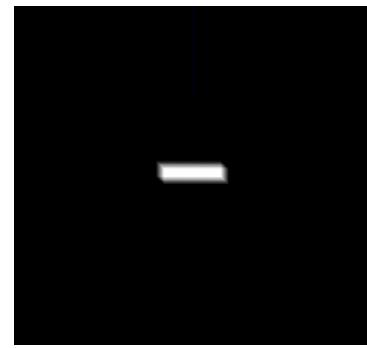


ნახ. 2.46  
რამოდენიმე წყაროს ფოტუსირება  
 $d_1=1, d_2 = 0.5, d_3 = 15, d_4 = 5$

ამ შემთხვევაში ფოკუსური მანძილის ცვლილება აღარ არის საჭირო, რათა სამივე წყარო დაგინახოთ მოცემული ნახაზის



ა)

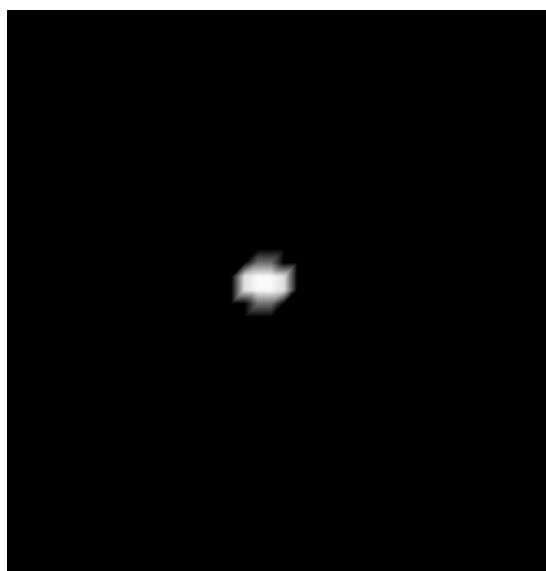


ბ)

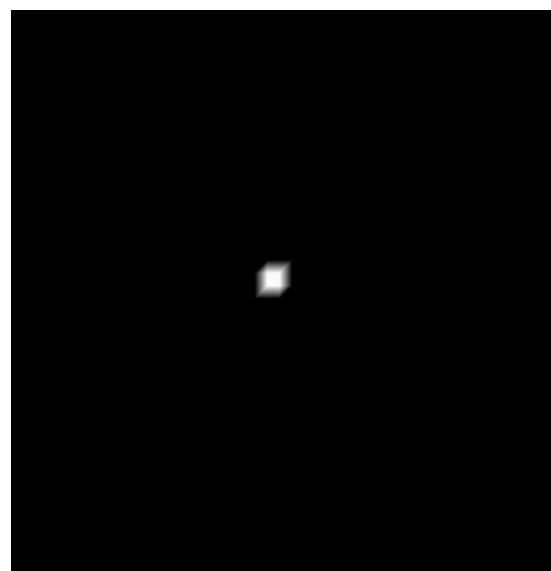
ნახ. 2.47 ერთი წყაროს ფოკუსირება

ა)  $d_3 = 6, d_4 = 6$  ბ)  $d_3 = 6, d_4 = 3$

მართობულ სიბრტყეში; მაშინ როცა წინა შემთხვევაში წყაროთა გამოსახულებები ერთმანეთს დაცილებულია და მიიღება სამივე წყაროს გამოსახულება სხვადასხვა სიბრტყეში. ნახ. 2.47-ზე ნაჩვენებია ერთი წყაროს ფოკუსირების შემთხვევა: ა) შემთხვევაში საპროექციო ეკრანი მოთავსებულია ლინზიდან 6 მეტრის; ხოლო ბ) შემთხვევაში 3 მეტრის მანძილზე. როგორც ნახაზიდან ჩანს, ფოკუსირების ხარისხი (გამოსახულების სიმკვეთრე) მეორე შემთხვევაში უფრო კარგია. ნახ 2.47- ზე ნაჩვენები სიბრტყის მართობულ სიბრტყეში ველის ფოკუსირების სურათი მოცემულია ნახ. 2.48-ზე ორივე ა) და ბ) შემთხვევისთვის:



ა)

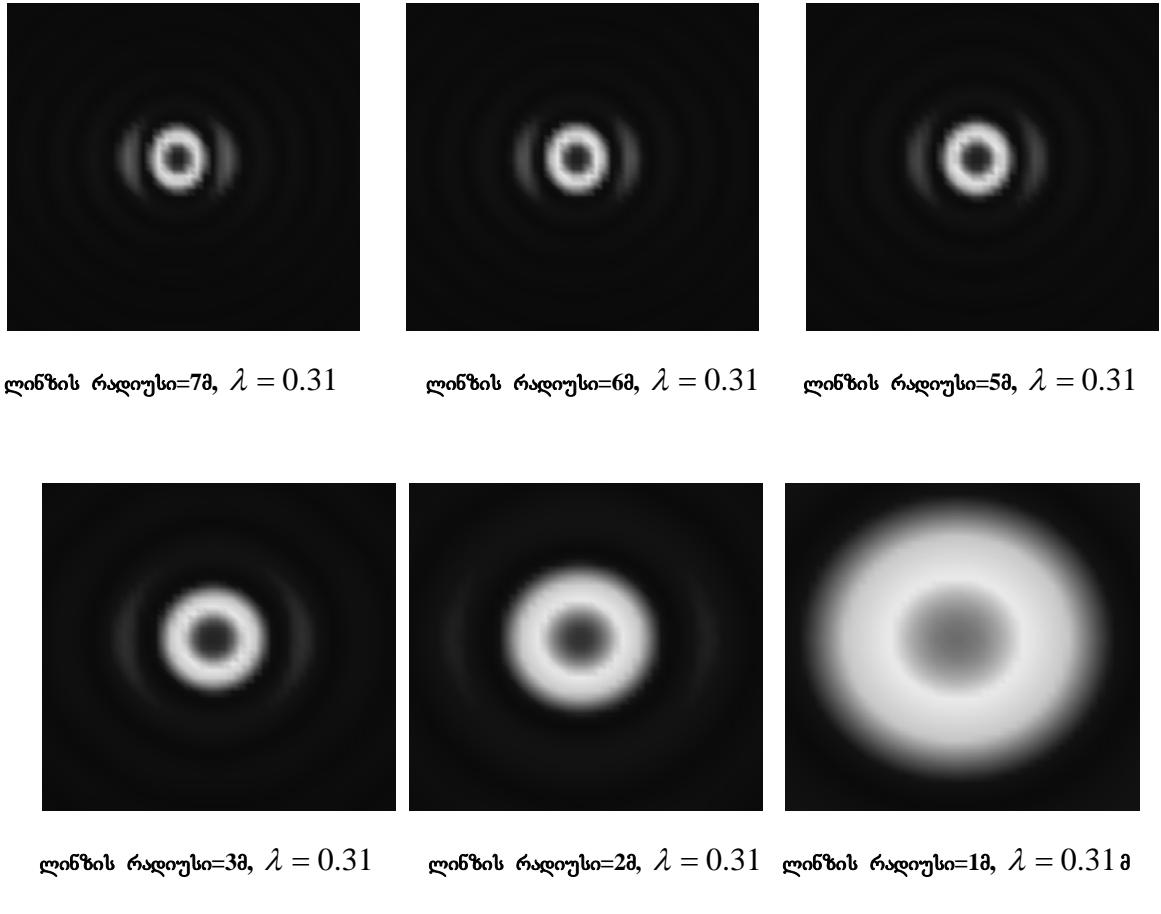


ბ)

ნახ. 2.48 ერთი წყაროს ფოკუსირება

ა)  $d_3 = 6, d_4 = 6$  ბ)  $d_3 = 6, d_4 = 3$

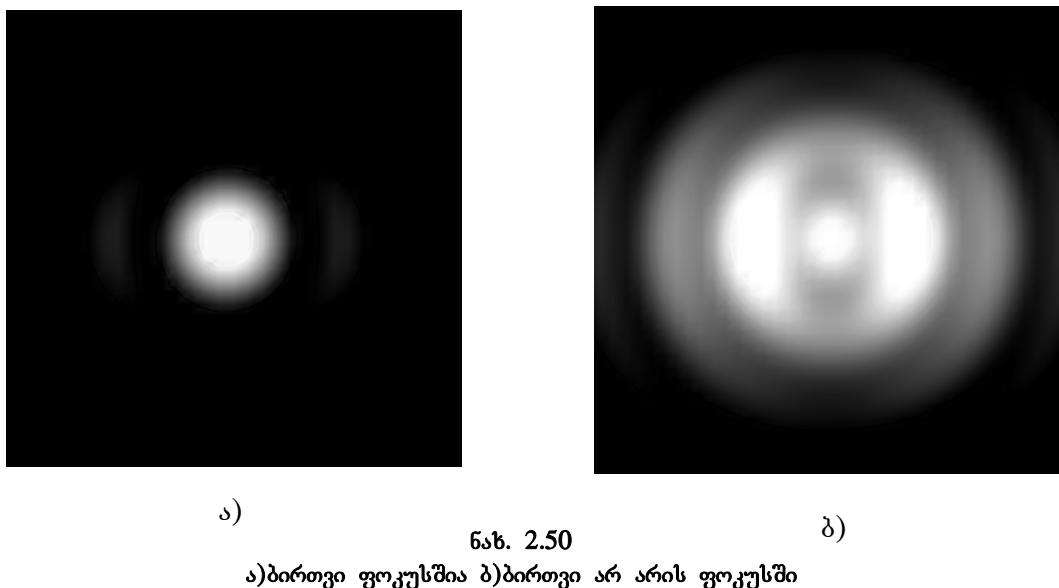
როგორც ნახიდან ჩანს, წყაროს კარგი ფოკუსირებისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს პარამეტრების სწორად შერჩევას. ფოკუსირების ხარისხზე? გავლენას ახდენს აგრეთვე ლინზის ზომა (ნახ. 2.49):



ნახ. 2.49 ფოკუსირების ხარისხის ლინზის ზომაზე  
დამოკიდებულება

## §2.8 სხეულის მდებარეობისა და ზედაპირის განსაზღვრა

განვიხილოთ ბირთვის ზედაპირის აღდგენის მაგალითი ფოტოგრაფიული მეთოდის საშუალებით. ბირთვი მოთავსებულია ლინზიდან 6 მეტრის მანძილზე. მის აღმოსაჩენად ლინზის პარამეტრებს ვარჩევთ ისე, რომ მან მოახდინოს სქანირება 5-დან 7- მეტრამდე დიამეტრში; და თითოეული შემთვევისთვის მოხდეს ველის აღდგენა. საუკეთესო გარჩევადობის, კერძოთ მაღალი გრადიენტის მქონე სურათი შეესაბამება იმ სიბრტყეს, რომელიც კვეთს ბირთვს. დანარჩენ შემთხვევებში სურათი გადღაბნილია.

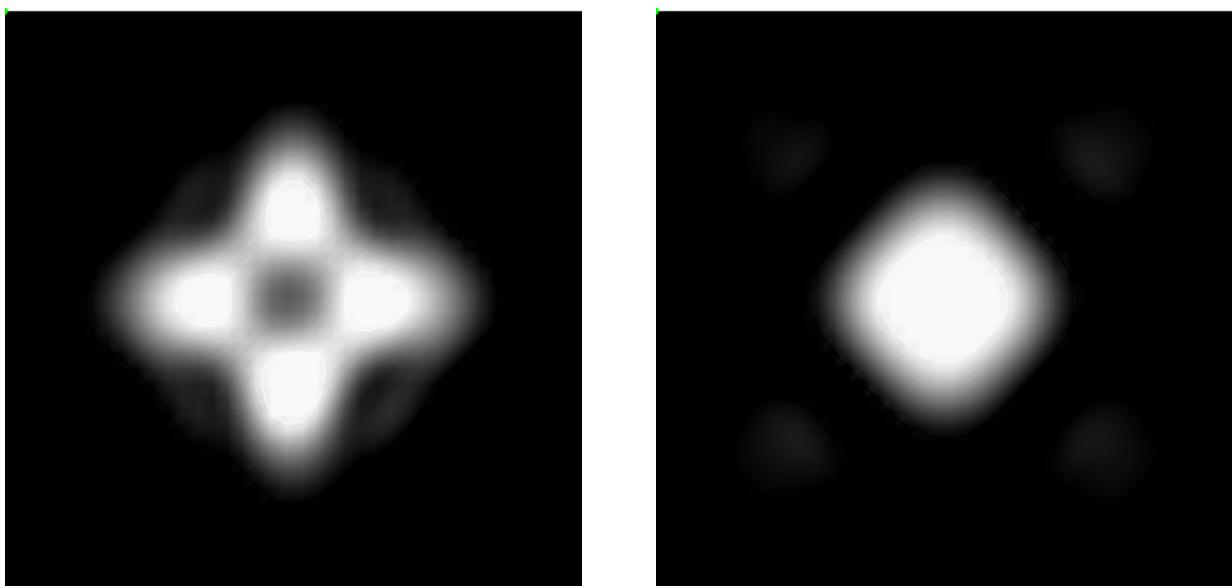


ნახ. 2.50 ა)ბირთვი ფოტუსშია ბ)ბირთვი არ არის ფოტუსში

ნახ. 2.50-ზე წარმოდგენილია ლინზის ზედაპირზე გაზომილი ველის საშუალებით ველის აღდგენის სურათის ორი სხვადასხვა შემთხვევა, როდესაც აღვადგენთ ლინზიდან სხვადასხვა მანძილით დაშორებული სიბრტყის ველებს: ა) შემთხვევა შეესაბამება სიბრტყეს, რომელიც კვეთს ბირთვს; ხოლო ბ) შემთხვევაში სიბრტყე ბირთვიდან დაშორებულია 0.5 მეტრით. ნახ. 2.50-ბ) შემთხვევაში გამოსახულება გადღაბნილია და განფენილია საკმაოდ დიდ არეზე – ბირთვის რეალური რადიუსი 0.8 მეტრია, სურათის მასშტაბიდან კი გამომდინარე ბირთვი გაცილებით დიდი ჩანს. ა) შემთხვევაში გამოსახულებაზე კარგად ჩანს ბირთვის კვეთის ფორმაც ანუ წრე და მისი ზომაც – სურათის მასშტაბიდან გამომდინარე ემთხვევა ბირთვის ზომას. რეალურ ექსპერიმენტზე, როდესაც არ ვიცით სხეულის მდებარეობა, მოვახდენთ სკანირებას საკმაოდ დიდ დიაპაზონში მცირე ბიჯით და კომპიუტერი ავტომატურად ამოირჩევს იმ სურათს, სადაც ველის გრადიენტი საკმაოდ მაღალია. ამ უკანასკნელის გამოსათვლელად კი ვპოულობთ ველის მინიმუმსა და მაქსიმუმს შორის სხვაობას. რიცხვითი ექსპერიმენტის საშუალებით ხდება სვადასხვა სირთულის ფორმის მქონე სხეულის ზედაპირის აღდგენა და შემდეგ გადავდივართ ჩაძირული სხეულის მდებარეობის და ფორმის დადგენაზე. მოცემული ალგორითმი წარმატებით მუშაობს ორივე შემთხვევაში. ქვემოთ წარმოდგენილი იქნება ეს შემთხვევები.

## §2.9 კუბის ზედაპირის აღდგენა

განვიხილოთ კუბის ზედაპირის აღდგენის შემთხვევა. ის რომ ამ მეთოდით შესაძლებელია სხეულის მდებარეობის დადგენა, არ არის საკმარისი. სასურველია მოხდეს სხეულის ამოცნობა. ჩვენ ავირჩიეთ კუბი, რომელიც სფეროსთან შედარებით უფრო რთული ფიგურაა – მას აქვს დერძული სიმეტრია. უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ ფოტოგრაფიული მეთოდის შემთხვევაში განვიხილავთ მონოქრომატული ტალღის დაცემას სხეულზე; თუ პოლოგრაფიული მეთოდის შემთხვევაში შეუძლებელი იყო სხეულის მდებარეობის და ფორმის აღდგენა ერთი სიხშირით, აյ ამ შემთხვევაში – ფოტოგრაფიული მეთოდით ერთი სიხშირე საკმარისია. მაგრამ რადგან საბოლოოდ მაინც იმპულსს გამოვიყენებოთ და იმპულსი კი რამოდენიმე სიხშირეს შეიცავს, ფოტოგრაფიული მეთოდის გამოყნება უფრო ზუსტ ინფორმაციას მოგვცემს სხეულის შესახებ. კუბს ვათავსებთ 6 მეტრის მანილზე მიწის სიღრმეში როგორც ეს სფეროს შემთხვევაში იყო. კუბი შემოვატრიალეთ 45 გრადუსით, რადგან რეალურ შემთხვევაში მისი ორიენტაცია შეიძლება ნებისმიერი იყოს. კუბი დიელექტრიკულია და მისი შეღწევადობა  $\varepsilon = 3$ . კუბის კუთხეები მომრგვალებულია რადგან პირდაპირი ამოცანის ამოხსნა უფრო მარტივია. რეალურად კი შესაძლებელია სხეულის ზედაპირი არ იყოს გლუვი. მოცემული მეთოდი, თუ არეკვლილი ველის მნიშვნელობები ცნობილია, შეძლებს აღადგინოს არაგლუვი ზედაპირის მქონე სხეულებიც. ნახ. 2.51-ზე



ა)

ბ)

ნახ. 2.51

კუბის ზედაპირის აღდგენა  
ა) კუბი არ არის ფოკუსში      ბ) კუბი ფოკუსშია

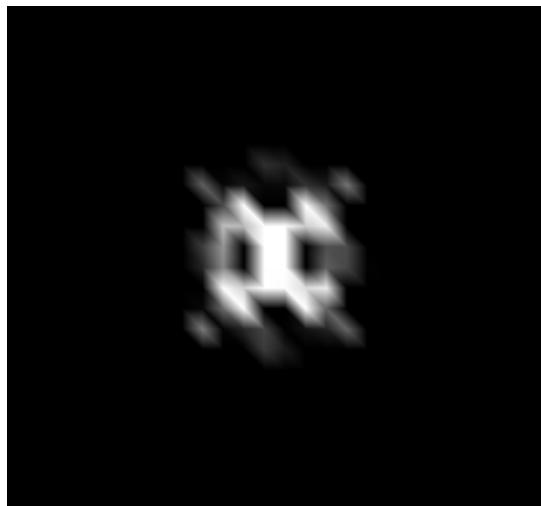
წარმოდგენილია კუბის ზედაპირის აღდგენის შემთხვევა: ა) სურათზე, რომელიც შეესაბამება ლინზიდან 5 მეტრს ანუ კუბიდან მოშორებით, მიიღება გამოსახულება, რომელიც კუბს არ გავს; თუ განვიხილავთ სიბრტყეს ლინზიდან

6 მეტრის მანძილზე, ანუ ეს შეესაბამება სიბრტყეს რომელიც გადის კუბის ცენტრზე, მივიღებთ ბ) სურაოს. ეს უკანასკნელი გამოსახულება იძლევა საშუალებას განვსაზღვროთ რომ სხეული კუბია მომრგვალებული კუთხეებით.

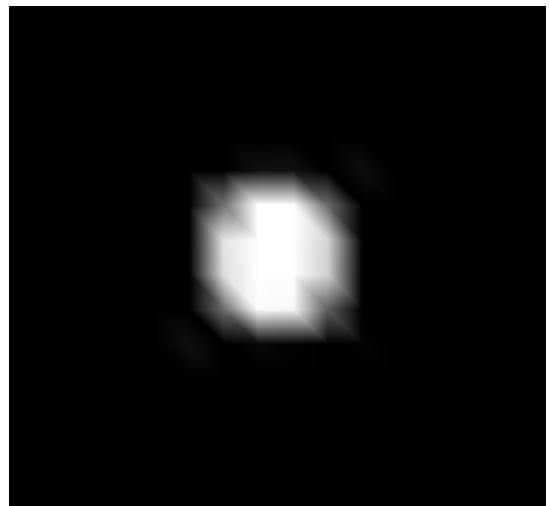
## §2.10 საგნის გარჩევისუნარიანობის დამოკიდებულება ლინზიდან მანძილზე

გამივიკლიოთ როგორ არის დამოკიდებული საგნის გარჩევისუნარიანობა ლინზიდან მანძილზე. მოვათავსოთ სხეული საგნიდან სხვადასხვა მანძილზე 1 დან 11 მეტრამდე დიაპაზონში და ვნახოთ როგორია გარჩევისუნარიანობა.

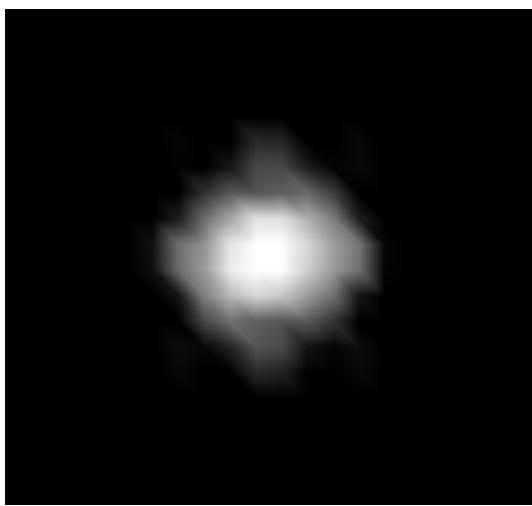
1. ლინზიდან საპროექციო ექრანამდე მანძილი 3მ. ლინზის სიმრუდის რადიუსი 4მ.



ა)ლინზიდან საგნის ცენტრამდე მანძილი 1მ



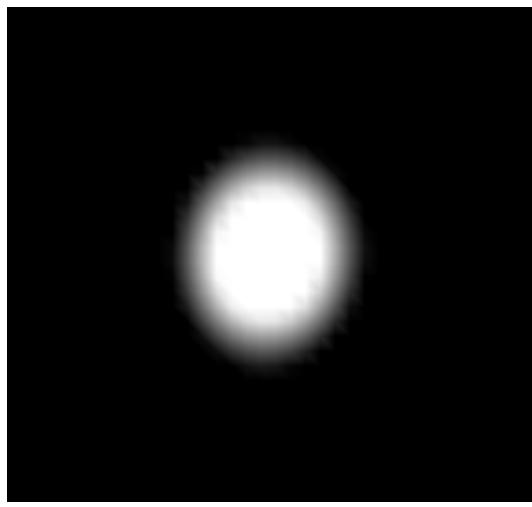
ბ)ლინზიდან საგნის ცენტრამდე მანძილი 3მ



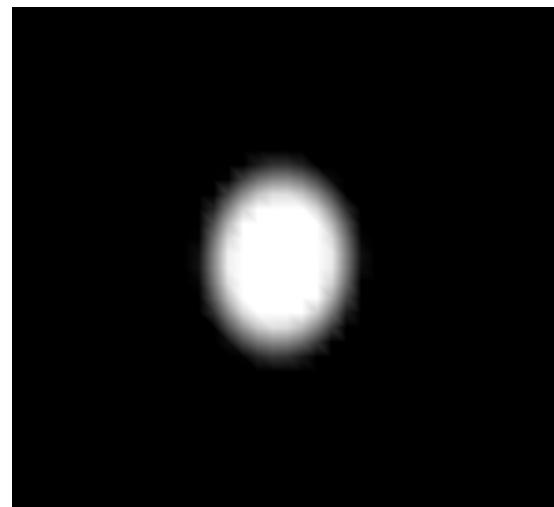
გ)ლინზიდან საგნის ცენტრამდე მანძილი 5მ



დ)ლინზიდან საგნის ცენტრამდე მანძილი 7მ



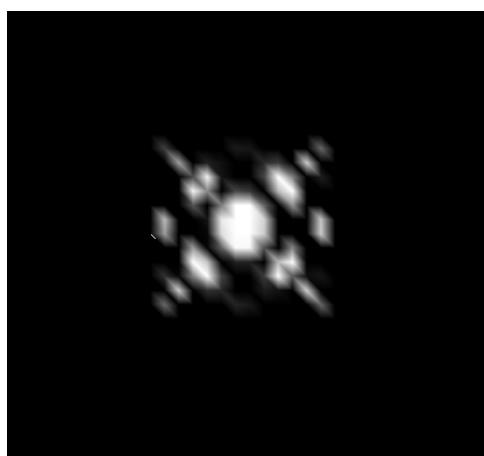
ე)ლინზიდან საგნის ცენტრამდე მანძილი 9მ



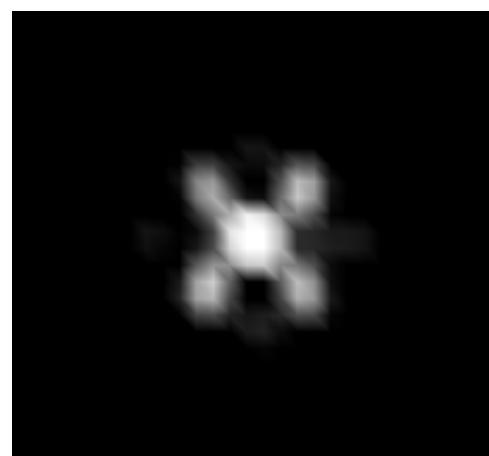
ვ)ლინზიდან საგნის ცენტრამდე მანძილი 11მ

**ნახ. 2.52  
კუბის ზედაპირის აღდგენა**

როგორც ნახ. 2.52-ზე ჩანს, ყველაზე საუკეთესო ვარიანტი არის გ) ანუ როდესაც მანძილი ლინზიდან 5მ-ია. ოუმცა რამდენადმე დამახინჯებულია – მასში შეგვიძლია ამოვიცნოთ კუბი და ის ფაქტი, რომ კუბი 45 გრადუსით არის შემობრუნებული.



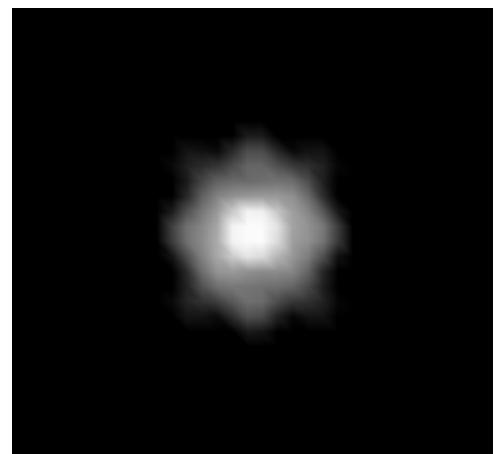
ა)ლინზიდან საგნის ცენტრამდე მანძილი 1მ



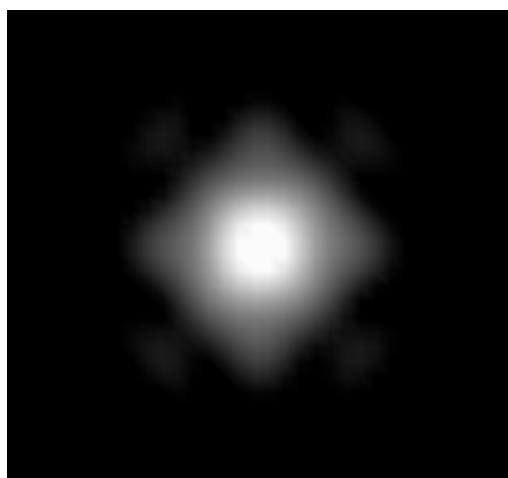
ბ)ლინზიდან საგნის ცენტრამდე მანძილი 3მ



გ) ლინზიდან საგნის ცენტრამდე მანძილი 5მ



დ) ლინზიდან საგნის ცენტრამდე მანძილი 6მ



ე) ლინზიდან საგნის ცენტრამდე მანძილი 8მ



ვ) ლინზიდან საგნის ცენტრამდე მანძილი 10მ

**ნახ. 2.53  
საგნის გარჩევისუნარიანობის დამოკიდებულება ლინზიდან მანძილზე**

7მ-ის ზემოთ ის უკვე მრგვალ დაქად იქცევა და ვეღარ გავარჩევთ მის ფორმას. ეს შედეგი არ ნიშნავს იმას, რომ საუკეთესო ხედვის მანძილი 5 მ-ია. ამისთვის კიდევ ჩავატაროთ ერთი გამოკვლევა. ამჯერად ლინზიდან საპროექციო სიბრტყემდე მანძილი ავიდოთ 6მ და გავიმეოროთ იგივე:

2. ლინზიდან საპროექციო ეკრანამდე მანძილი 6მ. ლინზის სიმრუდის რადიუსი 4მ.

ნახ. 2.53 სურათებიდან ყველაზე კარგი აღდგენა გვაქვს როდესაც საგანი ლინზიდან 8 მეტრის მანძილზე. აქედან გამომდინარე, იმის მიხედვით თუ როგორ არის განლაგებული საპროექციო ეკრანი, ლინზა და საგანი, საუკეთესო ხედვის მანძილი არის სხვადასხვა. ჩვენი გამოკვლევიდან გამომდინარე, თუ გვინდა რომ საუკეთესო ხედვის მანძილი წაგანაცვლოთ, საპროექციო ეკრანიც იგივე მიმართულებით უნდა წაგანაცვლოთ – ანუ თუ შორს არის საგანი, ეკრანს გავწევთ უფრო შორს; თუ საგანი ახლოსაა მაშინ საუკეთესო გარეჩევადობას რომ მივაღწიოთ, ეკრანის ლინზას უნდა მივუახლოვოთ. მარტო ამ პარამეტრის ცვლილება არ არის საქმარისი რადგან ამ დროს ხედვის

სიღრმეც იცვლება. ამიტომ ფოკუსური მანძილი უნდა შეგცვალოთ ისე, რომ საგანი ისევ ფოკუსში მოხდეს. ასევე მნიშვნელოვანია საპროექციო ეკრანის ზომის შერჩევა, რადგან ძალიან დიდი ზომის აღების შემთხვევაში საგანს გამოსახულება მრგვალ ლაქად გადაიქცევა. სასურველია ეკრანის ზომა საგნის გამოსახულების ზომას მაქსიმუმ 2-3 ჯერ აღემატებოდეს.

პოლოგრაფული მეთოდისგან განსხვავებით, ფოტოგრაფიული მეთოდით შესაძლებელია დავაკვირდეთ საგანს სხვადასხვა მანძილზე და მივიღოთ კარგი გარჩევადობის სურათი, გავზარდოთ ხედვის სიღრმე. ოდონდ ამისათვის საჭიროა პარამეტრების ზუსტად შერჩევა. გამოკვლევები აგრეთვე აჩვენებს, რომ მოცემულ სიხშირეზე, როცა ტალღური რიცხვი  $k=20$  სმ, ხაზოვანი ზომების მქონე სხეულის ფორმის გარჩევა შესაძლებელია მაქსიმუმ 10 მეტრზე, რაც შეესაბამება ხედვის კუთხის დაახლოებით  $5.7^\circ$ -ს.

### §2.11 ტოროიდის ზედაპირის აღდგენა

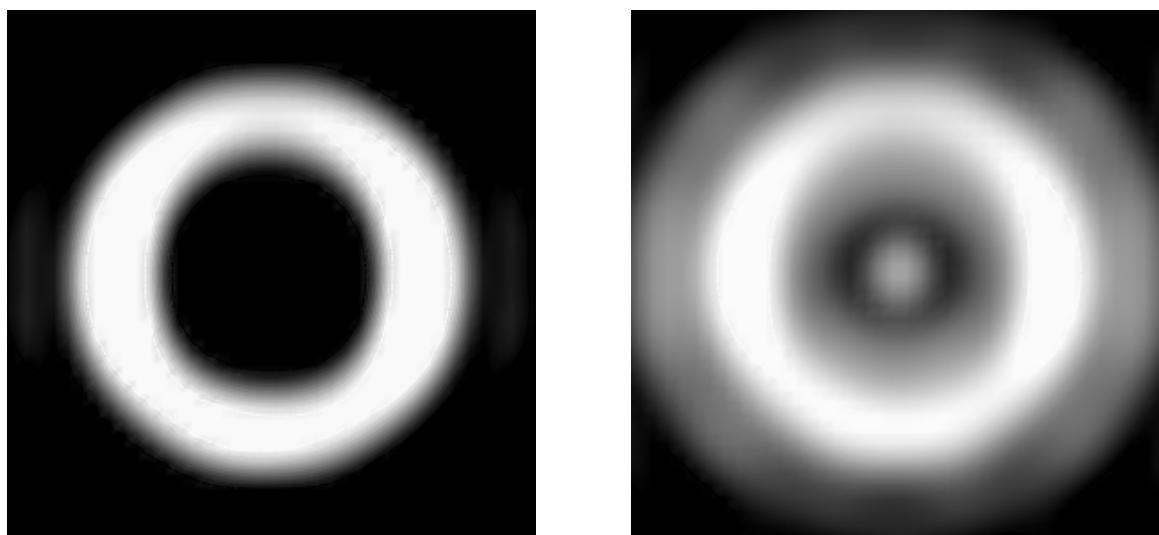
გადავიდეთ უფრო რთული ფორმის მქონე სხეულის, კერძოდ ტოროიდის (ნახ.2.54) ზედაპირის აღდგენაზე.



ნახ. 2.54

ტოროიდი

წინა შემთხვევებში სხეული მოთავსებული იყო ლინზიდან 5 მეტრზე. ამჯერად ტორს ვათავსებთ 5 მეტრის მანძილზე, ვხსნით პირდაპირ ამოცანას – ანუ ტორზე დიფრაქციის ამოცანას, შემდეგ ვპოულობთ ტორიდან არეალიდ ველს ლინზის ზედაპირზე და აღვადგენთ ველის სურათს ლინზიდან სხვადასხვა მანძილზე ისე, როგორც ამას ვაკეთებდით სხვა სხეულების შემთხვევაში. ნახ. 2.55-ზე წარმოდგენილია ველის აღდგენის 2 შემთხვევა: მარცხენა



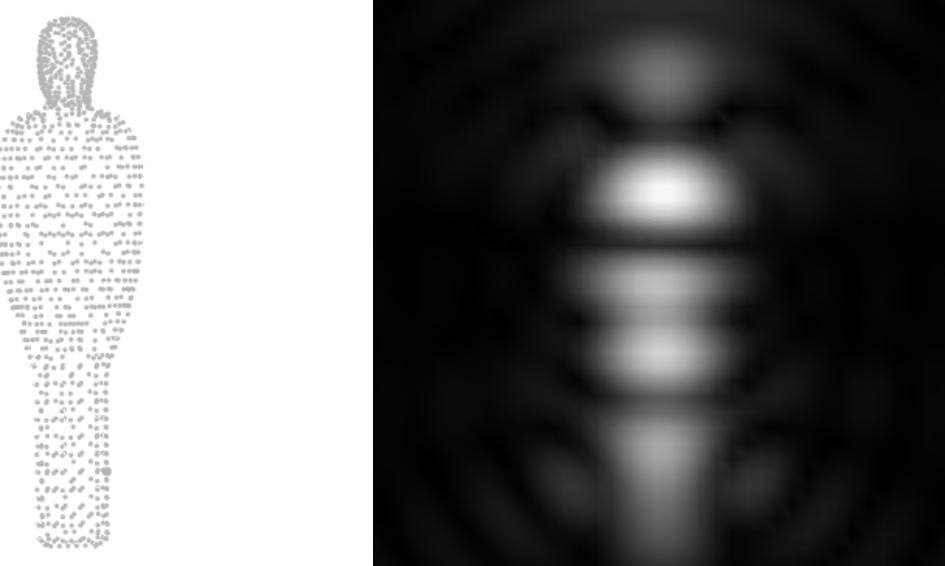
ნახ. 2.55

ტორის ზედაპირის აღდგენა  
ტოროიდი ფოკუსში(მარცხნივ) ტოროიდი არ არის ფოკუსში (მარჯვნივ)

შეესაბამება ლინზიდან 5 მეტრის მანძილს; მარცხენა კი ლინზიდან 5 მეტრის მანძილს. როგორც ვხედავთ მარცხენა სურათი იმეორებს ტოროიდის ფორმას, რადგან ის შეესაბამება ტორის მდებარეობას. მარჯვენა სურათი კი გადღაბნილია. ლინზის რადიუსი ამ შემთხვევაში 3 მეტრია, რაც შედარებით პატარაა წინა შემთხვევებისგან. უფრო პატარა ლინზის აღება არ იძლევა კარგ შედეგს. ლინზაზე წერტილების რაოდენობა არის 15 X 15 და ველის აღდგენას კომპიუტერი (P4, 2.4 GHZ) უნდება 10 წამი ფიქსირებული პარამეტრებისთვის.

### §2.12 ადამიანის ზედაპირის აღდგენა

განვიხილოთ ერთგვაროვანი ადამიანის ზედაპირის აღდგენა. ნახ. 2.56-ზე მარცხნივ წამოდგენილია ადამიანის გეომეტრია მოცემული წერტილებით; ხოლო მარჯვნივ კი აღდგენილი ველის სურათი, რომელზეც გამოსახულება იმეორებს ადამიანის გეომეტრიას.



ნახ. 2.56  
ადამიანი გეომეტრია(მარცხნივ) და ადამიანის  
ზედაპირის აღდგენა (მარჯვნივ)

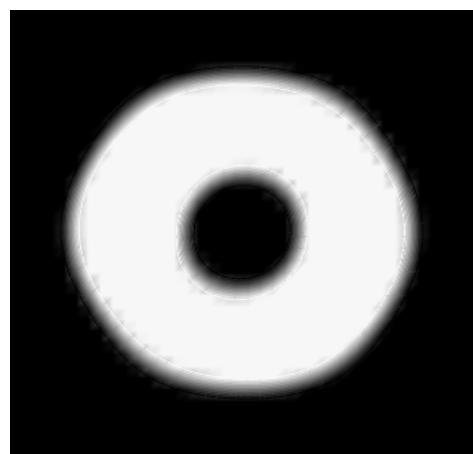
### §2.13 ჩაძირული სხეულის ზედაპირის აღდგენა

აქამდე ჩვენ ვიხილავდით თავისუფალ სივრცეში არსებულ სხეულის ზედაპირის აღდგენის ამოცანას. მაგრამ ჩვენი ამოცანაა მიწაში ჩაძირული სხეულის პოვნა. ამიტომ განვიხილოთ ზოგადად დიელექტრიკულ გარემოში ჩაძირული სხეულის აღდგენა. კერძოთ ჩაძირული ტორის აღდგენის ამოცანა. მიწის დიელექტრიკული შედწევადობა  $\epsilon_1 = 2$ . ხოლო ტორის  $\epsilon_2 = 3$  ტალღური რიცხვი  $k=20$ .



ნახ. 2.57  
ტორის და მიწის ზედაპირის გეომეტრია

მანძილი ლინზიდან ტორამდე 6.78 (ნახ. 2.57). მაგრამ რადგან სხეული მიწაშია ჩაძირული, გამოსახულება მიიღება უფრო ახლოს. კერძოდ 4.95 მეტრის მანძილზე. აღდგენილი ველის სურათი მოცემულია ნახ. 2.58-ზე:

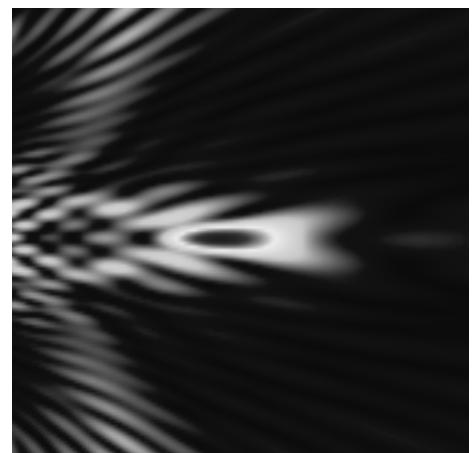
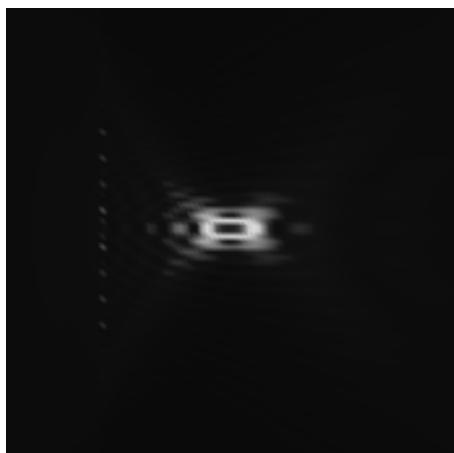


ნახ. 2.58  
ჩაძირული ტორის ზედაპირის აღდგენა

### §2.14 ფოტოგრაფიული და პოლოგრაფიული მეთოდების შედარება

ფოტოგრაფიული მეთოდის საშუალებით ჩვენ აღვადგენდით სხეულის ფორმას და მდებარეობას. იმისათვის რომ ფოტოგრაფიული და პოლოგრაფიული მეთოდი შევადაროთ, განვიხილოთ განმხოლობებული წყაროების ველის აღდგენა ფოტოგრაფიული მეთოდით ისევე, როგორც ეს გავაკეთეთ პოლოგრაფიული მეთოდის შემთხვევაში და მიღებული შედეგები შევადაროთ პოლოგრაფიული მეთოდით მიღებულ შედეგებს. ნახ. 2.59-ზე წარმოდგენილია ერთი წყაროს ველის აღდგენის შემთხვევა ფოტოგრაფიული და პოლოგრაფიული მეთოდის საშუალებით წყაროს სიხშირის ერთი და იგივე მნიშვნელობებისთვის:

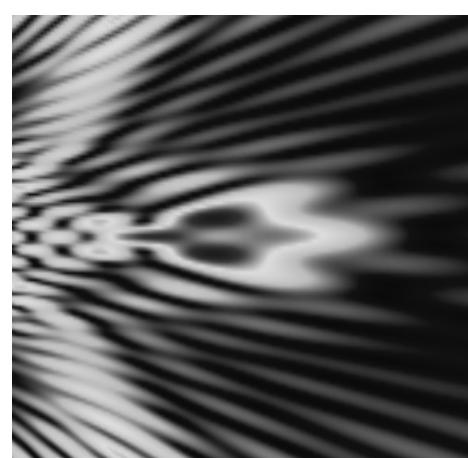
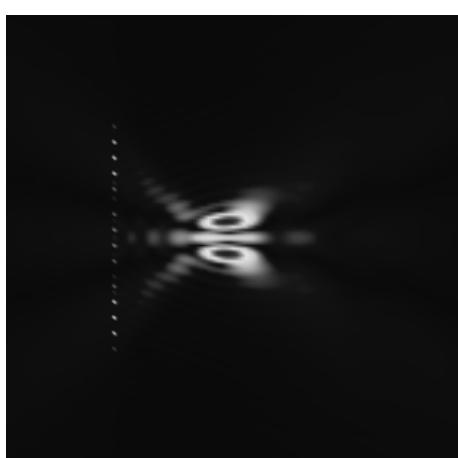
როგორც ნახაზზე ჩანს ფოტოგრაფიული მეთოდის შემთხვევაში წყაროს ველი ლოკალიზებულია უფრო მცირე არეში და ამრიგად უფრო ახლოა რეალურ შემთხვევასთან. ახლა განვიხილოთ შემთხვევა როდესაც გვაქვს ორი წყარო ერთმანეთისგან მცირე



ნახ. 2.59

ერთი წყაროს აღდგენილი ველის შედარება ფოტოგრაფიული (მარცხნივ) და პოლოგრაფიული (მარჯვნივ) მეთოდების საშუალებით

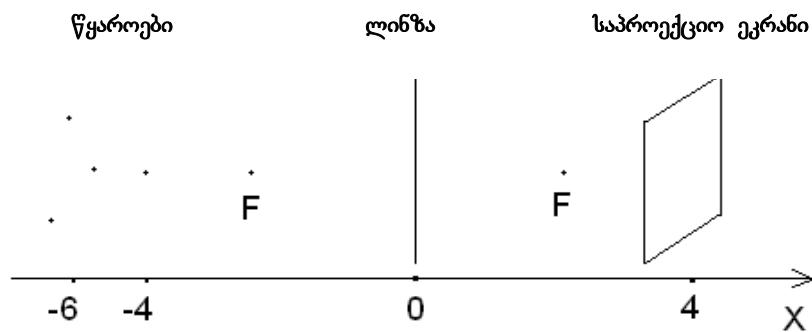
მანძილით დაშორებული. მათი შესაბამისი აღდგენილი ველის სურათები მოცემულია ნახ. 2.60-ზე.



ნახ. 2.60

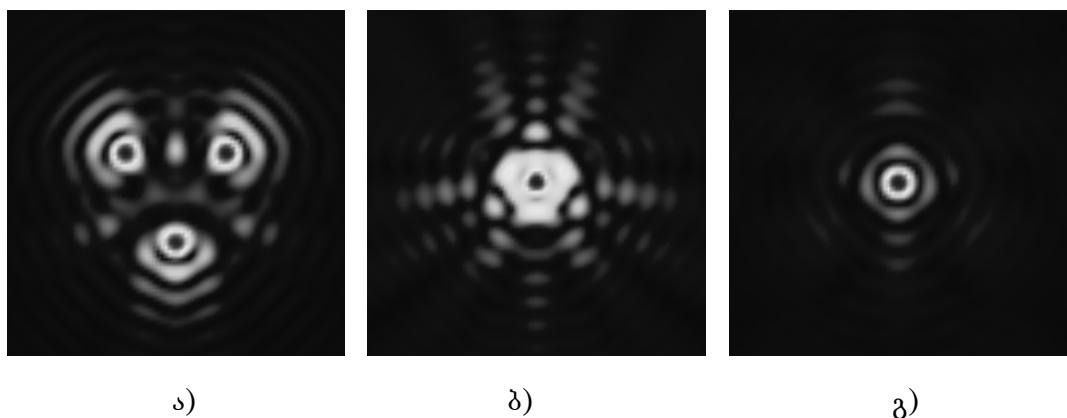
ერთი წყაროს აღდგენილი ველის შედარება ფოტოგრაფიული (მარცხნივ) და პოლოგრაფიული (მარჯვნივ) მეთოდების საშუალებით

როგორც ნახაზზე ჩანს. ფოტოგრაფიული მეთოდით აღდგენილ ველის სურათში ორივე წყარო ერთმანეთისგან განცალკევებულია, ხოლო პოლოგრაფიულის შემთხვევაში წყაროთა ველები ერთმანეთს გადაფარავს.



ნახ. 2.61  
სამი წყაროს ფოტოგრაფია

გავზარდოთ წყაროთა რაოდენობა და ამჯერად განვიხილოთ 4 წყარო და განვალაგოთ სიგრცეში ისე როგორც ეს ნახ. 2.61-ზეა ნაჩვენები.



ნახ. 2.62  
4 წყაროს ფოტოგრაფია  
ა)  $F=5\text{m}$ , ბ)  $F=4\theta$ , გ)  $F=3\theta$

წინა შემთხვევებში აღდგენილ ველს ვაკვირდებოდით ლინზის მართობულ სიბრტყეში, ახლა დავაკვირდეთ ლინზის სიბრტყეში. მივანიჭოთ ფოტუსურ მანძილს სხვადასხვა მნიშვნელობა და ვნახოთ რას მივიღებოთ ეკრანზე. ჩვენი მიზანია სხვადასხვა ფოტუსური მანძილისთვის მოვახდინოთ ეკრანზე ჯერ სამი

წყაროს ფოკუსირება, რომელიც ერთ სიბრტყეში მდებარეობს ლინზიდან 6 მ-ის მანძილზე;

შემდეგ კი მეოთხე წყაროს ფოკუსირება რომელიც ლინზიდან 4 მეტრის მანძილზე მდებარეობს. ნახ. 2.62-ზე წარმოდგენილია სამი სხვადასხვა შემთხვევა:

ა) შემთხვევაში ფოკუსური მანძილი უდრის 5 მეტრს და საპროექციო ეკრნზე მიიღება სამი წყაროს ველი.

ბ) შემთხვევაში გვაჩვენ გარდამავალი შემთხვევა. ფოკუსური მანძილი უდრის 4 მეტრს.

გ) შემთხვევაში ფოკუსური მანძილი უდრის 3 მეტრს და მიიღება მეოთხე წყაროს გამოსახულება რომელიც პირველი სამი წყაროსგან განსხვავებით ლინზასთან უფრო ახლო.

სწორედ ამით განსხვავდება ფოტოგრაფიული მეთოდი პოლოგრაფიულისგან: ის იძლევა ერთხელ გაზომილი ველის მნიშვნელობებით მოვახდინოთ გარემოს სკანირება და ვიპოვოთ სხეულის მდებარეობა.

**დასკვნა.** დამხმარე გამომსხივებლების მეთოდი საშუალებას იძლევა ამოისსნას შებრუნებული ამოცანა მე-5 ნიშნამდე სიზუსტით. ჩვენს მიერ განხილულ იქნა შებრუნებული ამოცანის ამოხსნის კერძო შემთხვევა, კერძოთ მიწაში ჩაძირული სხეულის ვიზუალიზაციის ამოცანა. ამოცანის ამოხსნა შეიცავს შემდეგ ეტაპებს:

– პირველად ხდება მიწის მახასიათებლის დადგენა – დგინდება რა სიხშირულ დიაპასზონშია მიწა გამჭვირვალე.

– შემდეგ ხდება დაცემული იმპულსის პარამეტრების შერჩევა ისე, რომ მოცემული იმპულსის სპექტრი შეიცავდეს სიხშირეებს, რომლის მიმართაც მიწა მეტ-ნაკლებად გამჭვირვალეა.

– ამის შემდეგ ხდება პირდაპირი ამოცანის ამოხსნა, რაც საშუალებას იძლევა გაიზომოს მიწიდან და მისი სიღრმეებიდან არეკვლილი იმპულსი გარკვეულ ზედაპირზე.

– გაზომილი მონაცემების საფუძველზე ანალიზური გაგრძელებით ხდება ველის აღდგენა სასურველ არეში ფოტოგრაფიული და პოლოგრაფიული მეთოდების დახმარებით. ეს იძლევა საშუალებას აღმოვაჩინოთ მიწაში მოთავსებული სხეული, დავადგინოთ მისი მდებარეობა, ფორმა და ზომები.

– შექმნილია პროგრამული პაკეტი, რომელიც იძლევა საშუალებას დავამოდელიროთ მიწაში ჩაძირული სხვადასხვა ფორმის, ზომის და ელექტროდინამიკური პარამეტრების სხეული; ამოისსნას პირდაპირი ამოცანა და შემდეგ შებრუნებული ამოცანის ამოხსნის შედეგად მოხდეს ჩაძირული სხეულის ვიზუალიზაცია რეალურ დროში.

### თავი III

ფოტონური კრისტალების კომპიუტერული მოდელირება

## ზოგადი მიმოხილვა

როგორც წესი, არსებითი წინსვლა ტექნოლოგიის განვითარების ისტორიაში შესაძლებელი ხდება მასალათა თვისებების უფრო ღრმა აღქმის და მათი გამოყენების წყალობით. ისტორიამდელი ხალხი ქმნიდნენ იარაღებს იმ ცოდნაზე დაყრდნობით, რომ ქვა მტკიცეა და რკინა კი მყარი. თითოეულ შემთხვევაში, კაცობრიობა სწავლობდა ამოედო მიწიდან მასალები, რომელთაც პქონდათ სასარგებლო თვისებები კონკრეტული გამოყენებისთვის. ამის შემდგომ ინჟინრებმა ისწავლეს იმაზე უფრო მეტი, ვიდრე უბრალოდ გამოეყენებინათ ის, რასაც მიწა იძლეოდა – კერძოდ ცნობილი მასალების საშუალებით ისინი ქმნიდნენ სუბსტანციებს უფრო სასარგებლო თვისებებით – ადრეული ბრინჯაოდან დღევანდელ ბეტონამდე და ფოლადამდე. მეტალურგიის მიღწევების, კერამიკისა და პლასტიკის წყალობით დღევანდელ დღეს ჩვენთვის მისაწვდომია მრავალი სრულიად ხელოვნური მასალა მექანიკური თვისებების ფართო დიაპაზონით.

ბოლო ათწლეულში მიკროტალდური და ოპტიკური ელექტრონიკის სწრაფ განვითარებასთან დაკავშირებით, წარმოიშვა აუცილებლობა შეიქმნას სპეციალური მასალა მათი ელექტრული და ოპტიკური თვისებების მართვის შესაძლებლობით. მას შემდეგ რაც უკვე შესაძლებელი გახდა მასალების დამუშავება, რომლებიც ეწინააღმდეგებოდნენ სინათლის გავრცელებას, ატარებდნენ მას მხოლოდ გარკვეულ სიხშირეებზე, ან ახდენდნენ მის ლოკალიზებას გარკვეულ არეში – ეს მაშინვე გამოყენებულ იქნა მრავალ თანამედროვე ტექნოლოგიურ ოპტოელექტრონულ მოწყობილობაში მათი პრაქტიკული რეალიზების მიზნით.

თავის დროზე თვით ოპტიკურბოჭკოვანმა კაბელებმა, რომლებიც უბრალოდ ატარებდნენ სინათლეს, მოახდინეს ნამდვილი რევოლუცია ტელეკომუნიკაციის ინდუსტრიაში.

როგორი მასალები მოგვცემენ მასში გამავალი სინათლის საკმარისი კონტროლის საშუალებას? რომ ვუპასუხოთ ამ კითხვას, გავავლოთ ანალოგია ნახევარგამტარული მიკროელექტრონიკის მიღწევებთან; კონკრეტულად განვიხილოთ ელექტრონის ყოფაქცევა ნახევარგამტარში. კრისტალი წარმოადგენს პერიოდულად განლაგებული ატომების და მოლეკულების წყებას, ე.ი. კრისტალური მესერი იქმნება სივრცეში ელემენტარული მოწყესრიგებული საშენი აგურების – ატომების და მოლეკულების გამეორებით. ამრიგად მასში მოძრავი ელექტრონისათვის, როგორც დამუხტული ნაწილაკისათვის, კრისტალი წარმოადგენს გარემოს პერიოდული ელექტრული პოტენციალით და კრისტალის გეომეტრია განაპირობებს მისი გამტარობის მრავალ თვისებას. კერძოდ, მესერმა შეიძლება შექმნას აკრძალული არეები კრისტალის ენერგეტიკულ მახასიათებელში ისე, რომ გარკვეული ენერგიის მქონე ელექტრონების გავრცელება რაიმე მიმართულებით იქნება უბრალოდ აკრძალული. თუ მესრის პოტენციალი საკმაოდ მაღალია, მაშინ აკრძალული ზონა შეიძლება წარმოიქმნას ყველა შესაძლო მიმართულებისთვის, და შექმნას ამრიგად სრული აკრძალული ზონა (complete band gap). მაგალითად, ნახევარგამტარს აქვს სრული აკრძალული ზონა სავალენტო ზონის და გამტარობის ზონის ენერგეტიკულ დონეებს შორის.

ნახევარგამტარის ოპტიკური ანალოგი არის ფოტონური კრისტალი, რომელშიც პერიოდული პოტენციალი ფოტონებისთვის წარმოიქმნება (ატომების ნაცვლად) მაკროსკოპული დიელექტრიკული ელემენტების პერიოდული მესრის არსებობის წყალობით. თუ მესრის მასალების დიელექტრიკული თვისებები საკმაოდ განსხვავდება, ხოლო სინათლის შთანთქმა კრისტალის მიერ მინიმალურია, მაშინ გარემოთა შორის საზღვარზე ფოტონებისთვის (სინათლის მოდებისთვის)

შეიძლება განვაპირობოთ ანალოგიური მოვლენების სიმრავლე, რომელიც დაიკვირვება ელექტრონების გავრცელების შემთხვევაში ნახევარგამტარების ატომურ მესერში. ამრიგად, ერთ-ერთ საშუალებას სინათლის მართვისთვის წარმოადგენს ფოტონური კრისტალების ანუ დაბალი შთანთქმის მქონე პერიოდული გარემოს გამოყენება. კერძოდ, ჩვენ შეგვიძლია დაგამუშაოთ ფოტონური კრისტალი ფოტონური აკრძალული ზონებით, რომელიც ეწინააღმდეგება მოცემული სიხშირის სინათლის გავრცელებას გარკვეული მიმართულებით და აქვს მოცემული მიმართულების პოლარიზაცია. შემდეგ, შევიტანო რა მესერში სპეციალურ დეფექტებს, ან შევცლით რა რომელიმე უჯრის თვისებებს მოცემული ხაზის გასწვრივ, შესაძლებელია შეიქმნას ტალღამტარი მოცემულ სიხშირულ დიაპაზონში. ეს სპეციალური დეფექტები, არხები და უჯრები, სადაც აღწევს ფოტონი, წარმოადგენს რეზონანსულ არეებს მოცემული სიხშირის სინათლისთვის. დეფექტების სხვადასხვა ტიპი განაპირობებს არხის სხვადასხვა ყოფაქცევას დაცემული ტალღის მიმართ. ეს მნიშვნელოვნად აიოლებს ზემადალი სიხშირის ხელსაწყოების ანალოგების შექმნას ოპტიკურ დიაპაზონში. ზმს ტექნიკაში ფართოდაა გავრცელებული მოწოდილობები ტალღის გავრცელების მართვისთვის, ისეთები როგორიცაა მეტალური ტალღამტარი და სიღრუე. მეტალური სიღრუე კრძალავს ტალღების გავრცელებას გარკვეული ზღვრული სიხშირეების ქვემოთ, ამავე დროს მეტალური ტალღამტარი უშვებს გავრცელებას მხოლოდ გარკვეული მიმართულებით. ორივე ეს თვისება უკიდურესად სასარგებლოა ზმს მოწყობილობების შექმნისათვის, და ამიტომ სასურველია უზრუნველვყოთ ისინი უფრო მაღალ სიხშირეებზეც, რომელიც გადიან ზმს-ის გარეთ. კერძოდ, ოპტიკურ დიაპაზონში ოპტიკური ინტეგრალური სქემების შემადგენელი კვანძების რანგში გამოყენებისათვის. მაგრამ ელექტრომაგნიტური ტალღები მაღალ სიხშირეებზე (მაგალითად ხილული სინათლე) სწრაფად შთაინთქმება მეტალური ელემენტებით. ამას გარდა, ანალოგიური მოწყობილობების დასამზადებლად ამ დიაპაზონში მოითხოვება უფრო მაღალი ტექნოლოგიური სიზუსტე, რაც შეუძლებელს ხდის ამ მოწყობილობების კონსტრუქციის პირდაპირ გადატანას ოპტიკურ დიაპაზონში. ამის საწინააღმდეგოდ ფოტონურ კრისტალებს შეუძლიათ არა მარტო გაიმეორონ დრუთა და ტალღამტართა თვისებები ოტიკურ დიაპაზონში, არამედ ისინი არიან მასშტაბირებადი და გამოყენებადი უფრო ფართო სიხშირულ დიაპაზონშიც. თანამედროვე ტექნოლოგია საშუალებას იძლევა შეიქმნას ფოტონური კრისტალების ანალოგები მოცემული კონფიგურაციის და სასურველი მილიმეტრული ზომების დეფექტებით ზმს დიაპაზონისთვის, ასევე მიკრონული ინფრაწითელი სინათლის სამართავადაც.

## პროგრამული პაკეტი

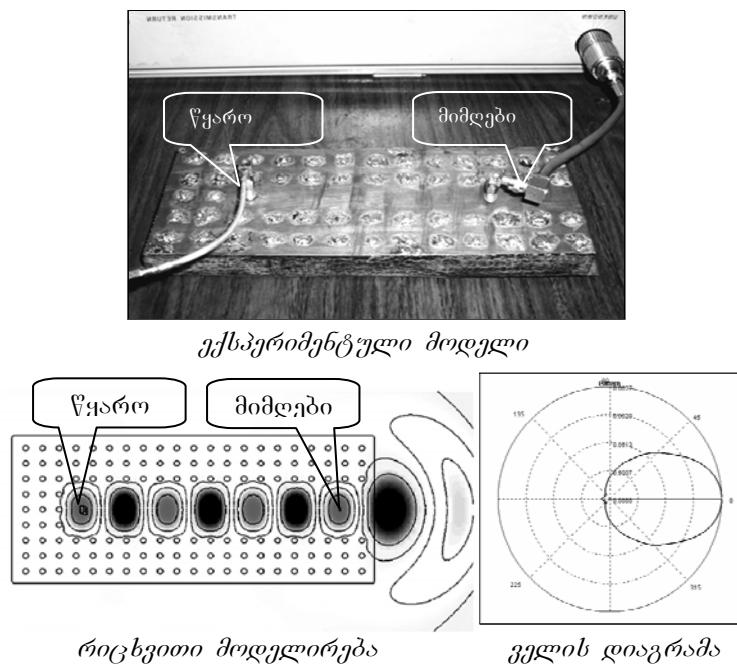
ნაშრომის შესავალ ნაწილში წარმოდგენილი იყო მოდელი შემუშავებული დამხმარე გამომსხივებლების მეთოდის ბაზაზე და ალგორითმი ფოტონური კრისტალების კომპიუტერული მოდელირებისათვის. წარმოდგენილ ალგორითმზე შექმნილია პროგრამული პაკეტი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს მივიღოთ ელექტრომაგნიტური ველის ამპლიტუდის და ფაზის განაწილების სურათი ახლო არეში და გადასხივებული ველის დიაგრამა შორ ზონაში. პროგრამული პაკეტი განკუთვნილია ინჟინერული მოხმარებისათვის და არ საჭიროებს ალგორითმში გამოყენებული მეთოდის საფუძვლიან ცოდნას. მასში აღვილად არის შესაძლებელი კრისტალის ფორმის, ზომის და დიელექტრიკული შეღწევადობის შერჩევა. შესაძლებელია არჩეულ იქნას დეფექტების ნებისმიერი განლაგება. ასევე შეგვიძლია ვცვალოთ ელექტრომაგნიტური ველის წყაროს აგილდებარეობა და მისი პარამეტრები: ამპლიტუდა, ფაზა და სიხშირე, მათი რაოდენობა და განლაგება. პროგრამული პაკეტი საშუალებას იძლევა დინამიურ რეჟიმში ვცვალოთ აღნიშნული პარამეტრები და ამავე დროს თვალი ვადგვნოთ სისტემაში მიმდინარე ტალღურ პროცესებს. ფიქსირებული მესრისათვის შესაძლებელია ვიპოვოთ მისი რეზონანსული სიხშირე. იგი განისაზღვრება შორ ზონაში გადასხივებული ველის მაქსიმუმის სიხშირეზე დამოკიდებულების გრაფიკიდან, რომელიც ავტომატურად იგება პროგრამის დინამიურ რეჟიმში გაშვების დროს.

ჩატარებული იქნა რიცხვითი ექსპერიმენტები სხვადასხვა სახის კრისტალური მესრისთვის და ქვემოთ მოყვანილია მიღებული შედეგები.

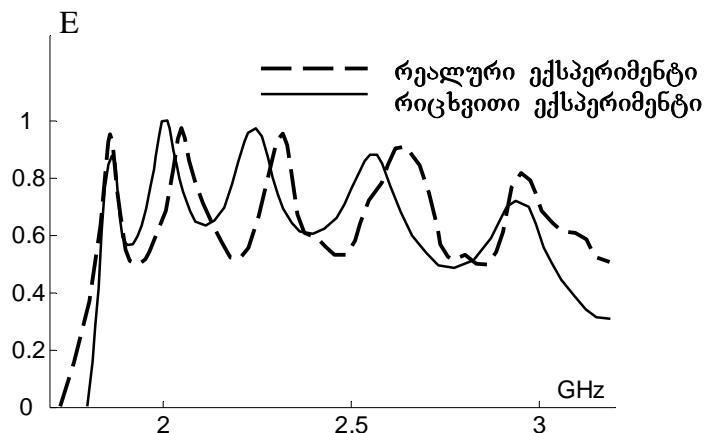
## ელექტრონული მოწყობილობები

### §3.1 წრფივი ტალღგამტარი

ფოტონური კრისტალების ბაზაზე შეიძლება დამზადდეს ტალღგამტარი. ამისათვის კრისტალში უნდა ამოვიდოთ რამდენიმე პერიოდული წყება ნახ. 3.1-ზე წარმოდგენილია ტალღგამტარის რიცხვითი და ექსპერიმენტული მოდელი. რიცხვითი მოდელი იქმნება იმ მეთოდის საფუძველზე, რომელიც ზემოთ იყო აღნიშნული. ექსპერიმენტული მოდელის დასამზადებლად აღებულია დიელექტრიკული ფენა, რომელზეც ორივე მხრიდან დაფენილია მეტალის თხელი ფენა; ხოლო შიგნით კრისტალურ მესერს ქმნის ლითონის დეროები. ტალღგამტარის დასაწყისში მოთავსებულია ელექტრომაგნიტური ველის წყარო, გამოსასვლელში კი მიმდები. ხდება ელექტრული ველის ამპლიტუდის გაზომვა სხვადასხვა სიხშირეზე. მოცემულ სტრუქტურას აქვს გამოსხივების საკმაოდ მიმართული დიაგრამა (ნახ. 3.1).



ნახ. 3.1: ფოტონურ კრისტალებზე დაფუძნებული ტალღამტარის კვეთა

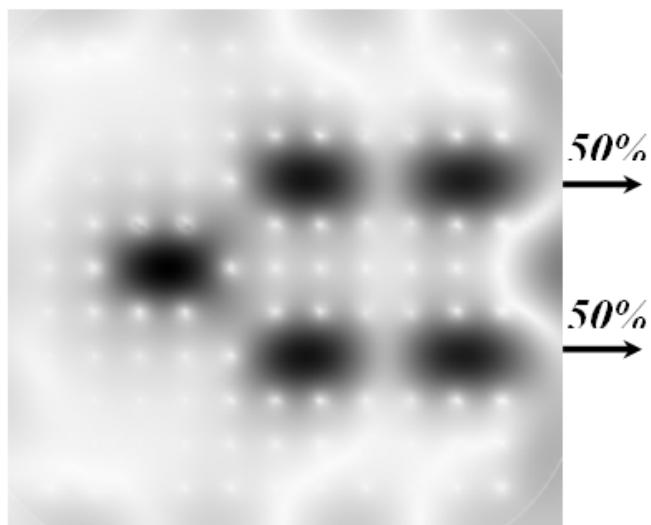


ნახ. 3.2: რიცხვით და რეალური ექსპერიმენტის შედარება ლია ბოლოს მქონე ტალღამტარისთვის. ნახაზზე მოცემულია ტალღამტარის პერისოდების ელექტრული ველის სიხშირეზე დამოკიდებულება დიაპაზონში 1.95 GHz - დან 3.0 GHz - მდე

ნახ. 3.2-ზე წარმოდგენილია რეალური და რიცხვითი ექსპერიმენტის შედარება სიხშირულ დიაპაზონში: 1.95 GHz-დან 3.0 GHz-მდე. მოყვანილია მოცემულ დიაპაზონში რეალურ ექსპერიმენტზე გაზომილი ელექტრული ველის ამპლიტუდების მნიშვნელობები და მოდელირების შედეგად მიღებული მნიშვნელობების მათთან შედარება. როგორც ნახაზიდან ჩანს, დამთხვევა საკმაოდ კარგია. ცდომილება, რაც ნახაზზე ჩანს, გამოწვეულია კრისტალის დამზადებისას დაშვეული ტექნოლოგიური ცდომილებით, და აგრეთვე კრისტალის დიელექტრიკოსის შეღწევადობის მნიშვნელობების შერჩევის სიზუსტით, რომელიც აღებული იყო ცხრილიდან გეტინაქსისათვის.

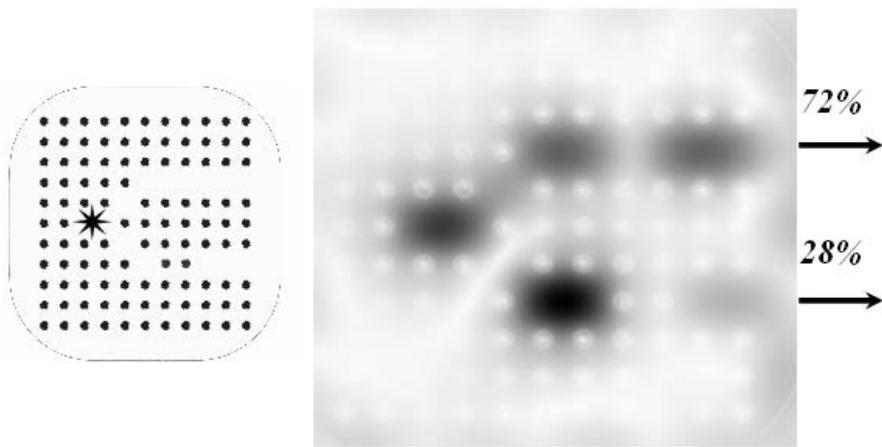
### §3.2 სიმძლავრის გამყოფი

სიმძლავრის გამყოფი წარმოადგენს ელექტრონულ მოწყობილობას, რომელიც ახდენს მასში მოთავსებული ელექტრომაგნიტური წყაროს სიმძლავრის რამდენიმე ნაწილად გაყოფას სასურველი პროპორციით.



ნახ. 3.3  
ახლო ველის განაწილება  $k=2.3$  ტალღური  
რიცხვისთვის

განვიხილეთ რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც ველის სიმძლავრეს გყოფდით 2 ნაწილად სასურველი პროპორციით. სიმძლავრის გამყოფის მოდელად ავიღეთ დიელექტრიკი მასში

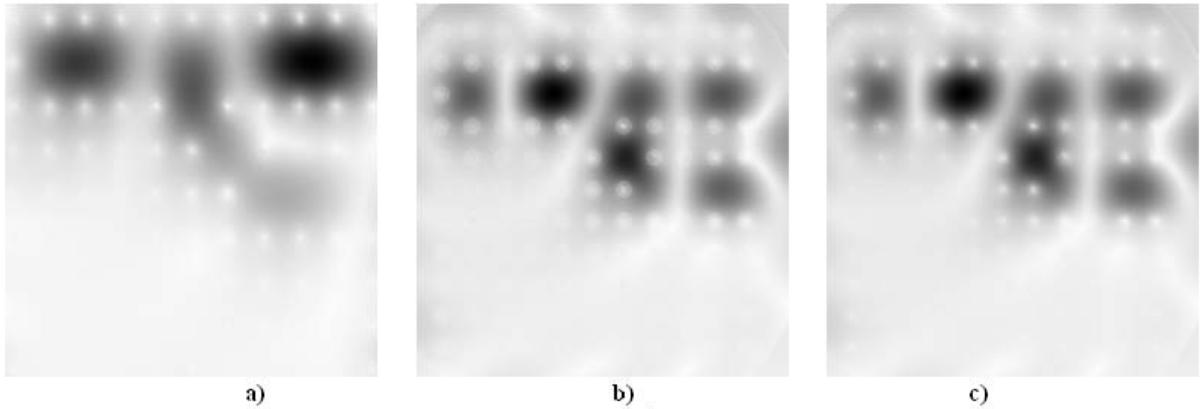


**ნახ. 3.4**  
ახლო გელის განაწილება  $k=2.3$  ტალღური  
რიცხვისთვის

შეტანილი მეტალური დეროების პერიოდული სტრუქტურით, რომლის პერიოდულობა დარღვეულია ისე, რომ კრისტალში გვაქვს ერთი შემავალი და ორი გამომავალი არხი (ნახ. 3.3) [10].

ერთ-ერთ რეზონანსულ სიხშირეზე ( $k=2.3$ ) გამოვითვალეთ ახლო გელის განაწილება, რომელიც წარმოდგენილია ნახ. 2.1 -ზე. როგორც ნახაზიდან ჩანს, არხში გამავალი გელის ამპლიტუდებს შორის თანაფარდობა 1-ის ტოლია. ეს იმის მანიშნებელია, რომ აღნიშნული კრისტალი მასში მოთავსებული წყაროს გელის ენერგიას არხებში ყოფს თანაბარ ნაწილებად. თანაბარი გაყოფა მივიღეთ იმის გამო, რომ კრისტალი X დერძის მიმართ სიმეტრიულია. იმისათვის რომ მივიღოთ გელის სიმძლავრის სხვა პროპორციით გაყოფა, კრისტალის სტრუქტურა უნდა შეიცვალოს. სიმძლავრის გამყოფი ეფექტურად მუშაობს კრისტალის რეზონანსულ სიხშირეზე, ამიტომ ყოველი ახალი სტრუქტურისთვის საჭიროა შორ ზონაში გადასხივებული გელის ენერგიის სიხშირეზე დამოკიდებულების გრაფიკის აგება, რომელიც რეზონანსული სიხშირის გამოვლენის საშუალებას მოგვცემს. როდესაც ნახ. 3.3 -ზე წარმოდგენილ კრისტალში შევიტანეთ დამატებით 2 ელემენტი, როგორც ეს ნახ. 3.4-ზეა ნაჩვენები, კრისტალის თვისება შეიცვალა, რაც გამოიხატა იმაში, რომ მიღებულმა კრისტალმა მოგვცა მასში მოთავსებული წყაროს ენერგიის განსხვავებული თანაფარდობით გაყოფა (ნახ. 3.4) [10]. ელექტრომაგნიტური გელის წყაროს მოდელად აღებული გვაქვს წერტილოვანი წყარო, რომელიც შეგვიძლია მოვათვავსოთ კრისტალში ნებისმიერ ადგილას. განხილული შედეგებიდან ნათლად ჩანს, რომ კრისტალის სტრუქტურის შეცვლით შეგვიძლია მივიღოთ გაყოფის ნებისმიერი, სასურველ თანაფარდობა. მოცემულ თანაფარდობაზე გავლენას ახდენს დიელექტრიკში შეტანილი მეტალის დეროების რადიუსის ცვლილებაც. რეზონანსული სიხშირე ნახ. 3.3-ზე მოცემული შემთხვევისთვის იგივეა რაც წინა შემთხვევაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ კრისტალში 2 ელემენტის ჩამატებამ მნიშვნელოვნად არ შეცვალა კრისტალის რეზონანსული მახასიათებელი, რომელიც შორ ზონაში გადასხივებული გელის მნიშვნელობისთვისაა აღებული. თუმცა ახლო ზონაში მან მოგვცა სასურველი შედეგი, ანუ გელის სიმძლავრის სასურველი თანაფარდობით გაყოფა.

სიმძლავრის სხვადასხვა თანაფარდობით გაყოფა მიიღწევა ელექტრომაგნიტური ველის წყაროს სიხშირის ცვლილებითაც, ამ შემთხვევაში კრისტალის გეომეტრიას არ ვცვლით. გამყოფისათვის შევარჩიეთ ნახ. 3.5-ზე მოცემული კრისტალი. მასში არხები არასიმუტრულადაა განლაგებული, რაც განაპირობებს წყაროს ენერგიის არათანაბარ გადანაწილებას. ავაგეთ ორივე არხის გამოსასვლელზე

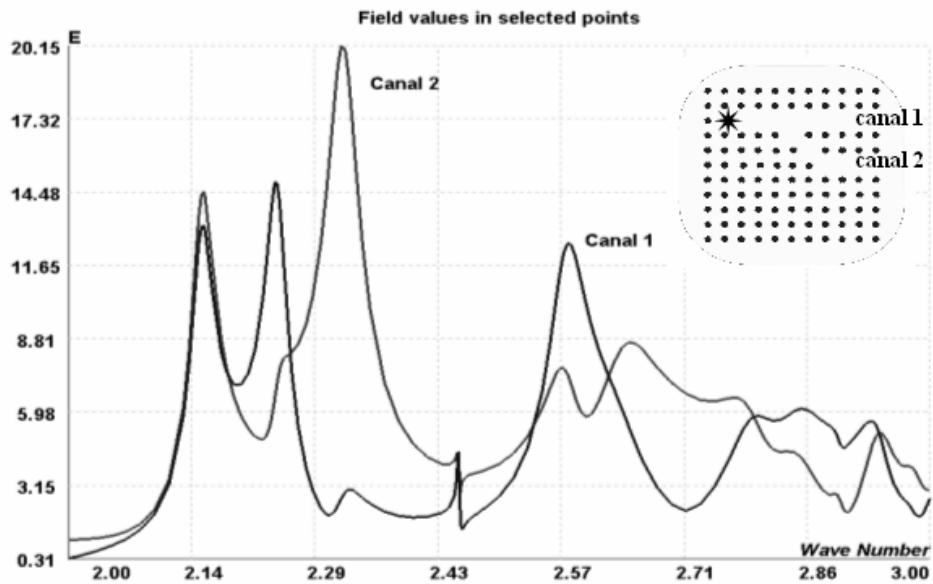


ნახ. 3.5  
ახლო ველის განაწილება კრისტალში  
a)  $k=2.6$  64% 36% b)  $k=2.54$  50% 50% c)  $k=2.32$  30% 70%

კონკრეტულ წერტილებში ველის მნიშვნელობების სიხშირული მახასიათებელი, რამაც საშუალება მოგვცა მიგვედო ველის ენერგიის გაყოფის სასურველი თანაფარდობა, რაც ნათლად ჩანს სურ. 3.5-ზე გრაფიკიდან. ავირჩიეთ 3 განსხვავებული სიხშირე, რომლებზედაც არხებში გვაქვს ველის სურათზე მოყვანილი თანაფარდობით გაყოფა (სურ. 3.5). [10]

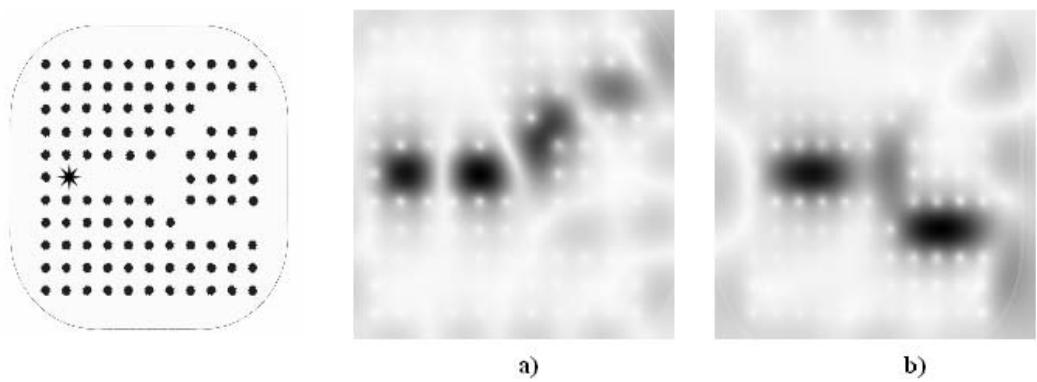
### §3.3 სიხშირული ფილტრი

სიხშირული ფილტრი წარმოადგენს მოწყობილობას, რომელიც განასხვავებს გარკვეულ სიხშირეებს და მათ მიმართავს განსაზღვრული მიმართულებით. წინა შემთხვევის მსგავსად, ავიდეთ კრისტალი 1 შესავალი და 2 გამოსავალი არხით. საჭიროა შეირჩეს ისეთი სტრუქტურა, რომელიც ერთი გარკვეული სიხშირის წყაროს ენერგიას მიმართავს პირველ გამოსავალ არხში, ხოლო სხვას მეორეში. ფილტრაციის დროს, რა თქმა უნდა გარკვეული ენერგია მეორე არასასურველ არხშიც ვრცელდება, მაგრამ მან არ უნდა გადააჭარბოს განსაზღვრულ მნიშვნელობას.



ნახ. 3.6  
ფიქსირებულ წერტილებში ველის ამპლიტუდების  
სიხშირეზე დამოკიდებულება

ნახ. 3.7-ზე წარმოდგენილია კრისტალის გეომეტრია. მოცემული კრისტალისთვის თითოეულ გამომავალ არხში ველის ამპლიტუდის სიხშირეზე დამოკიდებულებას აქვს ნახ. 3.6 სახე. მოცემული გრაფიკებიდან ავარჩიეთ სიხშირეები, რომლებზედაც არხის გამოსასვლელებს შორის ველის ამპლიტუდის მაქსიმალური განსხვავება გვაქვს (არჩეული სიხსირეები შეესაბამება ფილტრაციის სიხშირეებს). ამ სიხშირეთა შესაბამისი  $k=2.6$  და  $k=2.2$  ტალღური რიცხვებისთვის ველის განაწილებას კრისტალში აქვს (ნახ. 3.8 ა,ბ) სახე, რაც იმის მანიშნებელია, რომ ამ სიხშირეებისთვის ხდება ტალღის ფილტრაცია. ნახაზზე ნათლად ჩანს, რომ  $k=2.6$



ნახ. 3.7  
კრისტალის ფორმა

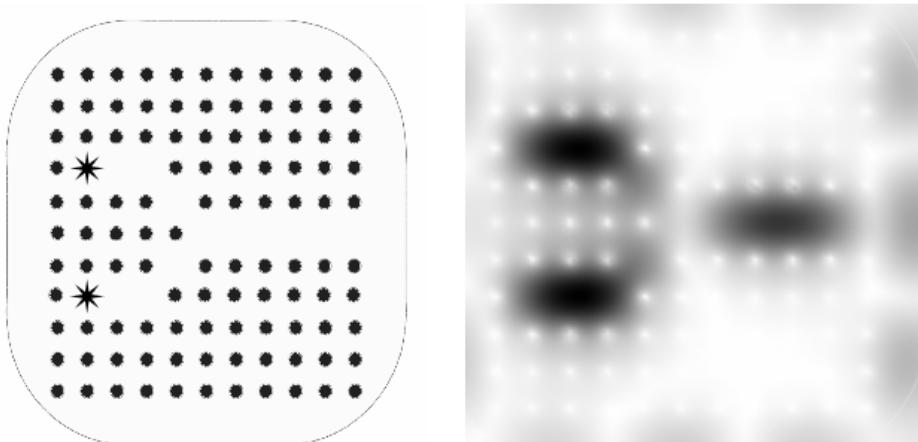
ნახ. 3.8  
ახლო ველის განაწილება კრისტალში  
ა)  $k=2.6$  ბ)  $k=2.2$

შემთხვევაში ენერგიის მნიშვნელოვანი ნაწილი კრიცელდება პირველ არხში, ხოლო  $k=2.2$  შემთხვევაში მეორე არხში. შესაძლებელია შეირჩეს სხვა სტრუქტურებიც ფილტრისათვის, რომელიც სხვა სიხშირეებზე იმუშავებს. ასევე შესაძლებელია კრისტალში გაკეთდეს 3 გამოსავალი არხი, რაც საშუალებას მოგვცემს სამი სხვადასხვა სიხშირის სასურველ არხში გადაცემას.

### §3.4 სიმძლავრეთა შემრევი

ფოტონური კრისტალების ბაზაზე შეიძლება შემუშავებულ იქნას აგრეთვე სიმძლავრეთა შემრევი. შემრევი წარმოადგენს მოწყობილობას, რომელიც ახდენს 2 ან რამდენიმე წყაროს ენერგიის შერევას.

ჩვენ განვიხილეთ შემრევის ნახ. 3.9-ზე წარმოდგენილი ვარიანტი, როდესაც კრისტალში გაკეთებულია 2 შესასვლელი და ერთი გამოსასვლელი არხი. პირველ 2 არხში ვათავსებთ 2 სხვადასხვა ენერგიის წყაროს და კრისტალი უზრუნველყოფს მათ შერევას, ანუ დეფექტები ისეა განლაგებული, რომ გამოსავალზე მიიღება ამ ორი წყაროს ჯამური ველი.

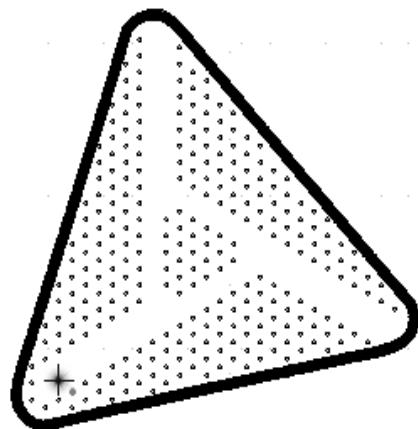


ნახ. 3.9  
კრისტალის გეომეტრია და ახლო ველის განაწილება  
კრისტალში  $k=2.2$  ტალღური რიცხვისთვის

თუ ავიდებთ სხვა სიხშირის წყაროებს, მაშინ საჭირო გახდება დეფექტების განლაგების სხვა კონსტრუქციის შერჩევა. შესაძლებელია აგრეთვე სამი და მეტი წყაროს ენერგიის შერევა. ამისათვის უნდა შეირჩეს შესაბამისი კრისტალი მასში დეფექტების საჭირო კონფიგურაციით.

### §3.5 ცირკულატორი

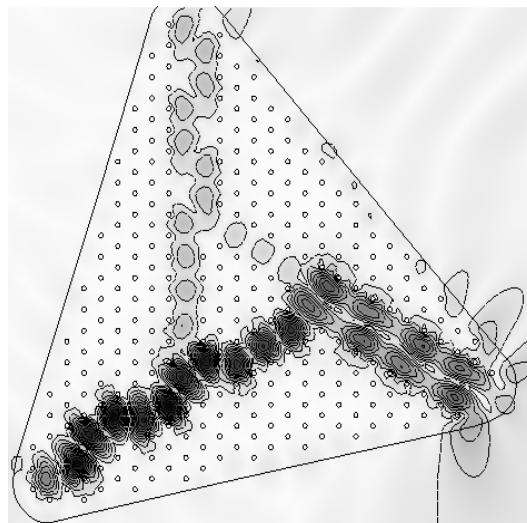
ცირკულატორი წარმოადგენს მოწყობილობას, რომელიც მიმართულებას უცვლის ელექტრომაგნიტური ველის წყაროს ენერგიას. თავდაპირველად განვიხილეთ კრისტალის ოთხკუთხა ფორმა, მასში ვაკეთებდით სამ არხს. ცირკულატორის



**ნახ. 3.10**  
**კრისტალის გეომეტრია**

ბუნებიდან გამომდინარე პირველ არხში მოთავსებული წყაროს ენერგია უნდა გადაეცეს მეორე არხს, მეორე არხში მოთავსებული წყაროს ენერგია მესამეს, ხოლო თუ წყაროს მესამე არხში მოვათავსებთ, მაშინ ველი პირველ არხში უნდა გავრცელდეს. კრისტალს მივეცით სამკუთხა ფორმა, როგორც ეს ნახ. 3.10-ზეა ნაჩვენები და მასში მეტალური ღეროები განვალაგეთ ჰექსაგონალურად.

მოცემული კრისტალი იმითაც არის საინტერესო, რომ ის მისი

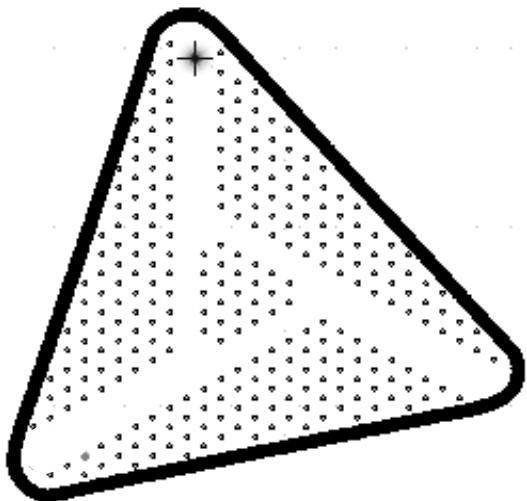


**ნახ. 3.11**  
**ახლო ე ველის განაწილება**  
**ცირკულატორში**

ცენტრის მიმართ სიმეტრიულია და ამიტომ მან უნდა იმუშაოს როგორც ცირკულატორმა: კრისტალმა უნდა გადაცეს პირველი არხიდან გელის მეორე არხში ენერგია, მაშინ ავტომატურად შესრულდება დანარჩენი პირობებიც მისი სიმეტრიულობის გამო. მოყვანილი მოსაზრების დასადასტურებლად დავიწყეთ

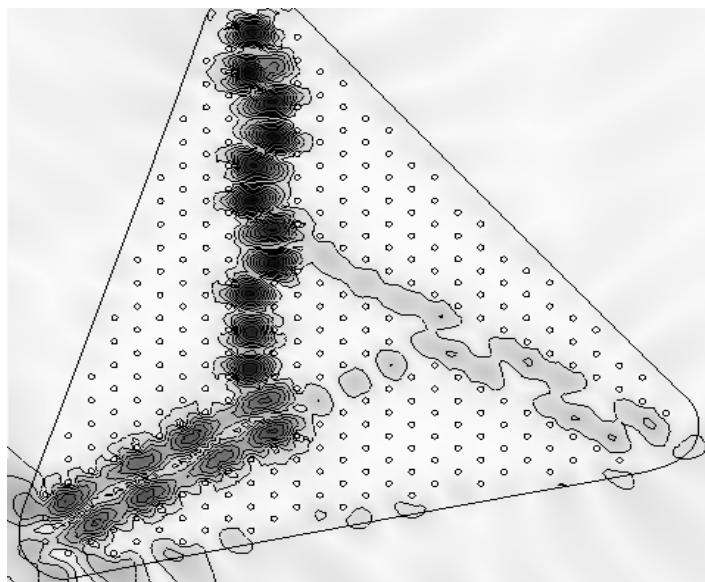
მოცემულ კრისტალის გამოკვლევა. მოვათავსეთ პირველ არხში წყარო და სხვადასხვა სიხშირეზე გაკვირდებოდით ახლო ველის სურათს. გარკვეულ სიხშირიდან, პირველი არხიდან მეორესა და მესამეში გადაცემული ველის ენერგიის თანაფარდობა იწყებს ზრდას და რეზონანსულ სიხშირეზე თითქმის მთელი ენერგია მეორე არხს გადაეცემა. მოცემული შემთხვევისთვის ახლო ველის განაწილება მოცემულია ნახ. 3.11-ზე. ნახაზზე ჩანს მესამე არხში ველის გარკვეული რაოდენობა, მაგრამ ის მდგარი ტალღის სახით არის და ამიტომ ამ მიმართულებით ველის ენერგიის გავრცელება არ ხდება.

შემდეგ წყარო მოვათავსეთ III არხში ( ნახ. 3.12 ). როგორც მოსალოდნელი იყო ველის ენერგია გადაეცა I არხს. ნახ. 3.13-ზე მოცემულია ახლო ველის სურათი და მასზე ნათლად ჩანს, რომ ველის განაწილება ნახ. 3.11-ზე განხილული შემთხვევის სიმეტრიულია. დადებითი შედეგი მივიღეთ მესამე შემთხვევაში, როცა წყარო მოთავსებულია მეორე არხში.



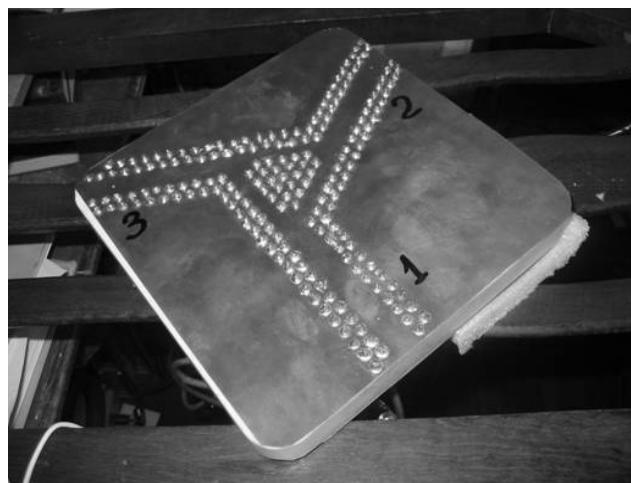
ნახ. 3.12  
კრისტალის გეომეტრია

იმ ფაქტს რომ ველი ვრცელდება ძირითადად ერთ არხში, განაპირობებს ის, რომ ცირკულატორის ცენტრში მოთავსებულია სამკუთხა ობიექტი. როდესაც ტალღა მას 2 სხვადასხვა მიმართულებიდან უვლის, ტალღები ხვდებიან სრულ საწინააღმდეგო ფაზაში და ერთმანეთს აქრობენ. ფოტონური კრისტალის ბაზაზე სავარაუდოა აგრეთვე სხვა კონფიგურაციის ცირკულატორის დამზადება. მასში მეტალური დეროები შეიძლება განლაგდეს სხვა ფორმითაც. მიღებულ შედეგზე გავლენას მოახდენს მათი რადიუსის რეგულირებაც.



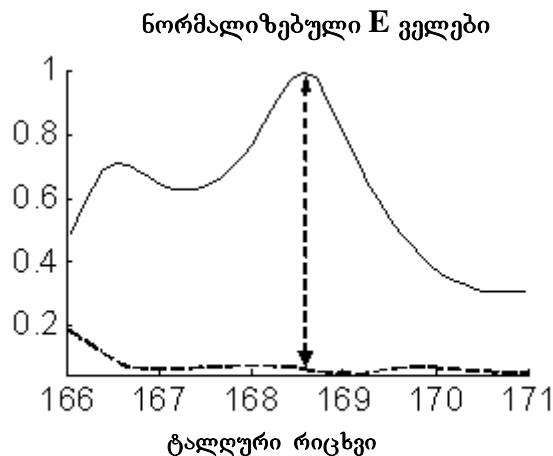
ნახ. 3.13  
ახლო ე ველის განაწილება

მოცემული კრისტალის ბაზაზე დამზადებულ იქნა ცირკულატორის პროტოტიპი. ის წარმოადგენს დიელექტრიკს, რომელზეც 2-ივე მხრიდან დაფენილია მეტალური ფენა და მასში მესერს ქმნის ლითონის წვრილი ღეროები. ლითონის ფენები, რომელიც მეტალზე 2-ივე მხრიდან არის დაფენილი, უზრუნველყოფს ველის სარკისებურ არეკვლას, და ამით ის თავისი თვისებებით ემსგავსება 2 განზომილებიან ფოტონურ კრისტალს. მას აქვს ნახ. 3.14-ზე ნაჩვენები სახე:

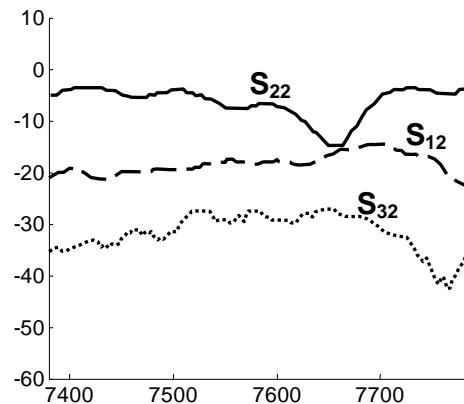


ნახ. 3.14  
ცირკულატორის პროტოტიპი

ჩატარდა რეალური გქსპერიმენტი ცირკულატორის მოცემულ პროტოტიპზე; შემოწმდა თუ რამდენად განსხვავდება ცირკულატორის მეორე და მესამე გამოსასვლელზე ველის ამპლიტუდა, როდესაც კვება მიეწოდება პირველ შესასვლელს. აიგო სიხშირული მახასიათებელი, რომელსაც აქვს შემდეგი სახე (ნახ. 3.15). ნახ. 3.16-ზე წარმოდგენილია ცირკულატორის გამოსასვლელზე არეალის კოეფიციენტის სიხშირული მახასიათებელი.

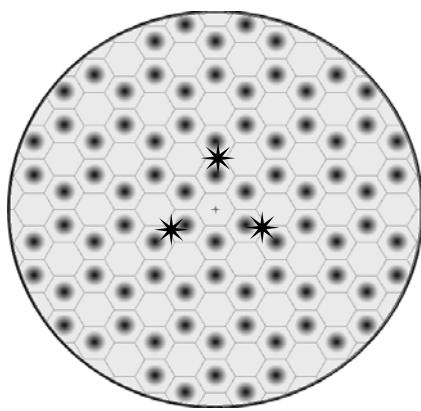


ნახ. 3.15. ცირკულატორის მეორე და მესამე არხის გამოსასვლელებზე ველის ამპლიტუდის სიხშირული მახასიათებელი, როცა კვება მიეწოდება I არხს



ნახ. 3.16  
ცირკულატორის გამოსასვლელზე არეალის კოეფიციენტის სიხშირეზე დამოკიდებულება  
 $S_{12}$  -შეესაბამება პირველ არხს  
 $S_{22}$  -შეესაბამება პირველ არხს  
 $S_{32}$  -შეესაბამება პირველ არხს

### §3.6 ანტენური სტრუქტურები

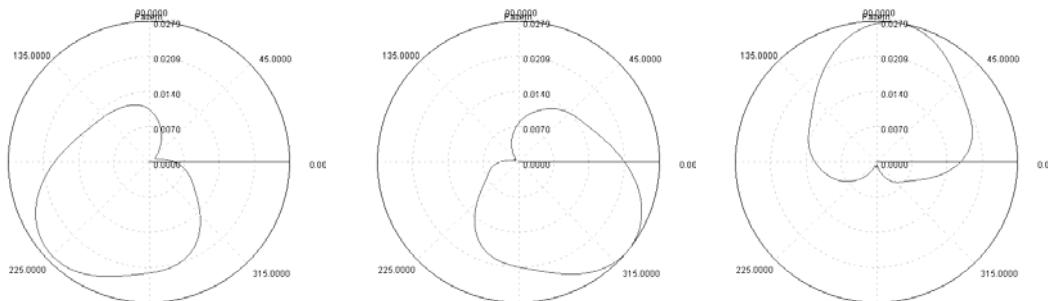


ნახ. 3.17

ფოტონური კრისტალი, როგორც ანტენა ფოტონური კრისტალი, როგორც ანტენა ანტენა მოცემული არის მოცემული ანტენა ნახ. 3.18 ზეა მოცემული. მოცემული ანტენა ხასიათდება იმ თვისებითაც, რომ მასში

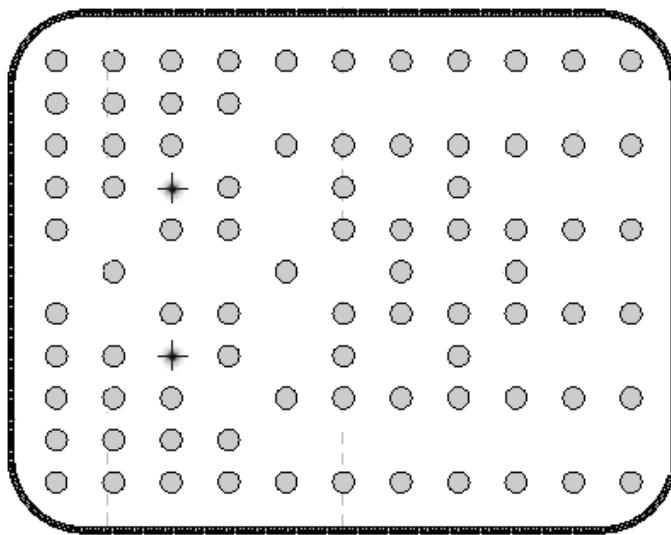
ფოტონური კრისტალი შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც მიმართული გამოსხივების მქონე ანტენა. ავირჩიეთ წრიული ფორმის კრისტალი (ნახ. 3.17), რომელშიც კრისტალის ცენტრის მიმართ სიმეტრიულად მოთავსებულია სამი გამომსხივებელი. სამივე გამომსხივებელს აქვს ერთნაირი სიხშირე, როდესაც მათი ფაზები ერთნაირია, ანტენა ასხივებს ყველა მიმართულებით კრისტალის სიმეტრიულობის გამო. საკმარისია ვცვალოთ მათი ფაზების თანაფარდობა, რომ გარკვეულ კონკრეტულ შემთხვევაში მივიღოთ მიმართული გამოსხივება როგორც ეს ნახ. 3.18

მოთავსებული წყაროების ფაზათა გარკვეული კანონზომიერებით ცვლილებისას შეიძლება მისი გამოსხივების მიმართულების შემოტრიალება 360 გრადუსით. ნახ. 3.18-ზე ნაჩვენებია ანტენის გამოსხივების დიაგრამა სამ სხვადასხვა შემთხვევაში.



ნახ. 3.18  
გამოსხივებული ველის დიაგრამა ფოტონური კრისტალისთვის  
(როგორც ანტენა)

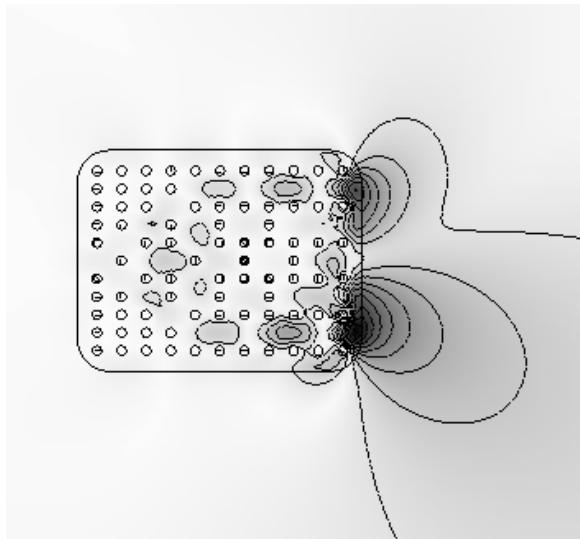
ასეთი ტიპის ანტენები გამოიყენება გარემოს სკანირებისათვის.



ნახ. 3.19  
კრისტალის გეომეტრია მასში მოთავსებული 2 წყაროთ

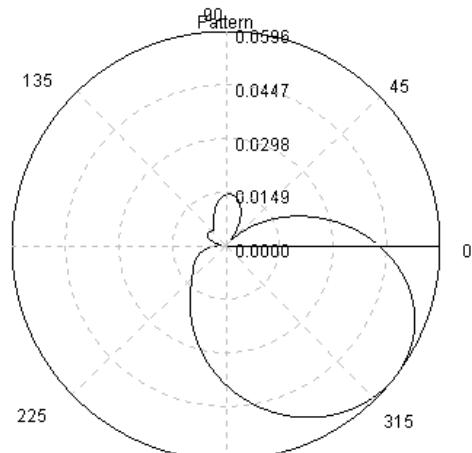
მისი დამზადება საკმაოდ შარტივია და აღარ არის საჭირო უზარმაზარი ანტენების გამოყენება იგივე მიზნებისთვის. ასეთი ანტენა აღარ საჭიროებს შემოტრიალებას, რადგან მათი გამოსხივების მიმართულების ცვლა ხდება ელექტრონულად. ასეთი ტიპის ანტენას შეიძლება ჰქონდეს მართკუთხა ფორმაც. ნახ. 3.19-ზე გამოსახულია ერთ-ერთი ასეთი შემთხვევა. როგორც ნახაზზე ჩანს, მასში მოთავსებულია 2 წყარო. ანტენა იძლევა მიმართულ გამოსხივებას და საჭიროა ამ მიმართულების მართვა წყაროთა ფაზების ცვლილების საშუალებით. ჩვენ გამოვიკვლიუთ მოცემული კრისტალი და გარკვეულ (კრისტალის პარამეტრების მიხედვით) სიხშირეზე მივიღეთ სასურველი სურათი. ნახ. 3.20-ზე გამოსახულია ახლო ველის განაწილება, როდესაც წყაროების ფაზათა თანაფარდობაა 0:80 ამ

დროს ანტენის გამოსხივების მიმართულება შემოტრიალებულია 45 გრადუსით X დერძის მიმართ მარჯვნივ. ნახ. 3.21-ზე მოცემულია შესაბამისი გადასხივებული გელის დიაგრამა. [12]



ნახ. 3.20

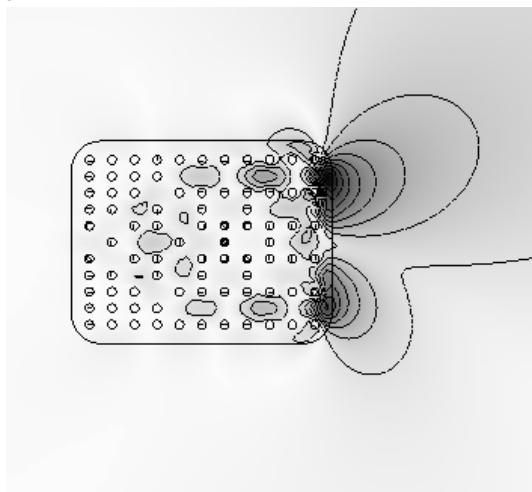
ახლო გელის განაწილება კრისტალში  
წყაროთა ფაზების თანაფარდობისას  
0 : 80



ნახ. 3.21

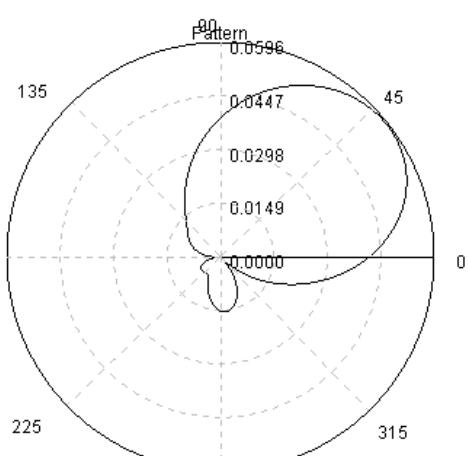
გადასხივებული გელის დიაგრამა

თუ დავიწყებთ ფაზათა თანაფარდობის მიმართულება დაიწყებს შემოტრიალებას შემთხვევაში ახლო გელის განაწილებას ხოლო გადასხივებული გელის დიაგრამა კი წარმოდგინდება ნახ. 3.23 სახით. როგორც ნახ. 3.23-ზე ჩანს გელი შემოტრიალდა 90 გრადუსით მარცხნივ. ნახ. 3.24-ზე მოცემულია ახლო გელის განაწილება ანტენური სტრუქტურისთვის, რომელსაც როგორც



ნახ. 3.22

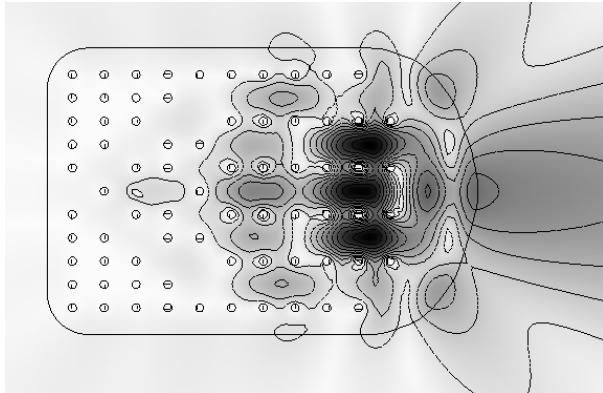
ახლო გელის განაწილება კრისტალში  
წყაროთა ფაზების თანაფარდობისას  
80 : 0



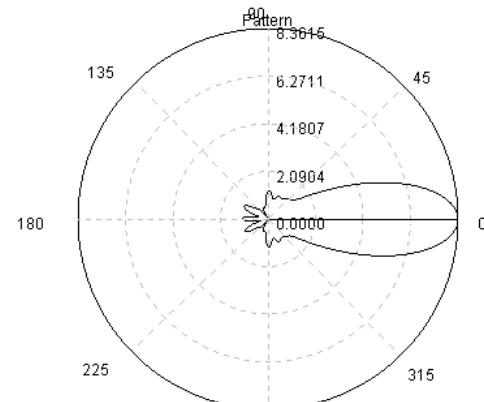
ნახ. 3.23

გადასხივებული გელის დიაგრამა

ნახაზზე ჩანს, გამოსასვლელზე აქვს შემკრები ლინზის ფორმა, რაც უზრუნველყოფს მის მიმართულ გამოსხივებას. მოცემული ანტენისათვის გადასხივებული ველის დიაგრამა მის რეზონანსულ სიხშირეზე მოცემულია სურ. 3.25-ზე. ასეთი ტიპის სტრუქტურა აღსანიშნავია იმით, რომ ლინზის რადიუსის ცვლილებით



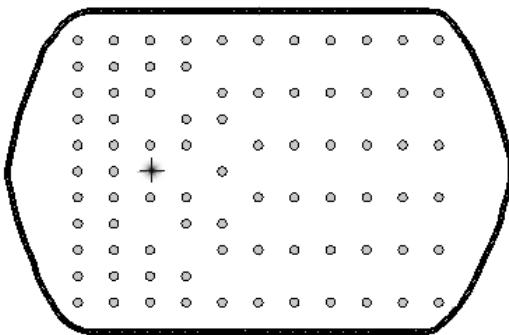
ნახ. 324  
ახლო ველის განაწილება



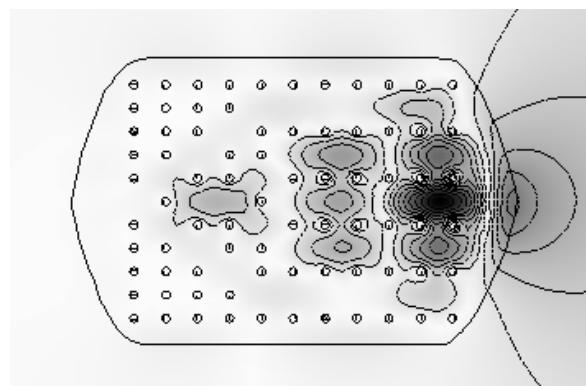
ნახ. 325  
გადასხივებული ველის

შეიძლება ანტენის გამოსხივება გავხადოთ უფრო მიმართული.

განვიხილოთ კიდევ ერთი ანტენური სტრუქტურა, როდესაც კრისტალის ორივე გვერდს აქვს ლინზის ფორმა. მისი გეომეტრია მოცემულია ნახ. 3.26-ზე. მოსალოდნელია, რომ მოცემულმა სტრუქტურამ

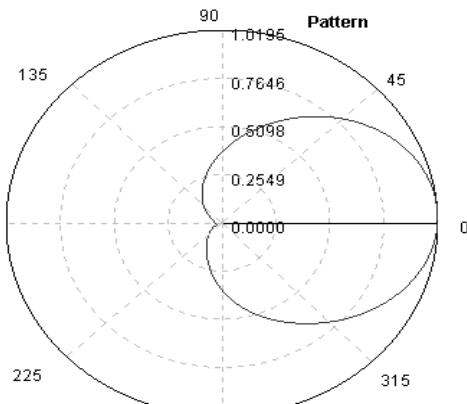


ნახ. 326  
კრისტალის გეომეტრია

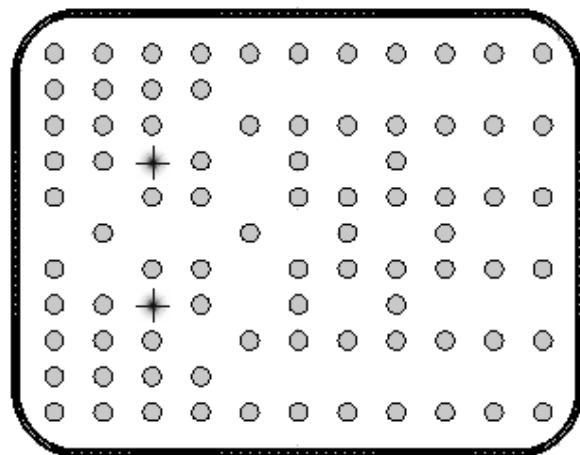


ნახ. 327  
ახლო ველის განაწილება

უნდა მოგვცეს მიმართული გამოსხივება, რასაც ადასტურებს ნახ. 3.27, რომელზეც მოცემულია ახლო ველის განაწილება ერთ-ერთ რეზონანსულ სიხშირეზე. შორ ზონაში გადასხივებული ველის დიაგრამა გამოსახულია ნახ. 3.28-ზე. [14]

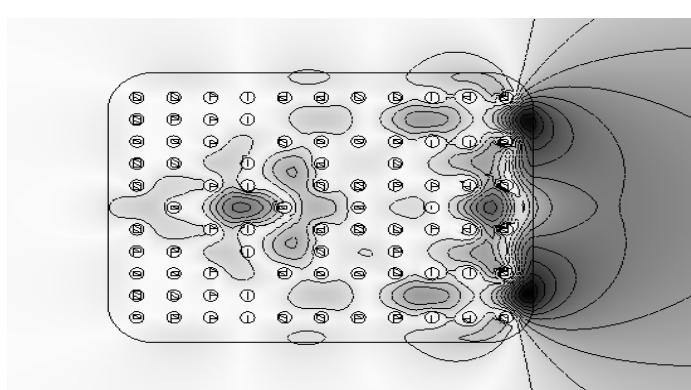


ნახ. 3.28  
გადასხივებული ველის დიაგრამა

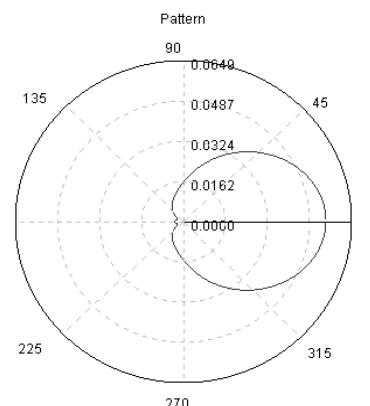


ნახ. 3.29  
კრისტალის გეომეტრია

ჩვენს მიერ განხილულ წინა შემთხვევებში კრისტალის დიელექტრიკული შეღწევადობა მერყეობდა  $4 - 9$  შუალედში. ახლა განვიხილოთ შემთხვევა, როცა  $\varepsilon = 100$ . კრისტალის გეომეტრიას აქვს ნახ. 3.29 სახე. გამოვიკვლიერ მოცემული სტრუქტურის კრისტალი, სხვადასხვა სიხშირეზე ვაკვირდებოდით ველის ყოფაქცევას ახლო ზონაში და ვიპოვეთ სიხშირე, რომელზეც ანტენას ჰქონდა მიმართული გამოსხივება. ახლო ველის განაწილება მოცემული შემთხვევისთვის ნაჩვენებია ნახ. 3.30-ზე, ხოლო გადასხივებული ველის დიაგრამა ნახ. 3.31-ზე. როგორც ამ ნახაზებიდან ჩანს ანტენის გამოსხივება საკმაოდ მიმართულია და X დერძის მიმართ სიმეტრიულია, რადგან კრისტალში მოთავსებული ორივე წყაროს ფაზები ერთმანეთს ემთხვევა. თუ მათი ფაზების თანაფარდობას შევცვლით, მაშინ გამოსხივების მიმართულება დაიწყებს შემოტრიალებას როგორც ერთი ისე მეორე მიმართულებით, როგორც ეს წინა შემთხვევებში იყო განხილული.



სურ. 3.30  
ახლო ველის განაწილება

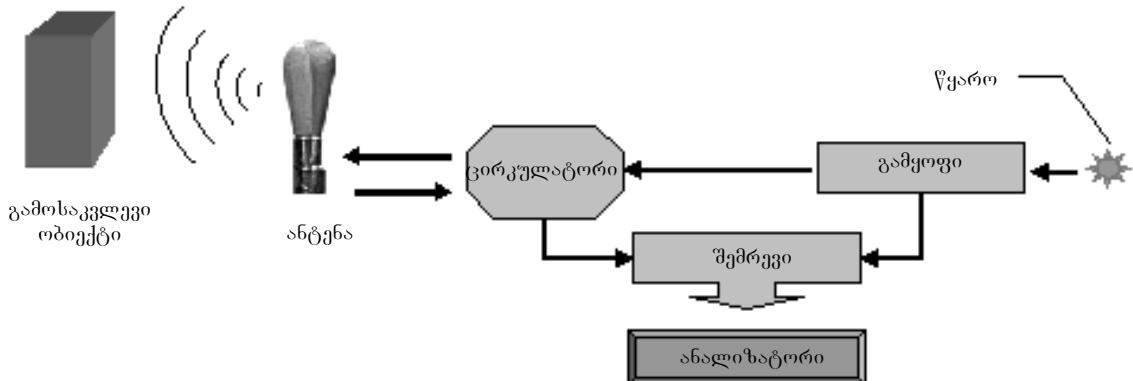


სურ. 3.31  
გადასხივებული ველის დიაგრამა

ჩვენ განვიხილავთ 2 განზომილებიან შემთხვევას. დიელექტრიკში შეტანილი იყო უსასრულო სიგრძის გამტარები. ორ თქმა უნდა ტექნიკურად ამის უზრუნველყოფა შეუძლებელია. ასეთი სახის მოწყობილობების დასამზადებლად იღებენ დიელექტრიკს, რომელშიც შეტანილია მეტალის გარკვეული სიგრძის დეროები და დიელექტრიკი თრივე მხრიდან იფარება მეტალური ფირფიტებით, რომლის მავრანირებელი ხასიათი ქმნის კრისტალში უსასრულო მეტალური გამტარების ეფექტს. მისი კვება შესაძლებელია მასში შეყვანილი კაბელით, რომელიც შეერთებულია ელექტრომაგნიტურ ტალღების გენერატორთან. ფოტონური კრისტალების ბაზაზე ასეთი სახის მოწყობილობების დამზადება საკმაოდ მარტივია.

### 3.7 ინტეგრალური სქემა ფოტონური კრისტალის ბაზაზე

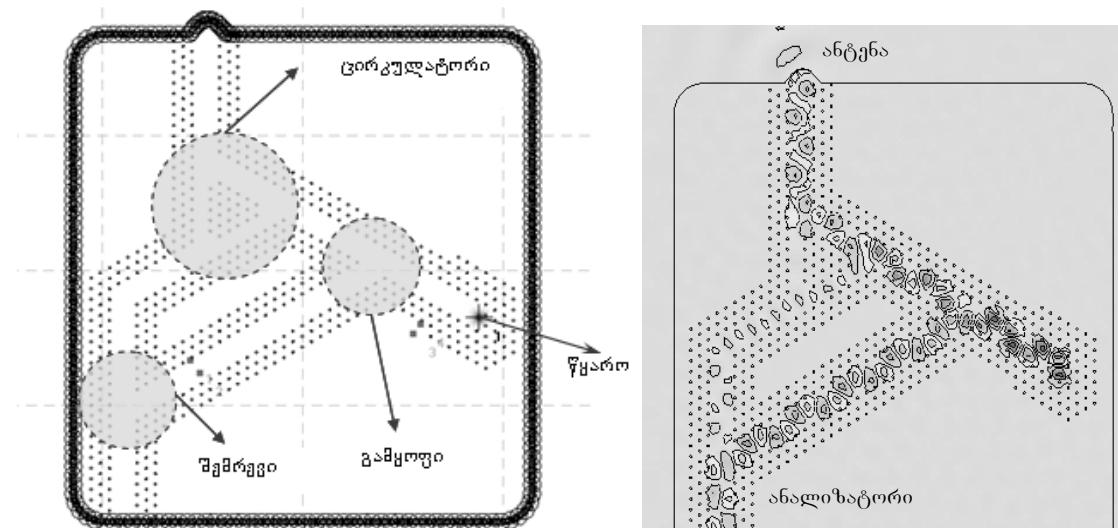
მოცემულ პარაგრაფში განვიხილავთ ფოტონური კრისტალის ბაზაზე დამზადებულ ინტეგრალურ სქემას, რომელიც წარმოადგენს ხელსაწყოს დიელექტრიკის ზედაპირის დისტანციური გამოკვლევისთვის. მის ბლოკ სქემას აქვს შემდეგი სახე ნახ.332:



ნახ. 3.32  
ინტეგრალური სქემის  
ბლოკსქემა

ელექტრომაგნიტური გელის წყაროდან ენერგია მიეწოდება სიმძლავრეთა გამყოფს; ნაწილი ენერგიისა მიდის ანალიზატორში და ასრულებს საყრდენი სიგნალის როლს; ნაწილი კი შედის ცირკულატორში და მისი გავლის შემდეგ მიეწოდება წვეთის ფორმის ანტენას, საიდანაც ეს ენერგია გამოსხივდება თავისუფალ სივრცეში. თუ მოცემულ მოწყობილობას მივუახლოვებთ რაიმე

ობიექტს, რომლის გამოკვლევაც გვინდა, ნაწილი ანტენის მიერ გამოსხივებული ენერგიისა აირეკლება მოცემული ობიექტდან და დაბრუნდება ისევ მოცემულ მოწყობილობაში ანტენის გავლით, რომელიც მუშაობს აგრეთვე როგორც მიმღები. შემდეგ ეს ენერგია შევა ცირკულატორში და იქიდან შემრევში, რომელშიც საყრდენ სიგანალს შეერევა და მიეწოდება ანალიზატორს, რომელიც მოახდენს მის ანალიზს. ჩვენ მოვახდინეთ მოცემული ხელსაწყოს მოდელირება ფოტონური კრისტალის ბაზაზე და მას აქვს ნახ. 3.33-ზე წარმოდგენილი სახე:

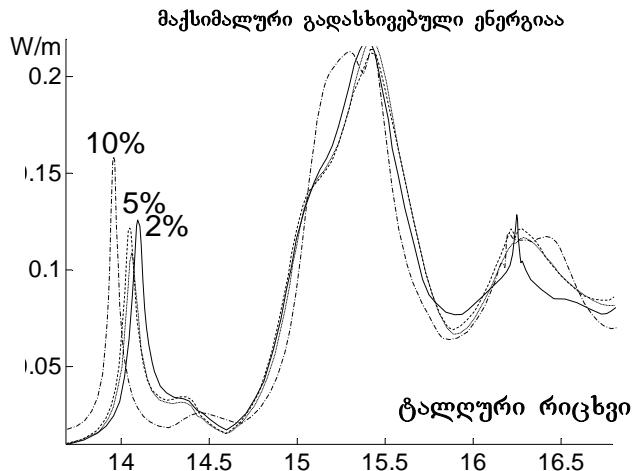


**ნახ. 3.33**  
ინტეგრალური სქემის გეომეტრია (მარცხნივ) და მასში ველის  
განაწილების სურათი (მარჯვნივ)

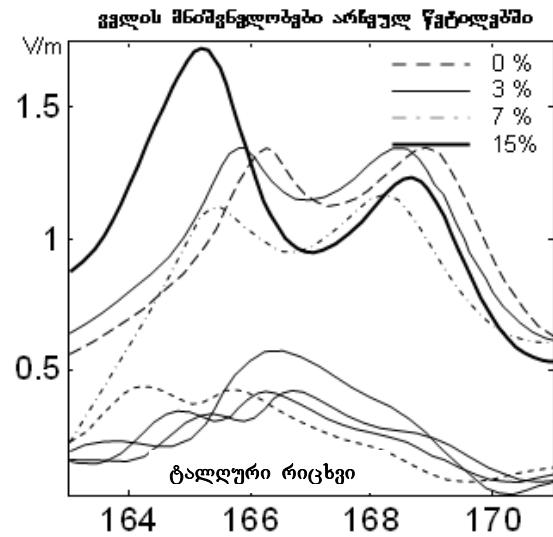
### §3.8 ქარხნული დამზადების სიზუსტის მოდელირება

როგორც ცნობილია, შეუძლებელია ქარხანამ სრული სიზუსტით დაამზადოს ესა თუ ის მოწყობილობა. ამასთანავე მეტად მნიშვნელოვანია გამოკვლეული იქნას თუ როგორ აისახება ქარხნული უზუსტობა ხელსაწყოს მუშაობაზე. ამ მიზნით ჩვენ დავამოდელირეთ ეს უზუსტობები. კერძოდ, მესრის ელემენტების ზომას და მდებარეობას მივეცით შემთხვევითი წანაცვლებები და ვნახეთ წონასწორობის მდებარეობიდან გადახრის რა პროცენტული რაოდენობისთვის არის მდგრადი ესა თუ ის მოწყობილობა. გამოვიყვლიეთ 2 შემთხვევა: ფაზირებული ანტენისა და ცირკულატორის სხვადასხვა პროცენტული უზუსტობებისთვის. ნახ. 3.34-ზე წარმოდგენილია მაქსიმალური გადასხივებული ენერგიის სისტემული მახასიათებელი დამზადების სხვადასხვა სიზუსტისთვის ფაზირებული ანტენის

დროს; ნახ. 3.35-ზე კი ველის მნიშვნელობების სიხშირული მახასიათებლები ცირკულატორის გადასხივებული არხის 2 სხვადასხვა წერტილში დამზადების სიზუსტის სხვადასხვა შემთხვევებისთვის.



ნახ. 3.34 გადასხივებული ენერგიის ტალღურ რიცხვზე დამოკიდებულება ფაზიორებული ანტენისქარხნული დამზადების სხვადასხვა სიზუსტისთვის.



ნახ.3.35 ცირკულატორის 2 სხვადასხვა წერტილში  $E_z$

ველის მნიშვნელობების სიხშირეზე დამოკიდებულება ქარხნული დამზადების სხვადასხვა სიზუსტისთვის.

როგორც ნახავთ გვიჩვენებს მოცემული მოწყობილობები მდგრადობას ინარჩუნებენ მანამ, სანამ დამზადების უზუსტობა არ გადააჭარბებს 10%-ს.

#### დასკვნა.

— გამოკვლევებმა გვაჩვენეს, რომ ფოტონური კრისტალების ბაზაზე შესაძლებელია შეიქმნას ისეთი მოწყობილობები და ელემენტები, როგორიცაა ცირკულატორი, სიხშირული ფილტრი, ტალღების გამყოფი, შემრევი და ანტენა სტრუქტურები.

— შეიქმნა პროგრამული პაკეტი, რომელიც საშუალებას იძლევა:

ა) გამოკიკლიოთ ნებისმიერი ფორმის, ზომის და სტრუქტურის ფოტონური კრისტალი;

ბ) ვცვალოთ კრისტალის დიელექტრიკული შედრევადობა;

გ) კრისტალში მოთავსებულ პერიოდულ სტრუქტურაში შევიტანოთ ნებისმიერი ფორმის დეფექტი;

დ) კრისტალში განვალაგოთ სასურველი რაოდენობის ელექტრომაგნიტური ველის წყარო;

ე) ვცვალოთ სიხშირე;

ვ) თითოეული შემთხვევისთვის შეიძლება გამოვსახოთ ახლო ველის განაწილება და ავაგოთ შორ ზონაში გადასხივებული ველის დიაგრამა;

ზ) კრისტალის სასურველ წერტილში ველის მნიშვნელობის სიხშირეზე დამოკიდებულების გრაფიკი.

თ) პროგრამული პაკეტის საშუალებით შესაძლებელია მოვახდინოთ ნებისმიერი მესრის საფუძვლიანი შესწავლა რეალურ დროში, რასაც პრაქტიკული განხორციელებისათვის არამარტო დიდი დროითი, არამედ მნიშვნელოვანი მატერიალური ხარჯი დასჭირდებოდა.

— ჩატარდა რეალური ექსპერიმენტი; მოხდა რეალური და რიცხვითი ექსპერიმენტის მონაცემების შედარება; განსხვავება ამ მონაცემებს შორის არ ცილდება ნორმის ფარგლებს.

— გათვალისწინებულია ქარხნული დამზადების სიზუსტის შემოსაზღვრულობა და ნაჩვენებია რომ მოწყობილობები ინარჩუნებენ მდგრადობას ნორმიდან მაქსიმუმ 10% გადახრის შემთხვევაში.

### ლიტერატურა

- [1] Kupradze, V.D. (1967) About approximates mathematical physics problem, Success of Mathematical Sciences, 22, N2, 59-107. (in Russian).
- [2] V.D. Kupradze, M.A. Aleksidze: On one approximate method for solving boundary problems. The BULLETIN of the Georgian Academy of Sciences. 30(1963)5, 529-536 (in Russian).
- [3] Aleksidze, M.A. (1991) Fundamental functions in approximate solutions of the boundary problems, Nauka, Moscow (in Russian).
- [4] M.A. Aleksidze: Fundamental functions in approximate solutions of the boundary problems, Nauka, Moscow 1991, 1-352 (in Russian).
- [5] Z.Domanski, A.Piskorek, Z.Roek: On the application of the Fisher-Riss-Kupradze method for solving the first Fourier problem. Rocz. Pol. Tow. Mat., Ser. 1, Prace Mat. 16 (1972), 137-147 (in Russian).
- [6] N.S. Bakhvalov: On the properties of the optimal methods for solving the problems of mathematical physics. Journal of Appl. Math. and Math. Physics. 10(1970)3, 555-568 (in Russian).
- [7] Yu.A. Eremin, N.V. Orlov: The method of discrete sources in the diffraction problems upon the body of rotation in dissipative half-space. Radiotekhnika i Elektronika. 33(1988)12, 2506 (in Russian).
- [8] R.S. Popovidi-Zaridze, D.D. Karkashadze, G.Z. Akhvlediani, J. h. Khatiashvili: Investigation of the possibilities of the method of auxiliary sources in solution of the two-dimensional electrodynamics problems. Radiotekhnika i Elektronika. 26(1981)2, 254-262 (in Russian).
- [9] R. Popovidi-Zaridze: The method of auxiliary Sources. Institute of Radio-engineering of Academy of Sciences, preprint N 14(386), Moscow 1984, 1-80 (in Russian).
- [10] Zaridze R., Karkashadze D., Tavzarashvili K., Bijamov A., **Tabatadze V.**, Hafner Ch., Erni D., Moreno E.. "PBG Devices Based On Periodic Structures With Defects". 2002 USNC/URSI National Radio Science Meeting & IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium, San Antonio, Texas, June 16-21, 2002, vol. 2, pp. 856-859. <http://www.ieeeaps.org/2002APSURSI>
- [11] R.S. Zaridze, D.D. Karkashadze, F.G. Bogdanov, A.Y. Bijamov. "Scattering and Propagation in Finite Photonic Crystals with Complex Material Filling ". Proceedings of VIth International Seminar/Workshop DIPED-2002, Tbilisi, Georgia, October 10-13, 2002, pp. 87-90. <http://www.ewh.ieee.org/soc/cpmt/ukraine/>
- [12] R. Zaridze, A. Bijamov, K. Tavzarashvili, **V. Tabatadze**. "Finite Photonic Crystals Implementation in Microwave Devices". Proceedings of VIth International Seminar/Workshop DIPED-2002, Tbilisi, Georgia, October 10-13, 2002, pp. 106-109. <http://www.ewh.ieee.org/soc/cpmt/ukraine/>

- [13]A. Bijamov, I. Paroshina, D. Karkashadze. "Simulation of optical control devices based on photonic band structures". Proceedings of VIIIth International Seminar/Workshop DIPED-2003, Lviv, September 23-25, 2003. pp. 59-62 <http://www.ewh.ieee.org/soc/cpmt/ukraine/>
- [14]R. Zaridze, A. Bijamov, K. Tavzarashvili, **V. Tabatadze**. "Simulation of the Finite Photonic Crystal-Based Adaptive Antenna". Proceedings of IX-th International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET2002), Kiev, Ukraine, September 10-13, 2002, vol. 2, pp. 407-409. <http://www.kharkov.ukrtel.net/mmet02>
- [15]R.Zaridze, A.Bijamov, D.Karkashadze, K.Tavzarashvili, **V.Tabatadze**, I.Paroshina, C.Hafner, D.Erni. "SOme antenna DEvices Based onPBG Systems".2003 IEEE International Antennas and Propagation Symposium and USNC/CNC/URSI North American Radio Science Meeting, June 22-27, 2003, Columbos, OH, USA.IEEE Catalog#03Ch37450C <http://aps2003.eng.ohio-state.edu/>
- [16]R.Zaridze, A.Bijamov, D.Karkashadze, K.Tavzarashvili, **V.Tabatadze**, I.Paroshina. "Simulation of the Finite Photonic Crystals and HF Circuits Based on Complex Materials." Proceedings of the 2004 IEEE nternational Antenas and Propagation Symposium and USNC/URSI National Radio Science Meeting, June 20-26,2004, Monterey,California.AP/URSI B Session: 78.p.141
- [17]Kupradze V. About approximates solution of mathematical physics problem. Success of Mathematical Sciences, Moscow. 22. N2 1967, 59-107.
- [18]Kupradze V. Dynamical Problems in Elasticity, Progress in Solid Mechanics 3, Amsterdam, 1963.
- [19]Kupradze V. Method of integral equations in the theory of diffraction. 1935. Moscow-Leningrad.
- [20]Millar R. F. Proc. Cambr, Phil. Soc. 1969, v.65, p.773.
- [21]Millar R. F. Electron. Letters 1969. v.5p.416.
- [22]Millar R. F. Radio Science. 1973 v.8. N8.9 pp.785-796.
- [23]Mittra R, Wilton K. 1969. Proc. IEEE, 57(11), 2064-2065. Eremin Yu. A. Lebedev O.A. Sveshnikov A.G. 1988. Radioeng. and Electr. Acad. of Scie USSR. Nauka, v.33, N10, 2076-2083.
- [24]Okuno Y. (1994) A duality Relationship between Scattering Field and current density calculation in the Yasuura Method. MMET, URSI, Kharkov, Ukraine pp. 278-281.
- [25]**V. Tabatadze**, D. Kakulia, G. Ghvedashvili, G. Saparishvili, R. Zaridze. "Application of Equivalent Currents and Charges Conception for Visualization of the Body's Front-Face Area Based on Total Field's Reconstruction". Proceedings of the 11th International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET-2006). June 26-29, 2006. Kharkiv, Ukraine. pp. 520-522.
- [26]R. Zaridze, D. Kakulia, G. Ghvedashvili, G. Saparishvili, **V. Tabatadze**, A. Bijamov Jr. "Numerical Simulation for Experimental Surface Recognition Based on Reflected Field Reconstruction". Proceedings of MEDITERRANEAN MICROWAVE SYMPOSIUM 2006, September 19-21, 2006, Genova, Italy.

- pp. 204-206.
- [27] **V. Tabatadze**, D. Kakulia, G. Ghvedashvili, G. Saparishvili, R. Zaridze. Visualization of the body's front-face area based on total field's reconstruction. Proceedings of XI-th International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2006), October 11-13, 2006, Tbilisi, Georgia. pp. 185-188.
- [28] R. Zaridze, **V. Tabatadze**, D. Kakulia, G. Ghvedashvili, G. Saparishvili "Acceleration of Total Field's Reconstruction for Visualization of Scatterer Surface". Proceedings of the European Conference on Antennas & Propagation (EuCAP 2006), November 6-10, 2006, Nice, France.
- [29] A. Bijamov, D. Kakulia, G. Saparishvili, **V. Tabatadze**, K. Tavzarashvili, R. Zaridze, Ch. Hafner, D. Erni "Simulation and investigation of 2D and 3D photonic devices" JAE (Journal of Applied Electromagnetism). ISSN 1109-1606, June 2007, Athens, Greece
- [30] M. Prishvin, G. Saparishvili, **V. Tabatadze**, R. Zaridze Reconstruction of underground structure using seismic event data. Proceedings of XII-th International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2007), Lviv, September 17-20, 2007, pp. 130-133.
- [31] **V. Tabatadze**, M. Prishvin, G. Saparishvili, D. Kakulia, R. Zaridze "Soil's characteristics study and buried objects visualization using remote sensing". Proceedings of XII -th International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2007), Lviv, September 17-20, 2007, pp. 134-138.
- [32] R. Zaridze, G. Bit-Babik, K. Tavzarashvili, N. Uzunoglu, D. Economou, "Wave Field Singularity Aspects Large-Size Scatterer and Inverse Problems." IEEE Transactions on AP, vol.50, No. 1, January 2002, p.50-58.
- [33] **V.Tabatadze**, A.Bijamov Jr, D.Kakulia, G.Saparishvili, R.zaridze, CH.Hafner, D.Erni, " Design and Analysis of Planar Photonic Band Gap Devices" Int J Infrared Milli Waves DOI 10.1007/s10762-008-9413-2